# Ein adaptives Impuls-EVG zum Betrieb von dielektrisch behinderten Gasentladungslampen





Hans-Peter Daub

#### Ein adaptives Impuls-EVG zum Betrieb von dielektrisch behinderten Gasentladungslampen

#### Ein adaptives Impuls-EVG zum Betrieb von dielektrisch behinderten Gasentladungslampen

von Hans-Peter Daub



Dissertation, Universität Karlsruhe (TH) Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, 2009

#### Impressum

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) KIT Scientific Publishing Straße am Forum 2 D-76131 Karlsruhe www.uvka.de

KIT – Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft



Diese Veröffentlichung ist im Internet unter folgender Creative Commons-Lizenz publiziert: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/

KIT Scientific Publishing 2010 Print on Demand

ISBN 978-3-86644-484-3

## Ein adaptives Impuls-EVG zum Betrieb von dielektrisch behinderten Gasentladungslampen

Zur Erlangung des akademischen Grades eines DOKTOR-INGENIEURS

von der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der Universität Fridericiana Karlsruhe genehmigte

DISSERTATION

von Dipl.-Ing. Hans-Peter Daub aus Pforzheim

Tag der mündlichen Prüfung: Hauptreferent: Korreferent: 04.05.2009 Prof. Dr.-Ing. W. Heering Prof. Dr.-Ing. T. Leibfried

Karlsruhe 2009

Meinen Eltern, Dominique, Cécile, Déborah

## Danksagung

Die vorliegende Arbeit entstand am Lichttechnischen Institut der Universität Karlsruhe (TH) im Rahmen des BMBF Verbundprojekts *Energieeffiziente quecksilberfreie Niederdrucklampen - FZK 13N8154* und im Rahmen des Industrieforschungsprojekts *Planilum*, das von der Firma Saint-Gobain France gefördert wurde.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr.-Ing. W. Heering, der mir die Zeit am LTI ermöglicht hat und mir auch bei schwierigen Entscheidungen mit seinem Rat zur Seite gestanden ist.

Meinem Korreferent Herrn Prof. Dr.-Ing. T. Leibfried danke ich für die freundliche Übernahme des Korreferats und die sorgfältige Durchsicht des Manuskripts.

Meinen Kollegen, Diplomanden, den wissenschaftlichen Hilfskräften und den guten Geistern des LTI danke ich für die allgegenwärtige Hilfsbereitschaft und die schöne Zeit am Institut:

Sebastian Bartlakowski, Antje Dau, Dominique Daub, Rüdiger Daub, Ingo Gabriel, Felix Geislhöringer, Michael Lambrecht, Patrik Langfeld, Günther Mürmann, Carsten Oppitz, Mark Paravia, Martin Perner, Stefan Pieke, Philipp Rabel, Markus Roth, Andreas Ruiss, Robert Sänger, Jörg Schroeter, Peter Schwarz-Kiene, Klaus Trampert, Richard Winkelmann und all den anderen ...

## Inhaltsverzeichnis

Da	Danksagung				
AI	obildu	ingsvei	rzeichnis	vii	
Tabellenverzeichnis     xii				xiii	
Ve	erwen	dete Z	eichen und Symbole	xv	
1	Einl	eitung		1	
2	<b>Bet</b> 2.1	r <b>iebsar</b> Die he	ten - Stand der Technik ochfrequente Sinusanregung	<b>7</b> 9	
	2.2 2.3 2.4	Der h Der In Vor- 1	ochfrequente Rechteckbetrieb	12 18	
	2.4	scher	Sicht	20	
3	Elek	trische	es Lampenmodell einer DBE	23	
	3.1	Zündı	mechanismen in einer Gasentladung	23	
		3.1.1 3.1.2 3.1.3	Ionisierung durch Elektronen im Gas	23 24	
		3.1.4	rie	27 29	
	3.2	Einflu ladun	ss des Sekundärelektronenkoeffizients $\gamma$ auf das Ent- gsverhalten	33	
	3.3	Elekti	risches Modell einer DBE	35	
		3.3.1	Definition der Größen in einer DBE	35	
		3.3.2	Grundlegendes elektrisches Verhalten einer DBE	37	
		3.3.3	Elektronen- und Ionen-Laufzeiten in einer DBE $$	44	
		3.3.4	Simulationsmodell	46	

4	<b>Ada</b>	ptives Entwi	Betriebsgerät zur Erzeugung unipolarer Pulse	<b>69</b> 70
	4.1	411	Auxiliary Resonant Pole Inverter (ARPI)	70
		4 1 2	Ladevorgang der DBE	71
		4.1.3	Adaptives Betriebsgerät für den Rechteckbetrieb	76
	4.2	Adapt	tives Betriebsgerät zur Erzeugung unipolarer Pulse	82
		4.2.1	Rückzündung	82
		4.2.2	Berechnung der Schaltzustände	87
		4.2.3	Dimensionierung der Bauteile für das adaptive Be-	
			triebsgerät für unipolare Pulse	101
5	Sim	ulation		107
	5.1	Simul	ationssoftware	107
	5.2	Imple	mentierung des Lampenmodells und des Pulsgeräts in	
		Simpl	orer	107
	5.3	Simul	ationsergebnisse	115
		5.3.1	Bestimmung der Betriebsgrößen	115
		5.3.2	Bestimmung der Verluste	121
	5.4	Einfül	hrung einer Lampen-Parallel-Kapazität	122
	5.5	Betrie	ebsweisen einer DBE mit Parallelkapazität $C_{inter}$	124
	5.6	Optin	nierung des Gerätewirkungsgrads	130
		5.6.1	Variation des Ubersetzungsverhältnis des Transfor-	
			mators	130
		5.6.2	Variation der Zwischenkreisspannung	132
		5.6.3	Optimierung des Parametersatzes	135
6	Mes	ssergeb	nisse	137
	6.1	Verwe	endete Laborlampe	137
	6.2	Auswa	ahl und Dimensionierung induktiver Bauelemente für	
		das P	uls-EVG	137
	6.3	Messu	ing und Diskussion der elektrischen Betriebsgrößen ei-	
		nes Pi	uls-EVGs	141
	6.4	Einflu	ss von Speicherdrossel und Ubersetzungsverhältnis .	149
		6.4.1	Variation von Transformator und Drossel bei kon-	
		<b>A 1 -</b>	stantem Spannungsanstieg	149
		6.4.2	Variation von Transformator und Drossel bei kon-	
	<u> </u>		stanter Lampenleistung	152
	6.5	Einflu	ss der Zwischenkreisspannung	153

7	Betr	ieb von Xe-Excimer Lampen am Puls-EVG	159
	7.1	Variation des zeitlichen Spannungsanstiegs	159
	7.2	Variation der Pulsweite	162
	7.3	Variation der Leistungszufuhr nach Zündung der DBE	163
	7.4	Vergleich: Leistungseinkopplung durch Einfachzündung und	
		Doppelzündung	165
	7.5	Vergleich homogene - filamentierte Betriebsart	167
	7.6	Lampenwirkungsgrad	169
	7.7	Vergleich mit einem auf dem Markt erhältlichen System	171
	7.8	Adaptivität des Betriebsgeräts	174
8	Disk	ussion der Ergebnisse	177
	8.1	Geräteeffizienz	177
	8.2	Lampenmodell	180
	8.3	Adaptives Impuls-EVG	181
9	Zusa	mmenfassung und Ausblick	185
Α	Anha	ang	189
	A.1	Herleitung - Spannungsverlauf an S2 beim Ausschalten	189
	A.2	Herleitung - Plasmastrom bei Lampenzündung	191
	A.3	Schaltverhalten von MOSFET bei schnellem Spannungsan-	
		stieg	193
Lit	eratu	irverzeichnis	199

# Abbildungsverzeichnis

1.1	Prinzipieller Aufbau einer DBE	2
1.2	DBEGeometrien	2
1.3	Kaltkathodenröhre	4
1.4	Flachlampe	4
2.1	Schalt-Leistungs-Bereiche von Leistungshalbleitern über der	-
	Arbeitsfrequenz	8
2.2	Betriebsgerät für hochfrequente Sinusanregung	9
2.3	Außere Spannung und äußerer Strom an einer DBE im Si-	
	nusbetrieb	11
2.4	Betriebsgerät für hochfrequente Rechteckanregung	12
2.5	Schaltungstopologie zur Erzeugung bipolarer Pulsspannun-	
	gen mit ZVS-Schaltentlastung	13
2.6	Schaltphasen und Stromflüsse des RPI	14
2.7	Schaltphasen und Stromflüsse des RPI	15
2.8	Ausgangsspannung des RPI bei verschiedenen Schaltphasen	17
2.9	Unipolares Vorschaltgerät der Firma Osram	18
2.10	Lampenstrom und Lampenspannung des Systems Xeradex	
	20 W mit Betriebsgerät	19
2.11	Verlauf von Spannung und Strom eines Betriebsgeräts mit	
	Transformator, der in Sättigung getrieben wird	20
3.1	Elektronen-Ionisierungszahl $\alpha/p$ für verschiedene Edelgase [1]	25
3.2	Strom der Elektronen einer Lawine, die durch ein Startelek-	
	tron ausgelöst ist; Strom der positiven Ionen einer Lawine,	
	die durch ein Startelektron ausgelöst ist	25
3.3	Zündspannung für verschiedene Edelgase zwischen parallelen	
	ebenen Elektroden bei $0^{\circ}C[1]$	28
3.4	Elektronen und Ionenströme von Lawinen, wenn Nachfolge-	
	Lawinen nur durch positive Ionen aus der Kathode heraus-	
	gelöst werden [1]	29

3.5	Elektronenstrom für $\mu = 1$ bei Erzeugung der Nachfolge- Elektronen durch Photonen	30
3.6	Relativer Stromverlauf der Elektronenlawinen für verschie-	
	dene $\mu$ [1]	30
3.7	Feldverzerrung beim Kanalaufbau	31
3.8	Streamermechanismen	32
3.9	Barrierenanordnung von DBE	34
3.10	einseitig behinderte Entladungslampe mit identischer elek-	01
0.120	trischer Anregung	35
3.11	Reale Grössen in einer DBE	36
3.12	Lampenmodell im ungezündeten Zustand	37
3.13	Feldverlauf im Plattenkondensator	38
3.14	Verlauf der Gapspannung bei unterschiedlichen Anregungs-	00
0.111	arten	40
3.15	Ablauf der Entladung	41
3.16	Dynamisches Lampenmodell	46
3.17	Elektrisches Lampenmodell für unipolaren Pulsbetrieb	47
3.18	Elektrisches Lampenmodell unter Berücksichtigung der Elek-	
0.20	tronen- und Ionenströme	50
3.19	Modell für Gap mit Plasmastrom vor Lampenzündung	51
3.20	Schnittdarstellung der Laborlampe, an der die inneren Grö-	-
	ßen gemessen wurden	52
3.21	Verlauf der berechneten Plasmakapazität einer DBE	54
3.22	Plasmakapazität nach der Lampenzündung, in Abhängig-	
	keit von der Anstiegsflanke	57
3.23	Spezifischer Plasmaleitwert, gebildet durch freie Elektronen	
	im Gap, in Abhängigkeit vom Spannungsanstieg der Lam-	
	penspannung	59
3.24	Innere Größen bei der Simulation einer DBE	62
3.25	Lampenmodell zu dem Ablaufdiagramm aus Abbildung 3.26	63
3.26	Ablaufdiagramm für das Lampenmodell aus Abbildung 3.25	64
3.27	Vergleich: Spannungs- und Stromverläufe einer sinusange-	
	regten DBE Entladung	66
3.28	Vergleich: Spannungs- und Stromverläufe einer pulsange-	
	regten DBE Entladung	67
4.1	Schaltplan ARPI Schaltung	70
4.2	Ladevorgang einer Kapazität mit geladener Speicherdrossel	72

4.3	Ladevorgang einer Kapazität mit Transformator bei gela-	
	dener Speicherdrossel	73
4.4	Spannungs- und Stromverlauf an einer ungezündeten DBE	75
4.5	Maximale Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung	77
4.6	Betriebsgerät für bipolaren Rechteckbetrieb	78
4.7	Schaltzeitpunkte des adaptiven Betriebsgeräts für bipolaren	
	Rechteckbetrieb	79
4.8	Schaltphasen des adaptiven Betriebsgeräts für bipolaren Rech	t-
	eckbetrieb	80
4.9	Variation des Duty-Cycles zum Betrieb einer DBE	83
4.10	Leistungseinkopplung in Abhängigkeit von der Pulslänge	84
4.11	Betriebsgerät für unipolare Pulse mit Rückspeisediode	85
4.12	Betriebsgerät für unipolare Pulse mit resonanter Rückspei-	
	sung	86
4.13	Ersatzschaltbild: Ladephase der Drossel	88
4.14	Ladephase der DBE	90
4.15	Ersatzschaltbild für den Ausschaltvorgang des Schalters S <sub>2</sub>	91
4.16	Spannungsverlauf am Schalter $S_2$	92
4.17	Ersatzschaltbild für die Ladephase der DBE	93
4.18	Berechnete Spannungs- und Stromverläufe während der La-	
	dephase der DBE	96
4.19	Ersatzschaltbilder der Zündphase	97
4.20	Ersatzschaltbilder der zweiten Zündphase (Rückzündung).	99
4.21	Anordnung von Primär- und Sekundärwicklung eines Trans-	
	formators, für eine gute Kopplung bzw. für geringe Streuin-	
	duktivitäten	102
۳ 1		100
0.1 E 0	Lampenmodell einer DBE in Simplorer für unipolare Pulse	108
0.Z	Ersatzschaltbild Elektrodenimpedanz	108
5.3 E 4	Verlauf des Leitwerts von G_Elektronen	111
5.4	Plasmastrom und auberer Lampenstrom vor Lampenzun-	110
	$\operatorname{dung}$ - Messung	112
5.5	Simulerte Schaltung	114
5.0 F 7	Verlauf des Drosselstroms	110
5.1 5.0	Verlauf Strom und Spannung von MOS2	118
0.8 E 0	Schaltzenlauf den Schaltzen wit 2 Schaltzen und E-th	125
5.9	Schaltverlauf der Schaltung mit 3 Schaltern und Entlas-	100
	tungskapazitat zum Betrieb einer DBE mit $C_{inter}$	126

5.10	Spannungsverlauf an der DBE mit gleicher Lampenleistung und unterschiedlicher Systemscheinleistung	134
6.1	Planilum - DBE Lampe der Firma Saint-Gobain	138
6.2	Strom- und Spannungsverlauf an einer Planilum	139
6.3	Schaltplan des vermessenen unipolaren Pulsgeräts	141
6.4	Spannungen und Ströme an den einzelnen Bauelementen .	143
6.5	Spannungen und Ströme an den einzelnen Bauelementen .	144
6.6	Hystereseverluste des Kernmaterials N87	148
6.7	Resonanter Spannungspuls an der DBE	150
6.8	Variation von Transformatorverhältnis und Drosselindukti-	
	vität bei angestrebtem konstanten Spannungsanstieg	151
6.9	Variation von Transformator und Drossel bei 60 W Lam-	
	penleistung	154
6.10	Spannungsanstieg über Pulslänge bei 60 W Lampenleistung	155
6.11	Variation der Zwischenkreisspannung bei konstanter Lam-	
	penleistung	156
6.12	Variation der Zwischenkreisspannung bei konstanter Lam-	
	penleistung	157
7.1	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	160
$7.1 \\ 7.2$	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	$\frac{160}{161}$
$7.1 \\ 7.2 \\ 7.3$	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	160 161 162
7.1 7.2 7.3 7.4	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	160 161 162
7.1 7.2 7.3 7.4	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	160 161 162 163
<ul> <li>7.1</li> <li>7.2</li> <li>7.3</li> <li>7.4</li> <li>7.5</li> </ul>	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	160 161 162 163 164
$7.1 \\ 7.2 \\ 7.3 \\ 7.4 \\ 7.5 \\ 7.6$	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	160 161 162 163 164
$7.1 \\ 7.2 \\ 7.3 \\ 7.4 \\ 7.5 \\ 7.6$	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	160 161 162 163 164 166
<ol> <li>7.1</li> <li>7.2</li> <li>7.3</li> <li>7.4</li> <li>7.5</li> <li>7.6</li> <li>7.7</li> </ol>	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	160 161 162 163 164 166 168
$7.1 \\ 7.2 \\ 7.3 \\ 7.4 \\ 7.5 \\ 7.6 \\ 7.7 \\ 7.8 \\$	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	160 161 162 163 164 166 168 170
$7.1 \\ 7.2 \\ 7.3 \\ 7.4 \\ 7.5 \\ 7.6 \\ 7.7 \\ 7.8 \\ 7.9 \\$	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	160 161 162 163 164 166 168 170 170
$7.1 \\ 7.2 \\ 7.3 \\ 7.4 \\ 7.5 \\ 7.6 \\ 7.7 \\ 7.8 \\ 7.9 \\ 7.10 \\$	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	<ul> <li>160</li> <li>161</li> <li>162</li> <li>163</li> <li>164</li> <li>166</li> <li>168</li> <li>170</li> <li>170</li> </ul>
$7.1 \\ 7.2 \\ 7.3 \\ 7.4 \\ 7.5 \\ 7.6 \\ 7.7 \\ 7.8 \\ 7.9 \\ 7.10 \\$	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	160 161 162 163 164 166 168 170 170
7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.11	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	<ul> <li>160</li> <li>161</li> <li>162</li> <li>163</li> <li>164</li> <li>166</li> <li>168</li> <li>170</li> <li>170</li> <li>172</li> </ul>
$7.1 \\ 7.2 \\ 7.3 \\ 7.4 \\ 7.5 \\ 7.6 \\ 7.7 \\ 7.8 \\ 7.9 \\ 7.10 \\ 7.11$	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	<ul> <li>160</li> <li>161</li> <li>162</li> <li>163</li> <li>164</li> <li>166</li> <li>168</li> <li>170</li> <li>170</li> <li>172</li> <li>173</li> </ul>
7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.117.12	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	<ul> <li>160</li> <li>161</li> <li>162</li> <li>163</li> <li>164</li> <li>166</li> <li>168</li> <li>170</li> <li>170</li> <li>172</li> <li>173</li> <li>174</li> </ul>
7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.117.127.13	Variation der Lampenleistung ohne $C_{inter}$	<ul> <li>160</li> <li>161</li> <li>162</li> <li>163</li> <li>164</li> <li>166</li> <li>168</li> <li>170</li> <li>170</li> <li>172</li> <li>173</li> <li>174</li> <li>176</li> </ul>

A.2	Ersatzschaltbild der Zündphase	192
A.3	Unterschiedliche MOSFET-Strukturen	194
A.4	MOSFET-Modelle	195
A.5	Schaltverläufe eines MOSFETs	197

## Tabellenverzeichnis

0.1	Verwendete Formelzeichen und physikalische Größen Teil 1	XV
0.2	Verwendete Formelzeichen und physikalische Größen Teil 2	xvi
0.3	Verwendete Konstanten	xvi
0.4	Verwendete Abkürzungen	xvii
3.1	Ausbreitungs- und Driftgeschwindigkeiten von Elektronen, Ionen und Streamern [1]	33
3.2	Parameter für die Ionendriftgeschwindigkeit von einfach io- nisierten Xenonatome bzw. Xenonexcimeren und die zuge-	
	hörige Driftgeschwindigkeit für $E/N = 70$ Td $\ldots$	45
3.3	Laufzeiten und Driftgeschwindigkeiten in einem Gap	46
3.4	Kapazitäten der Laborlampe im nicht gezündeten Zustand	53
3.5	Kapazitäten der Laborlampe im gezündeten Zustand bei	
0.0	Sinusanregung	55
3.6	Kapazitäten der Laborlampe bei Pulsanregung; Spannungs- anstieg konstant	56
3.7	Gesamtkapazität und Plasmakapazität der Laborlampe bei	
3.8	Spezifische Plasmaleitwerte für das Lampenmodell in Ab-	57
	hängigkeit von der Anregung	60
4.1	Werte für die Berechnung des Spannungsverlaufs	75
5.1	Elektrische Parameter der Planilum für das Lampenmodell	110
5.2	Bauteilgrößen für die Simulation	115
5.3	Kapazität C4 zum Beschränken der maximalen Spannung	
	auf 600 V an MOS2 in Abhängigkeit des Drosselstroms $I_L$ .	120
5.4	Effektiv- und Maximalströme der einzelnen Bauteile	120
5.5	Leistungsumsatz in den einzelnen Bauteilen	122
5.6	Elektrische Grössen der einzelnen Bauteilen im Betrieb mit	
	$C_{inter} = 1000 \mathrm{nF} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$	123

5.7	Elektrische Größen im resonanten Betrieb für die Topologien aus Abbildung 5.8; $C_{inter} = 0 \text{ pF}$ ; 1000 pF; 2000 pF	128
5.8	Elektrische Grössen im resonanten Betrieb für $u_{Trafo} = 4:1;$ 3:1: 2:1	131
5.9	Elektrische Größen im resonanten Betrieb für verschiedene	101
5 10	$U_{DC}$	133
0.10	Gerätewirkungsgrad	136
6.1	Technische Größen der Planilum Laborlampe	138
6.2	Technische Angaben der benutzten Transformatoren	140
6.3	Technische Angaben benutzter Speicherdrosseln	141
6.4	Elektrische Bauteile der Schaltung	142
6.5	Verteilung der gemessenen Verluste im Betriebsgerät	145
6.6	Kernverluste der Speicherdrossel bei verschiedenen Maxi-	
	malströmen und einer Betriebsfrequenz von 30 kHz und ei-	
	ner Kerntemperatur von $60^{\circ}$ C	148
6.7	Einstellungen für die Messung: Parametervariation von Über-	
	setzungsverhältnis und Speicherdrossel	150

## Verwendete Zeichen und Symbole

Symbol	Einheit	Beschreibung
Е	V/m	Elekrisches Feld
N	$1/\mathrm{m}^3$	Gesamtteilchendichte
0	1/m	Erster Townsendscher Ionisationsko-
α		effizient
d	m	Abstand
р	Pa bzw. Torr	Druck $(1 \text{ Pa} = 7,5006 \cdot 10^{-3} \text{ Torr})$
I	Λ	Strom der durch Elektronen gebildet
10	Α	wird
$ au_e$	S	Laufzeit einer Elektronenlawine
$ au_+$	S	Laufzeit einer Ionenwolke
t	S	Zeit
$u_e$	m/s	Driftgeschwindigkeit eines Elektrons
$u_+$	m/s	Driftgeschwindigkeit eines Ions
$\gamma_0$	1	Oberflächenionisierungszahl
	1	Volumenionisierungszahl durch posi-
//1		tive Ionen
	1	Ionisierungszahl durch Photonen an
γ2		der Kathode
		Anzahl der Elektronen, die an der
$\zeta$	1	Kathode durch ein Photon ausgelöst
		werden
$U_Z$	V	Zündspannung eines Gases
$d_Z$	m	Elektrodenabstand

Tabelle 0.1: Verwendete Formelzeichen und physikalische Größen Teil 1

Symbol	Einheit	Beschreibung
UDDD	V	Äußere Spannung, die an einer DBE
O DBE	v	anliegt
II,	V	Spannung die an der Wand bzw. an
UWand	v	der Barriere einer DBE anliegt
IT	V	Spannung die über dem Gasraum
$U_{gap}$	v	(gap) einer DBE anliegt
I <sub>Plas</sub>	А	Plasmastrom
I	Λ	Verschiebungsstrom im Gasraum ei-
Igap	Л	ner DBE
		Elektrisches Feld im Gasraum, das
$E_P$	V/m	durch Trennung von Ladungsträgern
		entsteht
Г	V/m	Von aussen eingekoppeltes elektri-
$L_0$	$v_0 = V/m$	sches Feld im Gasraum
$E_m$	V/m	resultierendes elektrisches Feld
А	$m^2$	Fläche
С	F	Kapazität
$C_{plas}$	F	Plasmakapazität
$C_{gap}$	F	Gapkapazität
Z <sub>Ion</sub>	Ω	Plasmaimpedanz

Tabelle 0.2: Verwendete Formelzeichen und physikalische Größen Teil 2

Konstante	Wert	Beschreibung
e	$1,602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}$	Elementarladung
А	26	empirische Konstante für
		das Paschengesetz
В	350	empirische Konstante für
		das Paschengesetz
$\epsilon_0$	$8,8542 \cdot 10^{-12}  \mathrm{As/Vm}$	Dielektrizitätskonstante des
		Vakuums
$\epsilon_r$	1	Permittivitätszahl des Va-
		kuums
k	$1,38\cdot 10^{-23}{ m J/K}$	Boltzmann-Konstante

 Tabelle 0.3:
 Verwendete Konstanten

Abkürzung	Beschreibung	
EVG	Elektrisches Vorschaltgerät	
DBE	Dielektrisch behinderte Entladung	
gap	Lücke; hier: Entladungsraum zwischen den Dielektrika	
Excimer	Excited Dimer	
LED	Light Emitting Diode	
MOSFET	Metal Oxid Semiconductor Field Effect Transistor	
IGBT	Insulated Gated Bipolar Transistor	
ZCS	Zero Current Switching	
ZVS	Zero Voltage Switching	
RPI	Resonant Pole Inverter	
ARPI	Auxiliary Resonant Pole Inverter	
ARCPI	Auxiliary Resonant Commutated Pole Inverter	

 Tabelle 0.4:
 Verwendete
 Abkürzungen

## 1 Einleitung

Bei der "Dielektrisch Behinderten Entladungslampe", kurz DBE, handelt es sich um eine Strahlerart aus der Gruppe der Plasmastrahlungsquellen. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der beiden Elektroden durch eine dielektrische Barriere vom Gasraum getrennt ist. Im nicht gezündeten Zustand kann solch eine Lampe mit einem Plattenkondensator verglichen werden. Im Gasraum (Gap) befindet sich ein Gasgemisch, bei dem in der Regel eine Komponente ein Edelgas ist. Wird an die Elektroden eine alternierende Spannung mit einem Spannungshub im kV-Bereich angelegt, so kann durch das im Gasraum erzeugte elektrische Feld eine Plasmaentladung entstehen. Die Entladung kann von 50 ns bis mehrere 100 ns andauern. Dies hängt vor allem von der Gasart, dem Gasdruck, der Lampengeometrie und der Barrierenkapazität ab. Durch den Ladungstransport im Gasraum baut sich während der Entladung ein inneres elektrisches Feld auf, das dem von außen eingekoppelten elektrischen Feld entgegenwirkt. Die Felder heben sich auf und die Entladung kommt zum Erliegen. In Kapitel 3 wird eingehend das Verhalten von Elektronen und Ionen während des Vorgangs der Entladung diskutiert. Mit den gewonnenen Erkenntnissen wird ein neuartiges Simulationsmodell vorgestellt.

Die möglichen Anordnungen von Elektroden und Dielektrika sind in Abbildung 1.1 zu sehen. Grundsätzlich wird zwischen einer einseitig- und einer beidseitig behinderten Barrierenentladung unterschieden. Bei der beidseitig behinderten Entladungslampe besteht der Vorteil darin, dass die Elektroden keinen direkten Kontakt zum Gasgemisch haben. Dadurch ist der Verschleiß der Elektroden praktisch ausgeschlossen. Außerdem können die Elektroden den Gasraum nicht verunreinigen. Bei der einseitig behinderten Entladung wird dieser Vorteil bewusst nicht genutzt. Dafür kann eine geringere Zündspannung und eine höhere Barrierenkapazität erreicht werden, die eine größere Leistungseinkopplung in das Plasma ermöglicht. Zudem ist die Elektrode verschieden. Mögliche geometrische Ausführungen von Barrieren-Entladungslampen sind in Abbildung 1.2 zu sehen.



Abbildung 1.1: Prinzipieller Aufbau einer DBE; schwarz: Elektrode und Kontaktierung; grau: Dielektrikum



Abbildung 1.2: DBE-Geometrien; schwarz: Elektrode; grau: Dielektrikum

Anwendung finden die DBEs in der Oberflächenbehandlung von Materialien [2] und zur Ozonerzeugung, da mit ihnen hoch energetische ultraviolette Strahlung erzeugt werden kann. Mit den Plasmabildschirmen hat sich die Excimerentladung (Excimer = excited dimer [3]) auch im Bereich der sichtbaren Strahlungserzeugung etabliert. Hier wird die ultraviolette Strahlung mit Hilfe von Luminophoren in sichtbare Strahlung umgewandelt [4]. Mit der "Planon" der Firma Osram und der "Planilum" der Firma Saint-Gobain sind bereits Lichtquellen auf Basis der Excimerentladung in Flachbauweise auf dem Markt eingeführt worden. Sie sollen in der Allgemeinbeleuchtung und in der Hinterleuchtungstechnik eingesetzt werden. Speziell bei der dielektrisch behinderten Entladung auf der Basis von Xenon-Excimeren besteht der Vorteil in der sofortigen Einsatzbereitschaft gegenüber Entladungslampen, deren Leuchtgas nach der Lampenzündung erst seinen Betriebsdruck erreichen muss. Es muss keine Einbrenndauer der Xenon-Excimer-Lampe berücksichtigt werden. Ein weiterer Vorteil gegenüber Quecksilber(Hg)-Niederdruckentladungen, deren System-Wirkungsgrad bei der Erzeugung weißen Lichts zum heutigen Stand der Technik unübertroffen ist, liegt in der Temperaturunabhängigkeit. Während der optimale Lampenwirkungsgrad einer Hg-Niederdruckentladung, abhängig von der Füllung, nur bei einer Temperatur zu erreichen ist, bleibt der Wirkungsgrad einer Xenon-Excimer-Lampe in einem Bereich von -30 °C bis +85 °C [5] konstant. Die freie Formgebung der Flachlampe in bis zu drei Dimensionen und das flächenhafte, lambertförmige Strahlungsverhalten machen dieses Lampenprinzip auch für gestalterische Anwendungen interessant. Unter umweltpolitischen Gesichtspunkten besteht der Vorteil in der unbedenklichen Entsorgung von Xenon-Excimer-Lampen im Hausmüll.

Bei jeder Art von Barrierenentladung spielt das Betriebsgerät eine zentrale Rolle. Neben den Konstruktionsparametern der Lampe wie z.B. Lampengas, Fülldruck, Gapabstand und Dicke des Dielektrikums entscheidet die an die Lampe angelegte Spannungs-Zeit-Form und damit das Betriebsgerät darüber, ob eine effiziente oder ineffiziente Entladung in der Lampe stattfindet [6].

Parallel zu dieser Arbeit wurden DBE-Flachlampen entwickelt [7], [8], die in der Lichtwerbung und in der Architektur eingesetzt werden sollen. Stand der Technik ist hier immer noch die von Georges Claude 1910 erfundene Neonröhre und die mit Quecksilber gefüllte Kaltkathodenröhre (Abbildung 1.3), deren Technologie seit ca. 50 Jahren kaum weiterentwickelt wurde. Als flächenhafte Strahler gibt es in der Lichtwerbung die sehr kostenaufwendigen, in Form gebogenen Kaltkathodenstrahler oder die sich schnell verbreitende LED-Technik. Für beide Techniken gilt, dass sie von einer Plexiglasform überdeckt werden müssen, damit der flächenhafte Eindruck gewährleistet ist. Diese Abdeckung, die als Diffusor eingesetzt wird, wird von den Lichtquellen durchleuchtet, so dass ein flächenhafter Eindruck entsteht. Die Xenon-Excimer-Flachlampe (Abbildung 1.4) ermöglicht hier eine kostengünstigere Herstellung von flachen, großen Leuchtschriften und -formen. Zusätzlich stellt diese Art der Lampe eine Innovation auf dem Markt der Lichtwerbung dar. Da hier individuelle Lampen mit unterschiedlichen Größen und Formen in Frage kommen, ist eine Vor-





Abbildung 1.3: Kaltkathodenröhre Abbildung 1.4: Flachlampe

aussetzung für den Erfolg dieser Flachlampen ein Betriebsgerät, das auf unterschiedlich große Lampen mit unterschiedlich großen Kapazitäten und unterschiedlichen Leistungsaufnahmen eigenständig adaptiert. Betriebsgeräte, die nicht die Fähigkeit der Adaptation besitzen, sind für jeweils nur eine spezielle Lampe geeignet.

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Betriebsgerät zu entwickeln, das unterschiedlich große Xenon-Excimer Strahler effizient betreibt und zusätzlich auf unterschiedlichen Lampenflächen mit gleicher Zündspannung eigenständig adaptiert. Dabei wird die Adaptation ausschließlich durch zeitliche Änderung der Schaltsignale für die Leistungshalbleiter angestrebt. Um diese Arbeit auch mit Simulationswerkzeugen zu unterstützen, ist ein weiterer Punkt die Entwicklung eines neuartigen elektrischen Simulationsmodells, das nicht nur für Sinusanregung sondern auch für Pulsanregung geeignet ist. Mit diesem Modell kann das Verhalten der Leistungsaufnahme bereits im Planungsstadium simuliert werden, so dass auch Konsequenzen durch Größenänderung der Entladungsfläche berücksichtigt werden können. Das konzipierte und aufgebaute adaptive Puls-Betriebsgerät für DBE-Lampen wurde im Laufe dieser Arbeit patentiert [9].

Diese Arbeit ist ein Teil eines Teamprojektes am Lichttechnischen Institut der Universität Karlsruhe, bei dem das System DBE-Lampe und Betriebsgerät erforscht wurde. Dabei wurde das Verhalten der Lampe in Abhängigkeit von der Anregungsart von K.E. Trampert untersucht [10]. Das in dieser Arbeit entwickelte Impuls-EVG wurde für die erwähnte Arbeit [10] herangezogen. Ein Teil der DBE-Lampen, die zur Entwicklung des Impuls-EVG benötigt wurden, wurden von dem Projektpartner gebaut und zur Verfügung gestellt.

#### 1 Einleitung
# 2 Betriebsarten - Stand der Technik

Seit der Beobachtung der Barrierenentladung durch Werner von Siemens wurden viele Betriebsgeräte für DBEs entwickelt. Anfänglich erzeugten diese niederfrequente alternierende Spannungsformen mit ausreichenden Amplituden, um einen elektrischen Durchbruch im Gasraum zu erzeugen [11]. Erst mit dem Siegeszug der Halbleitertechnologie konnten mit Hilfe von MOSFET- und IGBT-Schaltern hochfrequente Betriebsgeräte gebaut werden. Dabei haben die unterschiedlichen Halbleiterschalter verschiedene Einsatzbereiche. Die MOSFET-Technologie ist für hohe Betriebsfrequenzen am meisten geeignet, aufgrund der geringsten Schaltzeiten und folglich auch der geringsten Schaltverluste. Für jede Bauteiltechnologie konkurrieren die Größen Schaltfrequenz, Maximalspannung und Maximalstrom miteinander. In Abbildung 2.1 sieht man, dass mit zunehmender Leistung, die geschaltet werden muss, die erreichbare Schaltfrequenz abnimmt. Zu Beginn der Entwicklung von Betriebsgeräten für DBE, basierend auf der Halbleitertechnologie, begnügte man sich damit, die Barrierenentladungen mit einer Betriebsfrequenz von 50 Hz bis 300 kHz und einer sinusförmigen Lampenspannung zu betreiben. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass unter anderem die Anstiegsflanke der Lampenspannung maßgebend für den Lampenwirkungsgrad ist, wurden Betriebsgeräte gebaut, die rechteckähnliche Spannungsformen erzeugen, so dass in der Anstiegsflanke der Lampenspannung ein großes  $\frac{dU}{dt}$  erzeugt wird. Dabei variiert die Betriebs-frequenz im Bereich von 1 kHz bis 300 kHz und das Tastverhältnis im Bereich von 1% bis 50%. Trotz des Vorhandenseins der unterschiedlichsten Betriebsgeräte ist die optimale Betriebsart einer Barrierenentladung bis

heute noch nicht vollständig bekannt.



Abbildung 2.1: Schaltleistungsbereiche von Leistungshalbleitern über der Arbeitsfrequenz [12]



Abbildung 2.2: Betriebsgerät für hochfrequente Sinusanregung [13]

Um eine Barrierenentladung im hochfrequenten Bereich betreiben zu können, stehen grundsätzlich drei Anregungsarten zur Verfügung:

- die Sinusanregung
- die Rechteckanregung
- die Pulsanregung

Jedes dieser Prinzipien hat seine Vor- und Nachteile, die im Folgenden diskutiert werden.

## 2.1 Die hochfrequente Sinusanregung

Die Anregung einer Barrierenentladung durch eine hochfrequente sinusförmige Wechselspannung ist bis heute die verbreitetste Art, eine DBE zu betreiben. Vor allem im Leistungsbereich oberhalb 500 Watt wird diese Anregung genutzt, da der Wirkungsgrad (90 %) dieses Schaltprinzips noch nicht übertroffen werden konnte. Kunze et al. [13] veröffentlichten 1992 die Untersuchung einer Schaltungstopologie zum resonanten Betrieb von Barrierenentladungen mit einer Ausgangsleistung von bis zu 2,2 kW. Bei der Schaltungstopologie handelt es sich, wie in Abbildung 2.2 dargestellt, um eine Voll- oder H-brücke, in deren Mitte sich eine Drossel L und ein Transformator T in Reihe geschaltet befinden. Die Gesamtkapazität der Barrierenentladung (DBE), die auf der Sekundärseite des Transformators T angeschlossen ist, bildet mit der primärseitigen Drossel L einen Resonanzkreis, dessen Resonanzfrequenz sich zu

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{L \cdot u^2 \cdot C}} \tag{2.1}$$

ergibt, wenn von einem idealen Transformator ohne Streuinduktivität ausgegangen wird. Dabei ist u das Wicklungsverhältnis des Tranformators von Sekundärseite zu Primärseite:

$$u = \frac{w_{sek}}{w_{prim}} \tag{2.2}$$

Abhängig von der Zeitdauer  $t_1$ , in der die Schalter S1 und S4 geschlossen (leitend) sind, steigt der durch die Drossel L begrenzte Strom an. Dadurch steigt auch die Spannung am Transformator und an der Barrierenentladung an.

Bei Erreichen der Zündspannung wird das Lampengas kurzzeitig leitend und es fließt ein Plasmastrom im Zeitbereich von 50 ns bis 300 ns. Bei dieser Betriebsart ist es jedoch nicht möglich, den gesamten Entladungsraum synchron zu einem Zeitpunkt zu zünden. Es werden immer nur zeitlich und räumlich versetzte Einzelfilamente gezündet, so dass bei Erreichen der Zündspannung stochastisch verteilte Entladungsströme (Plasmaströme) auftreten [14]. Dieses stochastische Zündverhalten ist im äußeren Stromverlauf der DBE in Abbildung 2.3 zu sehen. Dem Ladestrom der Lampenkapazität sind hochfrequente Stromspitzen überlagert, die durch das stochastisch verteilte Zünden einzelner Filamente erzeugt werden. Im Gegensatz zu anderen Schaltprinzipien bricht die Lampenspannung bei dieser Betriebsart nur unwesentlich ein.

Sobald die Schalter S1 und S4 geöffnet werden (nicht leitender Zustand), fallen sowohl der Drosselstrom als auch der Ladestrom der Lampe sinusförmig ab. Dieser Schaltvorgang ist verlustbehaftet, da er während des maximalen Drosselstroms erfolgt (ZCS wird nicht eingehalten). Die Schaltverluste können aber durch Snubber-Kapazitäten parallel zu den Schaltern reduziert werden. Zusätzlich wird damit gewährleistet, dass der Spannungsanstieg an den Schaltern nicht die vorgegebenen Grenzwerte überschreitet. Durch die Energie, die in der Drossel L noch gespeichert ist, wird ein Strom über die Inversdioden der Schalter S2 und S3 getrieben. Die Versorgungsspannung wirkt dem Stromfluss der Drossel entgegen und der



Abbildung 2.3: Äußere Spannung und äußerer Strom an einer DBE im Sinusbetrieb,  $f = 20 \text{ kHz}, 1 \text{ kV/div}, 20 \text{ mA/div}, 10 \,\mu\text{s/div} [15]$ 

Drosselstrom geht auf null zurück. Wegen des kapazitiven Verhaltens der Barrierenentladung eilt die Phase des Stroms der Lampenspannung um ca. 90° voraus, so dass erst beim Nulldurchgang des Lampenstroms bzw. des Drosselstroms das Maximum der Lampenspannung erreicht wird. Um weitere Zündvorgänge in der Lampe zu erhalten, muss nun die Lampenspannung umgepolt werden. Dazu werden die Leistungshalbleiter S2 und S3 geschlossen (leitender Zustand). Damit nur geringe Einschaltverluste entstehen, müssen S2 und S3 spannungsfrei eingeschaltet werden (ZVS Bedingung). Dies geschieht, solange der Strom über die Inversdioden der zu schaltenden MOSFETs fließt. Idealerweise werden die MOSFETs zum Zeitpunkt des Stromnulldurchgangs des Drosselstroms eingeschaltet. Durch die Versorgungsspannung U, die dem kommutierten Drosselstrom entgegenwirkt, dreht sich der Drosselstrom um und fließt in die entgegengesetzte Richtung. Der Drosselstrom steigt an. Die Lampenspannung sinkt, wird umgepolt und steigt mit entgegengesetztem Vorzeichen wieder an. Von nun an wiederholt sich der Schaltzyklus.



Abbildung 2.4: Betriebsgerät für hochfrequente Rechteckanregung

## 2.2 Der hochfrequente Rechteckbetrieb

Nachdem sich herausgestellt hatte, dass die Flankensteilheit der anliegenden Lampenspannung einen wesentlichen Einfluss auf den Lampenwirkungsgrad hat [6], wurden vermehrt Untersuchungen an DBEs gemacht, die mit rechteckigen Spannungsformen und einem Dutycycle von 50 % betrieben werden. Als das naheliegendste Schaltungskonzept erscheint das Schaltungskonzept aus Kapitel 2.1 ohne die Induktivität L (Abbildung 2.4). Aufgrund des nicht idealen Transformators bestimmen dessen Streuinduktivitäten über die eigentliche Spannungsform an der DBE. Abhängig von der gewünschten Betriebsfrequenz, die im Bereich zwischen 20 kHz und 100 kHz liegt, der Zündspannung, die im Bereich von 2 kV bis 15 kV liegen kann, und einer Versorgungsspannung der Schaltung, im Bereich von ca. 300 V bis 800 V, muss die primäre Windungszahl des Transformators für kleine Betriebsfrequenzen so ausgelegt sein, dass der Kern nicht in Sättigung gerät [16]. Die sich daraus ergebende hohe Windungszahl führt zum einen zu großen ohmschen Verlusten und zum andern zu einer großen Streuinduktivität des Transformators. Die Streuinduktivität wiederum begrenzt die Anstiegszeit der Lampenspannung. Zusätzlich bildet die Streuinduktivität mit der Kapazität der DBE einen Resonanzkreis in dem hochfrequente Störanteile erzeugt werden. Sollen mit dem Betriebsgerät steile Spannungsflanken erzeugt werden, so ist es notwendig die Streuinduktivität des Transformators so klein wie möglich zu halten. Die Geschwindigkeiten der Anstiegs- und Abfallflanke werden durch die Kombination Transformator, Schaltereigenschaft und Last (DBE) festge-



Abbildung 2.5: Schaltungstopologie zur Erzeugung bipolarer Pulsspannungen mit ZVS-Schaltentlastung [15]

legt. Die Verluste in diesem Betriebsgerät sind hier erheblich größer als im Sinusbetrieb. Bedingt durch die Form der Lampenspannung, die keine große Induktivität in Reihe zum Transformator zulässt, ist keinerlei resonantes Schalten möglich.

Um die Anstiegs- und Abfallzeit aktiv zu beeinflussen, wurde am Lichttechnischen Institut der Universität Karlsruhe ein Betriebsgerät auf der Basis eines Resonant Pole Inverters (RPI) entwickelt [15], bei dem sowohl die steigende als auch die fallende Flanke unabhängig voneinander eingestellt werden können. In Abbildung 2.5 ist der Schaltplan für dieses Prinzip zu sehen. Während der Umladezeiten der DBE hat das Betriebsgerät den Charakter einer Stromquelle. Für dieses Verhalten ist primär die Induktivität  $L_{AB}$  verantwortlich, die parallel zum Transformator liegt. Solange Spannung am Transformator anliegt, wird die Drossel geladen. Sobald einer der Schalter geöffnet wird, wird ein Umladevorgang eingeleitet. Die Drossel treibt den Strom konstant in dieselbe Richtung weiter und lädt oder entlädt aktiv die Kapazität der DBE. Unterstützt wird die Induktivität  $L_{AB}$  durch die Induktivitäten  $L_A$  und  $L_B$ . Dabei beeinflusst die Induktivität  $L_A$  die Anstiegszeit und die Induktivität  $L_B$  die Abfallzeit des Spannungspulses. Verständlicher wird das Schaltprinzip durch Erläuterung der einzelnen Schaltzustände und Stromverläufe anhand der Abbildung 2.6.

1. Schalter  $A_{high}$  und  $B_{low}$  sind leitend. An dem Transformator liegt



Abbildung 2.6: Schaltphasen und Stromflüsse des RPI



Abbildung 2.7: Schaltphasen und Stromflüsse des RPI

eine positive Spannung an. Gleichzeitig fließen über die Induktivitäten  $L_{AB}$  und  $L_B$  Ladeströme wie im Bild eingezeichnet. In diesen Induktivitäten wird Energie gespeichert.

- 2. Sobald der Schalter  $B_{low}$  ausgeschaltet wird, wird das Potential an dem Anschlusspunkt B auf Versorgungsspannung gehoben. Dies geschieht durch die Ströme, die von den Induktivitäten  $L_{AB}$  und  $L_{B}$  in Richtung des Anschlusspunkts B getrieben werden. Dadurch liegen beide Anschlussklemmen des Transformators auf dem selben Potential. Die Inversdiode des Schalters  $B_{high}$  wird leitend und es kann spannungslos (ZVS-Bedingung) der Schalter  $B_{high}$  eingeschaltet werden. Es liegt keine Spannung am Transformator an, d. h. die Ausgangsspannung ist null. Mit den Drosselströmen, die während der Ausschaltzeit des Schalters  $B_{low}$  fließen, kann die abfallende Flankensteilheit der Lampenspannung zusätzlich eingestellt werden. Es bildet sich ein Kreisstrom über der oberen Masche aus, der so lange fließt bis die Drossel  $L_{AB}$  aufgrund von ohmschen Verlusten ihre gesamte Energie verloren hat oder bis der Schalter  $A_{high}$  nicht leitend gemacht wird. Gleichzeitig wird die Induktivität  $L_A$  geladen, die zwi-schen den Potentialen Versorgungsspannung und  $\frac{Versorgungsspannung}{2}$ liegt.
- 3. Der Schalter  $A_{high}$  wird ausgeschaltet. Das Potential des Anschlusspunkts A wird auf null Volt gezogen, so dass an der Lampe eine negative Anstiegsflanke erzeugt wird. Beschleunigt wird das Absinken der Spannung durch die Ströme, die von den Induktivitäten  $L_{AB}$ und  $L_A$  getrieben werden. Während dieses Vorgangs wird die Inversdiode des Schalters  $A_{low}$  leitend, der Schalter  $A_{low}$  kann spannungslos eingeschaltet werden.
- 4. Nachdem die Induktivität  $L_{AB}$  ihre gesamte Energie in die Versorgungsspannung zurückgespeist hat, dreht sich die Stromrichtung in der Drossel um. Die Drossel wird wieder geladen, wobei der Ladestrom in die entgegengesetzte Richtung fließt. Zusätzlich wird die Induktivität  $L_B$  geladen. Die angelegte Spannung am Transformator aus Schaltzyklus 3 bleibt bestehen.
- 5. Um die Lampenspannung auf null zu reduzieren, wird nun der Schalter  $B_{high}$  geöffnet. Der Punkt B der Vollbrücke sinkt auf null Volt,



Abbildung 2.8: Ausgangsspannung des RPI bei verschiedenen Schaltphasen

unterstützt durch die Ströme, der Induktivität  $L_{AB}$  und der Induktivität  $L_B$ . Es bildet sich ein Kreisstrom in der unteren Masche, der von der Induktivität  $L_{AB}$  getrieben wird. Dieser Kreisstrom fließt über die Inversdiode des Schalters  $B_{low}$ . Der Schalter  $B_{low}$  wird unter ZVS-Bedingung geschlossen. Gleichzeitig wird die Induktivität  $L_A$ über den Schalter  $A_{low}$  geladen.

6. Für den nächsten Umladevorgang, d. h. für die Einleitung der nächsten positiven Spannungsflanke, wird der Schalter  $A_{low}$  geschlossen, während ein Strom über ihn fließt. Die Spannung am Punkt A steigt an, unterstützt durch die Drosselströme  $L_{AB}$  und  $L_A$ . Die Drosselströme fließen über die Inversdiode des Schalters  $A_{high}$ . Dies ermöglicht das spannungsfreie Einschalten des Schalters  $A_{high}$ .

In Abbildung 2.8 ist die Ausgangsspannung mit den zugehörigen Zeitpunkten aufgetragen. In diesem Schaltprinzip dominieren die ohmschen Verluste, die dadurch entstehen, dass kontinuierlich Drosselströme über zwei jeweils wechselnde MosFets bzw. deren Inversdioden fließen. In [15] wird angegeben, dass der Gerätewirkungsgrad bei einer Betriebsfrequenz von 20 kHz 20 % und bei einer Betriebsfrequenz von 200 kHz 70 % beträgt. Da lampenbedingt nur bei einer Änderung der Lampenspannung elektrische Leistung in die DBEeingekoppelt werden kann, ist dieses Schaltprinzip für geringe Betriebsfrequenzen aufgrund der ständig fließenden Drosselströme nicht geeignet.



Abbildung 2.9: Unipolares Vorschaltgerät der Firma Osram [19]

# 2.3 Der Impulsbetrieb

1998 berichteteten Vollkommer und Hitschke [17] über eine Betriebsweise von Excimer Strahlern, die den Lampenwirkungsgrad im Gegensatz zum Sinusbetrieb bis zu einem Faktor drei verbesserten. Im Jahr 2000 wurde diese Aussage von Carman und Mildren [18] bestätigt. Diese Betriebsweise beinhaltet einen Spannungspuls, mit einer Anstiegszeit der Lampenspannung von ca. 90 V/ns, einer Pulsweite von etwa 1  $\mu$ s und einer Pulspause im Bereich von ca.  $10 \,\mu s$  bis  $310 \,\mu s$ . Um diese Betriebsart in einer Massenproduktion einzusetzen, wurde bei der Firma Osram ein Betriebsgerät entwickelt [19], das in Abbildung 2.9 zu sehen ist. Es hat einen elektrischen Gerätewirkungsgrad von bis zu  $\eta_{el} = 88\%$  [20]. Das Prinzip der Pulserzeugung besteht in einem Kondensator  $C_2$ , der sich beim Schließen des Schalters S1 über der Primärseite des Transformators bzw. des Impulsübertragers entlädt. Wegen des entgegengesetzten Wicklungssinns von Primär- und Sekundärseite des Transformators wird an der Lampe ein negativer Spannungsanstieg in Bezug auf Masse erzeugt. Während des negativen Spannungsanstiegs zündet die DBE. Die erzeugte negative Lampenspannung schwingt nach Erreichen der Maximalspannung zurück. Dabei bilden die Lampenkapazität und die Induktivität des Impulswandlers (Transformator) einen Schwingkreis. Die in den positiven Bereich umschwingende Lampenspannung ist über die Rückspeisediode D3 mit der Zwischenkreisspannung verbunden, so dass die Restenergie des Lampenkreises in den Kondensator C1 zurückgespeist wird. Während der



Abbildung 2.10: Lampenstrom und Lampenspannung des Systems Xeradex 20 W mit Betriebsgerät; t = 500 ns/div; U = 1 kV/div; I = 200 mA/div

Rückspeise-Phase kann kein Schwingen aufkommen. Lampenstrom und Lampenspannung sind für dieses Konzept in Abbildung 2.10 zu sehen.

Die Drossel L wirkt in dieser Schaltung zusammen mit der Diode D2, der Kapazität C2 und dem Schalter S1 als Hochsetzsteller. Je nach Bedarf kann die Höhe der anliegenden Spannung an der Primärseite des Impulswandlers über die Abstimmung der Bauteile variiert werden.

Um einen optimalen Gerätewirkungsgrad zu erhalten, muss zusätzlich auf geringe Schaltverluste des Schalters S1 geachtet werden. Beim Einschalten wird der Entladestrom aus der Kapazität C2 durch die Streuinduktivität des Impulswandlers gehemmt, so dass der Stromfluss beim Einschalten begrenzt wird. Nachdem der Kondensator C2 völlig entladen ist, kann während des Zurückschwingens des Lampenschwingkreises der Schalter stromlos geöffnet werden, da die Stromrichtung auch an der Primärseite des Impulswandlers dreht. Die Inversdiode des MOSFETwird leitend und es kann spannungsfrei ausgeschaltet werden. Da es sich hier um resonante Schaltvorgänge handelt, kann die Länge des Spannungspulses unter Beibehalten des optimalen Wirkungsgrads nur dann geändert werden, wenn die resonanten Bauelemente, einschließlich der Lampenkapazität, auf die gewünschte Pulsform angepasst werden.

Ein Überblick über weitere Schaltkonzepte um den Impulsbetrieb zu ermöglichen ist in [21] zusammengestellt. Hier werden verschiedene Arten von hauptsächlich resonanten Inverterkonzepten genutzt, um eine DBEzu betreiben. Ein unkonventionelles Prinzip ist die Idee, den Transformator-



Abbildung 2.11: Verlauf von Spannung und Strom eines Betriebsgeräts mit Transformator, der in Sättigung getrieben wird [21]; Ch1: Lampenspannung (1 kV/div); Ch2: Lampenstrom (20 A/div); Ch3: Primärstrom (10 A/div)

kern in Sättigung zu treiben, so dass die Spannung über dem Transformator zusammenbricht [22]. Nachdem die Lampe gezündet hat, bricht die Spannung, die über dem Transformator anliegt, zusammen (Abbildung 2.11), da der Transformatorkern in Sättigung gerät. Dadurch wird die Lampenkapazität kurzgeschlossen. Es wird eine Rückzündung mit schnell abfallender Spannungsflanke erzeugt.

## 2.4 Vor- und Nachteile der vorgestellten Konzepte aus elektrischer Sicht

Um das beste Betriebsgerät zur Anregung einer dielektrisch behinderten Entladungslampe zu finden, reicht es nicht aus, die elektrischen Gerätewirkungsgrade zu vergleichen. Es muss das gesamte System, d.h. Betriebsgerät und Lampe, in Betracht gezogen werden. Die von der Lampe absolut emittierte Leistung darf nicht unterschlagen werden. Hier werden zunächst die elektrischen Konzepte gegenübergestellt.

- Der größte Vorteil bei der hochfrequenten Sinusanregung ist die Tatsache, dass mit dieser Betriebsweise bis heute die größte bekannte Leistung in eine DBE eingekoppelt wird. So wurde am Lichttechnischen Institut mit nur einem Betriebsgerät 4 kW elektrische Wirkleistung in einen Excimerstrahler über eine längere Betriebszeit eingekoppelt [23]. Dies ist nur dann möglich, wenn der elektrische Wirkungsgrad im Bereich  $\eta_{el} > 90\%$  ist, damit möglichst wenig Wärme von den elektrischen Bauelementen abgeführt werden muss. Abgesehen von der hohen Energieeinkopplung in die Lampe, die mit dem hochfrequenten Sinusbetrieb möglich ist, hat der Lampenwirkungsgrad die geringste Effizienz unter allen Betriebsarten. Somit ist der Systemwirkungsgrad trotz des hohen elektrischen Gerätewirkungsgrads im Vergleich zu gepulsten Betriebsarten schlechter.
- Der geringe Lampenwirkungsgrad des Sinusbetriebs hängt unter anderem auch mit der geringen Anstiegs- und Abfallflanke der Lampenspannung zusammen. Der **Rechteckbetrieb** nimmt sich dieser Problematik an. Mit ihm werden steile Anstiegsflanke erzeugt. Damit handelt man sich jedoch das Problem höherer Verluste in den Schaltern ein, da bei steilen Spannungsflanken resonantes Schalten nur noch eingeschränkt möglich ist. Wie bereits in Kapitel 2.2 angesprochen, ist der Transformator das Element mit den höchsten Anforderungen. Im Gegensatz zum Sinusbetrieb, bei dem der Transformator nur für die Betriebsfrequenz ausgelegt sein muss, treten beim idealen Rechteckbetrieb alle Frequenzen auf. Beim nicht idealen Rechteckbetrieb sind die Anforderungen immer noch sehr hoch. Dabei spielen die Streuinduktivität, die parasitäre Kapazität und die Sättigung des Kerns, die mit der Spannungs-Zeit-Fläche zusammenhängt, eine große Rolle.
- Bei dem Rechteckbetrieb, der mit einer reinen H-Brücke ohne zusätzliche Schaltkomponenten realisiert wird, ist die Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung von der Lampenkapazität und der Impedanz der vorgeschalteten Gleichspannungsquelle abhängig. Mit dem **RPI-Rechteckbetrieb mit variabler Flankensteilheit** ist diese Abhängigkeit nicht mehr gegeben. Steht ein optimaler Transformator zur Verfügung, kann mit dieser Schaltung ein bipolares Spannungssignal im kV-Bereich erzeugt werden, bei dem sowohl die an-

steigende als auch die abfallende Flanke genau vorgegeben sind und nicht von der Last bestimmt werden. Dabei werden die Geschwindigkeiten der Spannungsflanken mit den Hilfsinduktivitäten  $L_A$  und  $L_B$  eingestellt. Problematisch sind die Verluste, die in dieser Schaltung entstehen. Bedingt durch das Schaltprinzip, fließen während des Betriebs ununterbrochen Blindströme, die für eine resonante Schaltweise notwendig sind. Somit sind die Schaltverluste gering, die ohmschen Verluste dafür umso höher. Ein weiterer Schwachpunkt bei dieser Schaltweise ist die eingeschränkte Einstellbarkeit des Puls-Pausen-Verhältnisses. In [24] wurde veröffentlicht, dass sich gerade bei kurzen Pulsen im Bereich von ca. 1  $\mu s$  bis 3  $\mu s$  die optimale Betriebsart für DBEs befindet. Diese Pulslängen können mit dem Betriebsgerät nicht erreicht werden.

• Der unipolare **Impulsbetrieb** kommt sowohl in der Anregung der Lampe, als auch im Gerätewirkungsgrad  $\eta_{el} = 88\%$  dem Optimum am Nächsten. Durch das verlustarme Schalten und die effektive Rückspeisung nicht benötigter Energie in die Spannungsversorgung. wird dieses Schaltprinzip zusammen mit der Lampe zu einem effizienten System. Trotz dieser verlustarmen Schaltweise ist das Gerät im Stande Spannungsanstiegszeiten im Bereich von  $6.5 \,\mathrm{kV}/\mu$  s zu generieren. Diese Schaltweise eignet sich jedoch nur für Lampenleistungen im Bereich von ca. 20 W bis 100W. Da der Kern des Transformators magnetisch nur in eine Richtung ausgesteuert wird, wird für höhere Leistungen das notwendige Kernvolumen zu groß. Zudem werden die Ströme in dem Schalter bei hohen Lampenleistungen zu groß. Damit ist dieses Prinzip, trotz des geringen Bauteileaufwands, nicht mehr wirtschaftlich. Der hohe Gerätewirkungsgrad setzt ein genaues Anpassen des Betriebsgeräts an die Lampe voraus, da die Lampe mit den Komponenten des Betriebsgeräts einen Schwingkreis bildet. Ist eine Veränderung der Betriebsfrequenz erwünscht, so müssen die Bauelemente des Schwingkreises auf die neue Betriebsfrequenz angepasst werden.

# 3 Elektrisches Lampenmodell einer DBE

Das Hauptziel dieser Arbeit ist der Entwurf und die Realisierung einer Schaltung, die eine Barrierenentladung optimal anregt. Es wurden verschiedene Schaltvarianten simuliert, um deren Tauglichkeit festzustellen. Dabei kann sich das Verhalten einer simulierten Schaltung der Wirklichkeit nur soweit annähern, wie sich das Modell der Last annähert. Bereits bestehende Modelle unterscheiden sich in ihrem Anspruch der physikalischen Genauigkeit und der damit verbundenen Komplexität. Es gibt bereits einige Versuche das Entladungsverhalten einer DBE zu simulieren [25], [26], [15]. Die meisten globalen Modelle, die für eine Schaltungssimulation geeignet wären, befassen sich mit der Sinusanregung. Für simulierte Spannungspulse sind diese jedoch nicht geeignet. Zusätzlich ist das Erstellen eines DBE-Modells schwierig, da noch nicht alle dominanten Mechanismen vollständig verstanden sind. Im Folgenden wird auf die wesentlichen Entladungsmechanismen in einer DBE eingegangen, um mit diesen Erkenntnissen auf ein makroskopisches Modell zu schließen, welches das elektrische Verhalten einer DBE in Hinsicht auf Lampenspannung, Lampenstrom und somit auch Lampenleistung nachbildet. Das Modell soll in der Lage sein das Verhalten einer DBE sowohl bei Sinusanregung als auch bei Pulsanregung wiederzugeben.

## 3.1 Zündmechanismen in einer Gasentladung

#### 3.1.1 Ionisierung durch Elektronen im Gas

Unabhängig von der Art einer Gasentladung wird die erste Zündung dadurch eingeleitet, dass ein ausreichend großes elektrisches Feld E im Entladungsraum auf ein freies Elektron eine Kraft ausübt und dieses in Feldrichtung beschleunigt. Durch die Grundionisierung des Gases aufgrund von kurzwelliger Höhenstrahlung und thermischer Bewegung ist das Vorhandensein eines freien Elektrons immer gewährleistet [1]. Befindet sich das Elektron an der Stelle x = 0, so führt es aufgrund von Stößen mit neutralen Atomen eine ungeordnete Bewegung aus. Im Mittel schreitet es jedoch in Richtung des elektrischen Feldes voran. Hat das Elektron ausreichend Energie aufgenommen, so wird mit dieser ein neutraler Stoßpartner ionisiert und es entsteht ein weiteres freies Elektron. Dabei gibt das ursprüngliche Elektron seine Energie ab und muss von Neuem beschleunigt werden, um ein weiteres Atom zu ionisieren. Es entsteht eine Elektronenlawine, die sich auf die Anode hin bewegt. Die Anzahl der Elektronen verhält sich nach folgender Formel:

$$N = N_0 \cdot exp\left(\alpha \, d\right) \tag{3.1}$$

 $N_0$  ist die Zahl der Startelektronen an der Stelle x = 0. d ist der Abstand von dem Ausgangspunkt x = 0 in Feldrichtung und  $\alpha$  ist die Elektronen-Ionisierungszahl oder Erster Townsendscher Ionisierungskoeffizient.  $\alpha$  gibt an, wie viele Ionen im Mittel durch ein Elektron auf einer Wegstrecke von 1 cm in Feldrichtung erzeugt werden. Wie in Abbildung 3.1 dargestellt, hängt  $\alpha$  zum einen von dem Verhältnis  $\frac{E}{p}$  ab und zum andern direkt von p, so dass gilt:

$$\alpha = p \cdot f(\frac{E}{p})$$

#### 3.1.2 Driftstrom von Elektronen und Ionen

Werden  $N_0$  Elektronen von der Kathode ausgelöst oder befinden sich diese vor der Kathode und werden durch ein anliegendes Feld in Richtung der Anode beschleunigt, wie im Fall der DBE, so bewirken diese einen Elektronenstrom

$$I_e(t) = \frac{e}{\tau_e} \cdot N_0 \cdot exp(\alpha x)$$
  
=  $\frac{e}{\tau_e} \cdot N_0 \cdot exp(\alpha u_e t)$  für  $0 \le t \le \tau_e$ 

Dieser Strom (Abbildung 3.2 links) fließt nur so lange, bis die Elektronenlawine an die anodenseitige Barriere des Gasraums gelangt. Bei Erreichen der Barriere sinkt der Strom auf null.  $\tau_e$  ist die Laufzeit dieser Lawine, die



Abbildung 3.1: Elektronen-Ionisierungszahl $\alpha/p$  für verschiedene Edelgase [1]



Abbildung 3.2: (a) Strom der Elektronen einer Lawine, die durch ein Startelektron ausgelöst ist; (b) Strom der positiven Ionen einer Lawine, die durch ein Startelektron ausgelöst ist [1]

sich aus der Driftgeschwindigkeit  $u_e$  der Elektroden im angelegten Feld und der geometrischen Ausdehnung in Feldrichtung des Entladungsraums d ergibt<sup>1</sup>.

$$\tau_e = \frac{d}{u_e}$$

Durch die erheblich größere Masse der entstandenen Ionen erscheinen diese im Vergleich zu den Elektronen zunächst als stationär. Für die Driftgeschwindigkeit der Ionen  $u_+$  im Feld gilt  $u_+ \ll u_e$ . Der Ionenstrom, der während der Laufzeit der Elektronenlawine fließt, beträgt [1]:

$$\begin{split} I_{+}(t) &= \frac{e N_{0}}{\tau_{+}} \cdot \left( exp \left( \alpha \, u_{e} \, t \right) - exp \left( \alpha \cdot \frac{u_{+} \, u_{e}}{u_{+} + u_{e}} \cdot t \right) \right) \quad \text{für } 0 \leq t \leq \tau_{e} \\ &\approx \frac{e N_{0}}{\tau_{+}} \cdot \left( exp \left( \alpha \, u_{e} \, t \right) - exp \left( \alpha \, u_{+} \, t \right) \right) \\ &\approx \frac{e N_{0}}{\tau_{+}} \exp \left( \alpha \, u_{e} \, t \right) \end{split}$$

Während der Laufzeit der Elektronenlawine wächst der Ionenstrom und der Elektronenstrom exponentiell an (Abbildung 3.2). Ist die Laufzeit der Elektronenlawine beendet, d.h. ist  $t > \tau_e$ , werden keine weiteren Ionen gebildet, wenn davon ausgegangen wird, dass die Ionenwolke keine weiteren Atome ionisiert. Solange  $u_+ \cdot t \ll d$  gilt, ist der Ionenstrom annähernd konstant.

$$I_{+}(t) = \frac{e N_{0}}{\tau_{+}} \cdot \left( exp \left( \alpha \ d \right) - exp \left( \alpha \cdot \frac{u_{+} u_{e}}{u_{+} + u_{e}} \cdot t \right) \right) \quad \text{für } \tau_{e} \le t \le \tau_{+}$$
$$\approx \frac{e N_{0}}{\tau_{+}} \cdot \left( exp \left( \alpha \ d \right) - exp \left( \alpha \ u_{+} \ t \right) \right)$$

Gegen Ende der Laufzeit nimmt der positive Ionenstrom ab und geht auf Null zurück.

 $<sup>^{1}\</sup>mathrm{Im}$ Falle der DBE wird die Ausdehnung des Entladungsraums in Feldrichtung als Gapabstand bezeichnet.

# 3.1.3 Nachfolge-Lawinen und die Townsendsche Zündtheorie

Gelangt nun die Ionenwolke an die Kathode des Entladungsraums, so kann diese abhängig vom Kathodenmaterial eine gewisse Anzahl an neuen Elektronen herauslösen. Die Anzahl an Elektronen, die von einem Ion herausgelöst werden kann, wird mit der Oberflächen-Ionisierungszahl  $\gamma_0$  bezeichnet, d.h. nach dem Auftreffen der Ionenwolke auf der Kathode sind

$$N_1 = \gamma_0 \cdot exp \ (\alpha \ d)$$

neue Elektronen an der Kathodenoberfläche entstanden. Die Gewinnung von Elektronen über Volumenionisierung durch positive Ionen wird mit dem Koeffizienten  $\gamma_1$  beschrieben.

Ein weiterer Prozess zur Erzeugung von Elektronen an der Kathode wird durch Photonen hervorgerufen. Dabei wird davon ausgegangen, dass jedes Photon, das an der Kathode ankommt,  $\zeta$  neue Elektronen befreit. Wie viele Photonen wirklich an der Kathode ankommen, hängt von der Geometrie des Entladungsgefäßes bzw. der Elektrodenanordnung ab. Dabei wird die Zahl der ankommenden Photonen an der Kathode um so größer, je kleiner der Plattenabstand (Gap) gegenüber den Plattendimensionen (Elektrodenflächen) ist. Die Gewinnung neuer Elektronen an der Kathode durch Photonen bei Vorhandensein einer Ausgangsanzahl von Elektronen wird auch wieder mit einem Koeffizienten  $\gamma_2$  bezeichnet. Alle drei Ionisierungsmechanismen, die zur Gewinnung von Sekundärelektronen beitragen, werden zum Zweiten Townsendschen Ionisierungskoeffizient  $\gamma = \gamma_0 + \gamma_1 + \gamma_2$  zusammengefasst. Die Townsendsche Zündbedingung besagt, dass der Strom zwischen zwei planparallelen Elektroden aufrecht erhalten wird, wenn gilt:

$$\mu = \gamma \left( exp\left(\alpha \, d\right) - 1 \right) = 1 \tag{3.2}$$

Wird diese Bedingung erfüllt, entstehen in der Entladung soviel Elektronen, dass der Stromfluss nicht abreißt. Voraussetzung für diese Zündbedingung ist, dass Verzerrungen des von außen aufgeprägten elektrischen Feldes durch Raumladungen zu vernachlässigen sind.

Werden  $\alpha$  und  $\gamma$  aus Gleichung 3.2 in Abhängigkeit von dem Verhältnis von Feldstärke zu Druck <sup>E</sup>/<sub>P</sub> geschrieben, so ergibt sich, dass die benötigte Zündspannung für eine selbständige Entladung von dem Produkt aus



Abbildung 3.3: Zündspannung für verschiedene Edelgase zwischen parallelen ebenen Elektroden bei 0 °C [1]

Elektrodenabstand und Gasdruck abhängt. Diese Abhängigkeit wird in dem Paschengesetz beschrieben und in Abbildung 3.3 für Edelgase dargestellt.

$$U_Z = \Phi (p \, d_Z)$$
  
=  $B \cdot \frac{p \, d_Z}{ln (p \, d_Z) + ln \frac{A}{ln(1+1)}}$ 

A und B sind empirische Konstanten, mit denen die Funktion an die gemessenen Zündspannungen angepasst wird. Im Bereich von  $\frac{E}{p} = 200$  bis 800 V/cm Torr (mit 1 Torr = 133,32 Pa) gelten für Xenon die Werte A = 26und B = 350.

Sind nun  $N_0$  Startelektronen an der Kathode vorhanden und werden diese durch ein Feld E zur Anode beschleunigt, so werden neue Startelektronen an der Kathode durch Photonen oder Ionen erzeugt. (In Edelgasen, bei Verwendung sehr reiner Elektroden, werden die Anfangselektronen für die Nachfolge-Lawine überwiegend durch positive Ionen aus der Kathode ausgelöst [1]). Die neuen Startelektronen werden in dem elektrischen Feld



Abbildung 3.4: Elektronen und Ionenströme von Lawinen, wenn Nachfolge-Lawinen nur durch positive Ionen aus der Kathode herausgelöst werden [1]

beschleunigt. Eine Nachfolge-Lawine entsteht. Würden alle Sekundärelektronen ausschließlich durch positive Ionen aus der Kathode gelöst, kann erst eine Nachfolge-Lawine von der Kathode starten, wenn die Ionenwolke an der Kathode ankommt. Elektronen- und Ionenstrom wären, abhängig von den Laufzeiten, zeitlich zum größten Teil getrennt. Der zeitliche Stromverlauf ist in Abbildung 3.4 dargestellt.

Dabei ist  $\tau_e$  die Laufzeit der Elektronenlawine und  $\tau_+$  die Laufzeit der Ionenwolke.

Werden die Nachfolge-Elektronen durch Photonen aus der Kathode ausgelöst, so verkürzt sich der zeitliche Abstand der einzelnen Elektronenlawinen. Geht man davon aus, dass Photonen bereits emittiert werden, bevor eine Elektronenlawine an der Anode angelangt ist, so überlagern sich die Elektronenströme verschiedener Elektronenlawinen wie in Abbildung 3.5 skizziert. Gilt nun  $\mu < 1$  für Gleichung 3.2, so bricht die Folge der Nachfolge-Lawinen nach wenigen Gliedern ab. Diese Zündbedingung gilt auch für die DBE-Entladung, da nur eine begrenzte Anzahl an Elektronen aus dem kathodenseitigen Dielektrikum herausgelöst werden kann. Zum Vergleich werden Elektronenlawinen und ihre Nachfolge-Lawinen bei verschiedenen  $\mu$  in Abbildung 3.6 dargestellt.

#### 3.1.4 Zündung im Kanalaufbau - die Streamer Theorie

Wie bereits erwähnt, hat die Townsendsche Zündtheorie nur dann ihre Gültigkeit, wenn keine wesentlichen Verzerrungen des angelegten äußeren Feldes durch Raumladungen (z.B. Ionenansammlungen) entstehen. Bei



Abbildung 3.5: Elektronenstrom für  $\mu = 1$  bei Erzeugung der Nachfolgerelektronen durch Photonen; Photonen werden emittiert, wenn eine Elektronenlawine die Anode erreicht (*gestrichelt*); Photonen werden bereits während der Laufzeit der Elektronenlawine emittiert (*durchgezogen*) [1]



Abbildung 3.6: Relativer Stromverlauf der Elektronenlawinen für verschiedene $\mu$ [1]



Abbildung 3.7: Feldverzerrung beim Kanalaufbau

Werten von  $\alpha \cdot d > 20$  kommt es zu einer Überhöhung der inneren Feldstärke, die in der Größenordnung der äußeren Feldstärke liegt und damit zu einer Veränderung des Aufbaus der Elektronenlawinen. Die Ionenausbeute ist erheblich größer als die in der Townsendentladung. An dem Ort, an dem sich die größte positive Raumladungsdichte befindet, ist der Ursprung eines Streamers, unabhängig davon, ob er sich in Richtung der Kathode (kathodenseitiger Streamer) oder in Richtung der Anode (anodenseitiger Streamer) ausbreitet. Die Feldstärke im Entladungsraum wird wie in Abbildung 3.7 in drei Bereiche unterteilt.

- 1. Bereich zwischen Kathode und Ionenansammlung: das Feld  $E_3$  ist größer als das ursprünglich von aussen angelegte Feld  $E_0$
- 2. Bereich zwischen Ionenansammlung und Elektronenlawine:  $E_2 < E_0$
- 3. Bereich zwischen Elektronenlawine und Anode:  $E_1 > E_0$

Unterstützt wird der Streameraufbau wesentlich durch die Photoionisierung des Gases [27]. Sekundärelektronen aus der Kathode sind für diesen Prozess von geringer Relevanz.

Im Folgenden wird die Theorie für den kathodenseitigen Streamer erklärt, der in Abbildung 3.8 (a) schematisch für zwei Zeitpunkte abgebildet ist: Die erste Elektronenlawine wandert von der Kathode in Richtung der Anode. Noch bevor diese Elektronenlawine die Anode erreicht, werden durch Photonen, die aus dem Bereich der positiven Raumladungen emittiert werden Atome ionisiert [28] [27]. Es entstehen kathodenseitig nun neue Elektronen an verschiedenen Orten, die an den Bereich des Lawinenkanals angrenzen. Da sich die neu gebildeten Elektronen in einem sehr starken



Abbildung 3.8: Streamermechanismen [27]

elektrischen Feld befinden, werden sie in Richtung der positiven Raumladung bzw. der Anode beschleunigt. Weitere Elektronenlawinen entstehen. Diese ionisieren Atome vor dem positiven Raumladungsfeld. Die sekundären Elektronenlawinen bilden mit dem Ionenfeld der primären Elektronenlawine ein quasi neutrales Feld. Weitere Photonen werden in Richtung Kathode emittiert. Sekundäre Ionen ziehen wiederum neu gebildete Elektronen an. Der Streamer breitet sich in Richtung Kathode aus, bis er dort zum Erliegen kommt.

Der anodenseitige Streamer verhält sich annähernd wie eine fortschreitende Elektronenlawine. Dabei kommt es anodenseitig zusätzlich zur Photoionisierung von Atomen.

Zwischen Anode und Kathode bildet sich ein Plasmaschlauch aus. Zum Vergleich stehen Driftgeschwindigkeiten von Elektronenlawinen, Ionen und Streamern in Tabelle 3.1. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Streamer ist aufgrund von Photoionisierung größer als die Driftgeschwindigkeit der Elektronenlawinen bei der Townsendzündung. Zur Streamerentladung sei angemerkt, dass diese bevorzugt in Anordnungen mit großflächigen Elektronen entsteht (z.B. koplanare Anordnung einer DBE).

	Ausbreitungs- bzw. Driftgeschwindigkeit [cm/s]
Elektronenlawine (Townsend)	10 <sup>7</sup>
Ionen	$10^4$ (annähernd ortsfest)
Kanal anodenseitig	7 bis $9 \cdot 10^7$
Kanal kathodenseitig	1 bis $2 \cdot 10^8$

 

 Tabelle
 3.1: Ausbreitungs- und Driftgeschwindigkeiten von Elektronen, Ionen und Streamern [1]

# 3.2 Einfluss des Sekundärelektronenkoeffizients $\gamma$ auf das Entladungsverhalten

Bei allen Gasentladungslampen beginnt die Entladung mit dem Durchbruch einer Elektronenlawine. Dieser primären Elektronenlawine folgen weitere sekundäre Lawinen. Wie in Kapitel 3.1.3 beschrieben hängt die Anzahl und die Dimension der sekundären Lawinen elementar davon ab, wie groß die Elektronen-Generationsrate  $\gamma$  an der Kathode ist. Bei Gasentladungslampen, deren elektrisch leitende Elektroden sich im Gasraum befinden, besteht die Möglichkeit, dass kontinuierlich sekundäre Elektronenlawinen entstehen. Somit kann diese Anordnung in eine selbständige Entladung übergehen (Abbildung 3.6 (c)).

Bei beidseitig behinderten Entladungslämpen ist die Anzahl der sekundären Elektronenlawinen beschränkt, da nur eine begrenzte Anzahl von Elektronen aus dem Dielektrikum ab- bzw. herausgelöst werden kann. Die Entladung ist nicht in der Lage, in eine selbständige Entladung überzugehen (Abbildung 3.6 (a)). Zusätzlich baut sich im Gasraum ein dem äußeren elektrischen Feld entgegengesetztes Feld auf. Dieses innere Feld wird durch die Ionen im Entladungsraum und den an der Anode angelagerten Elektronen erzeugt. Die Elektronen können an der durch ein Dielektrikum getrennten Anode nicht abfließen, so dass mit jeder Elektronenlawine das im Gasraum vorhandene Gegenfeld anwächst und das resultierende Feld geschwächt wird. Nach einigen Elektronenlawinen ist das resultierende Feld geso stark reduziert, dass weitere Sekundärelektronen von der Kathode nicht mehr genügend Energie erhalten, um Atome zu ionisieren. Die Entladung



Abbildung 3.9: Barrierenanordnung von DBE

kommt zum Erliegen.

Bei einseitig behinderten Entladungen<sup>2</sup> hängt der Abbruch der Entladung von der Polarität der Elektroden ab. Ist die Anode mit einer Barriere versehen und ragt die Kathode in den Entladungsraum (Abbildung 3.9 (b)), so ist der Sekundärelektronenkoeffizient  $\gamma$  groß. Die Zufuhr von Elektronen aus der Kathode wird nicht beschränkt. Die Abbruchbedingung wird von dem inneren Gegenfeld vorgegeben, das dadurch entsteht, dass Elektronen, die an der Anode ankommen, nicht abfließen können. Ragt hingegen die Anode direkt in den Entladungsraum und ist die Kathode durch ein Dielektrikum von dem Gasraum getrennt (Abbildung 3.9 (c)), so ist  $\gamma$ klein. Da die Elektronen aufgrund der metallischen Anode abfließen können, kommt die Entladung nicht durch ein anwachsendes Gegenfeld zum Erliegen, sondern dadurch, dass keine weiteren Elektronen aus der Kathode herausgelöst werden können.

Die Abbruchbedingung kann entscheidend über das Entladungsverhalten einer DBE sein. Zum Vergleich wurde eine einseitig behinderte Entladungslampe mit unipolaren Pulsen betrieben. Der Puls wurde so eingestellt, dass die DBE im kathodenseitig behinderten Betrieb keine filamentierte, sondern eine homogene Entladungsform hat. Danach wurden die Lampenanschlüsse vertauscht (anodenseitig behinderter Betrieb) und die elektrischen Parameter zur Anregung der DBE beibehalten. Der einzige Unterschied ist, dass die Lampe in Abbildung 3.10 (a) anodenseitig behindert und in

 $<sup>^2 {\</sup>rm Eine}$  Elektro<br/>de ist durch ein Dielektrikum vom Gasraum getrennt, die andere Elektro<br/>de hat direkten Kontakt mit dem Gasraum.



(a) anodenseitig behinderte Entladung ( $\gamma$  ist gross)



(b) kathodenseitig behinderte Entladung ( $\gamma$  ist klein)

Abbildung 3.10: einseitig behinderte Entladungslampe mit identischer elektrischer Anregung

Abbildung 3.10 (b) kathodenseitig behindert betrieben wurde. Dadurch ist die Entladung in der Lampe einmal filamentiert (anodenseitig behindert) und einmal homogen (kathodenseitig behindert). (Die unterschiedlichen Farbtöne der beiden Bilder hängen von der Belichtungszeit der Kamera ab.) Der einzige offensichtliche Unterschied in der Lampe bestand aus einem unterschiedlich großen Sekundärelektronenkoeffizienten  $\gamma$ .

# 3.3 Elektrisches Modell einer DBE

Um ein Modell zu erstellen, das den elektrischen Eigenschaften einer DBE aus makroskopischer Sicht entspricht, wurden Messdaten herangezogen, die als Vorgabe für das Modell dienen. Anders als in bestehenden elektrischen Modellen [26] [25] wird bei diesem Modell darauf Wert gelegt, dass es sowohl bei Sinusanregung als auch bei Pulsanregung anwendbar ist.

### 3.3.1 Definition der Größen in einer DBE

In Abbildung 3.11 werden die Größen erklärt, die in dieser Arbeit benutzt werden. Zunächst besteht die untersuchte DBE aus zwei Glasplatten, die zum einen als Behälter für das Gas dienen und zum andern als Barriere



Abbildung 3.11: Reale Grössen in einer DBE

bzw. Dielektrikum (Dielekrisch Behinderte Entladung). Auf den Aussenseiten der Glasplatten befinden sich Elektroden, von denen zumindest eine licht- bzw. strahlungsdurchlässig ist. An diesen Elektroden wird die äußere Spannung oder auch Lampenspannung angelegt. Diese Spannung wird mit  $U_{Lampe}$  oder  $U_{DBE}$  bezeichnet. Die außen angelegte Lampenspannung teilt sich in zwei Spannungsbereiche auf: die Wandspannung bzw. **Barrierenspannung** ( $U_{Wand}$ ,  $U_{Barriere}$ ), die über dem gesamten Dielektrikum abfällt und die Gapspannung  $U_{qap}$ , die über dem Gasraum anliegt. Kommt es zur Zündung der DBE, so fließt im Gap ein Strom. Dieser Strom, der als **Plasmastrom**  $I_{Plas}$  bezeichnet wird, wird in vielen Veröffentlichungen mit Hilfe einer spannungs- und zeitabhängigen Stromquelle beschrieben. Somit setzt sich der äußere Lampenstrom auf den ersten Blick aus den Komponenten  $I_{qap}$  und  $I_{Plas}$  zusammen. Damit sind alle direkt oder indirekt messbaren elektrischen Größen einer DBE beschrieben. Im Folgenden wird das Verhalten der Stromquelle im Gap analysiert und es werden Lösungsvorschläge gemacht, wie die Stromquelle nachgebildet werden kann.



Abbildung 3.12: Lampenmodell im ungezündeten Zustand

#### 3.3.2 Grundlegendes elektrisches Verhalten einer DBE

Betrachtet man die DBE im dynamischen nicht gezündeten Fall unter elektrischen Gesichtspunkten, so entspricht eine dielektrisch behinderte Entladungslampe zwei Kapazitäten, die in Reihe geschaltet sind (Abbildung 3.12). Die Spannung, die über der Wand und diejenige, die über dem Gasraum abfällt, verhält sich wie ein kapazitiver Spannungsteiler. Aus der Stromkontinuität folgt, dass das Produkt aus anliegender Lampenspannung mal Lampenkapazität gleich dem Produkt aus Wandspannung mal Wandkapazität bzw. dem Produkt aus Gapspannung mal Gapkapazität ist.

$$\int Idt = U_{DBE} \cdot C_{DBE} = U_{Wand} \cdot C_{Wand} = U_{gap} \cdot C_{gap}$$

Wird von außen eine Spannung an die Lampe angelegt, beginnt ein Verschiebungstrom  $I_D$  zu fließen, der proportional zur Kapazität und zum Spannungsanstieg pro Zeit ist.

$$I_D = C \, \frac{dU}{dt}$$

Sind freie Ladungsträger im Gap vorhanden, so kommen zu dem Verschiebungsstrom Driftströme hinzu, die durch das angelegte Feld erzeugt werden (Kapitel 3.1.2). Ist das angelegte Feld nicht ausreichend groß, d.h. es entstehen keine Elektronenlawinen, findet keine Ionisierung und kein Lawineneffekt statt. Die Driftströme existieren dann nur so lange, bis die Elektronen an der Anode bzw. die Ionen an der Kathode angelangt sind. Erst wenn das angelegte Feld ausreichend groß ist, kann eine Elektronenlawine entstehen, die wiederum einen Driftstrom darstellt. Ohne Berücksichtigung weiterer Entladungsmechanismen in einer DBE kann zum Zeitpunkt kurz nach der ersten Elektronenlawine eine Feldverzerrung im Gasraum festgestellt werden. Diese Feldverzerrung basiert zunächst darauf, dass sich die viel schnelleren Elektronen an der Anode anlagern und



Abbildung 3.13: Feldverlauf im Plattenkondensator - links: ohne Dielektrikum; rechts: mit Dielektrikum

im Gasraum ein Ionenfeld zurücklassen. Die getrennten Raumladungen spannen ein elektrisches Feld  $E_P$  auf, das dem von außen angelegten Feld  $E_0$  entgegengesetzt verläuft.

Um auf das kapazitive Verhalten einer DBE schließen zu können, bei der Raumladungen getrennt werden, wird zunächst das Verhalten eines Plattenkondensators betrachtet, in dem ein Dielektrikum eingebracht ist. Im vereinfachten Fall des Plattenkondensators berechnen sich die Kapazitäten der Wand und der Gapkapazität nach

$$C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{d} \tag{3.3}$$

Dabei ist A die Fläche der Elektrodenplatten, d der Elektrodenabstand,  $\epsilon_0$  die elektrische Feldkonstante und  $\epsilon_r$  die Permittivitätszahl. Befindet sich zwischen den beiden Kondensatorelektroden Vakuum, so ist die Permittivitätszahl  $\epsilon_r = 1$  und die Kapazität des Kondensators entspricht der Vakuumkapazität. Wird ein Dielektrikum zwischen die Kondensatorelektroden gebracht (Abbildung 3.13), so richten sich die Ladungen des Dielektrikums im elektrischen Feld  $\vec{E_0}$  des Kondensators aus und erzeugen ein Gegenfeld  $\vec{E_P}$  im Dielektrikum. Dieses Gegenfeld, das von den Polarisationsladungen des Dielektrikums erzeugt wird, schwächt das ursprüngliche Feld  $\vec{E_0}$ . Das resultierende Feld ergibt sich zu

$$E_m = E_0 - E_P$$

Das Verhältnis aus ursprünglichem Feld zu resultierendem Feld ist die Dielektrizitätszahl $\epsilon_r.$ 

$$\frac{E_0}{E_m} = \epsilon_r \ge 1$$

Wird nun solch ein Dielektrikum in das Feld eines Kondensators eingebracht, sinkt das resultierende elektrische Feld und es können zusätzliche Ladungsträger an den Elektroden des Kondensators gespeichert werden. Dadurch steigt die Kapazität bei Errichten eines Gegenfelds im Innern des Kondensators an. Ist der Kondensator mit einer Spannungsquelle verbunden, während das resultierende elektrische Feld  $E_m$  absinkt, so fließen zusätzliche Ladungsträger auf den Kondensator. Ist der Kondensator nicht mit einer Spannungsquelle verbunden, sinkt die äußere Spannung. Dabei gilt für ein homogenes Gegenfeld:

$$\frac{E_0}{E_m} = \frac{U_0}{U_m} = \frac{C_m}{C_0} = \epsilon_r$$

Die Gapspannung an einer DBE verhält sich näherungsweise wie wenn in einem Plattenkondensator ein Dielektrikum eingeschoben wird. Wird die Zündspannung erreicht, d.h. werden im Gasraum der DBE Ladungsträger erzeugt und getrennt, so baut sich ein internes elektrisches Gegenfeld auf. Dies hat zur Folge, dass die Gapkapazität ansteigt und die Gapspannung einbricht, da aufgrund der Barriere nicht ausreichend Ladungsträger nachfließen können. In Abbildung 3.14 ist die Gapspannung sowohl für den Sinusbetrieb, als auch für den Pulsbetrieb dargestellt. Dabei unterscheidet sich die DBE von einer Kapazität mit Dielektrikum im Verhalten der Dielektrizitätszahl. Die theoretische Dielektrizitätszahl einer DBE hat keinen festen Wert. Bei dem internen Feld im Gap handelt es sich um eine dynamische Größe. Vor allem im Sinusbetrieb gibt es Momente, in denen sich das äußere und das innere Feld konstruktiv überlagern. Für diesen Fall gilt  $E_m > E_0$ ; für die Dielektrizitätszahl bedeutet dies  $\epsilon_r < 1$ . Als weitere Besonderheit existiert der Fall, dass im Gap Raumladungen getrennt sind, jedoch kein äußeres Feld vorhanden ist (Pulsbetrieb). Dies bedeutet  $\epsilon_r \rightarrow 0$ , die Kapazität bzw. DBE hat den Charakter einer Spannungsquelle und induziert Ströme in den äußeren Stromkreis. Im Folgenden wird die Verteilung der Raumladungen im Gap und die dazugehörenden äußeren Spannungen für den Sinusbetrieb und den Pulsbetrieb betrachtet.



(b) Pulsanregung

Abbildung 3.14: Verlauf der Gapspannung bei unterschiedlichen Anregungsarten; dünne Linie: Lampenspannung - dicke Linie: Gapspannung



Abbildung 3.15: Ablauf der Entladung (Spannungs-Zeit-Diagramme: dünne Linie - äußere Lampenspannung; dicke Linie -Gapspannung)

# Ladungsverteilung im Fall des Sinusbetriebs: (Abbildung 3.15 linke Spalte)

- a) Die Sinusspannung befindet sich in der negativen Halbperiode. Die Entladung hat bereits stattgefunden. Durch die von außen angelegte Spannung  $U_0$  werden die im Gasraum erzeugten Ladungsträger getrennt. Die Ionen haben sich an der Kathode angelagert, die Elektronen an der Anode. Durch die Trennung der Ladungsträger wird ein elektrisches Feld und somit eine Spannung  $U_P$  erzeugt, die der äußeren Spannung entgegenwirkt. Die resultierende Spannung, die im Gap anliegt, ist kleiner als wenn sie mit dem kapazitiven Spannungsteiler berechnet werden würde.
- **b)** Die äußere negative Spannung sinkt auf null Volt. Aufgrund der getrennten Ladungsträger im Gap wird die Gapspannung bereits positiv, obwohl die Lampenspannung noch negativ ist. Es gilt:

$$U_G = U_0 + U_P$$

- c) Die Spannung  $U_P$  und die Lampenspannung  $U_0$  überlagern sich konstruktiv, so dass das innere Feld schnell zu großen Werten ansteigt.
- d) Die Bedingung für den Lawinendurchbruch wird erreicht. Es entsteht eine Elektronenlawine, die sehr schnell zur Anode wandert. Dabei hinterlässt die Elektronenlawine eine durch Ionen erzeugte positive Raumladung im Gap. Unabhängig davon, ob es zu einem Kanaldurchbruch kommt (Streamer) oder nicht, erlischt die Entladung nach kurzer Zeit. Trotz des Anstiegs der äußeren Lampenspannung bricht die Gapspannung während des Zündzeitpunkts ein. Da die Elektronen und Ionen durch das äußere Feld getrennt werden, erzeugen sie ein Gegenfeld, das die resultierende Gapspannung reduziert.
- e) Die äußere Lampenspannung steigt weiter an. Da die Entladung zum Erliegen gekommen ist, d.h. da keine weiteren Ladungsträger durch Ionisierung erzeugt werden, folgt die Gapspannung der äußeren Lampenspannung im Sinne des kapazitiven Spannungsteilers, bis die äußere Spannung den Maximalwert erreicht hat und wieder sinkt.
Ladungsverteilung im Fall des Pulsbetriebs: (Abbildung 3.15 rechte Spalte)

- a) Im Gap existiert kein Feld, das durch getrennte Ladungsträger erzeugt wird. Die Spannung  $U_P$  ist null. Falls Ionen und Elektronen im Gap existieren, sind diese nicht räumlich getrennt, sondern so durchmischt, dass nach außen kein elektrisches Feld wirkt. Die äußere Lampenspannung  $U_0$  steigt bis zur Zündspannung an. Die am Gap anliegende Spannung verhält sich in erster Näherung wie beim kapazitiven Spannungsteiler.
- b) Die Bedingung für die Lampenzündung wird erreicht. Es entstehen eine oder mehrere Elektronenlawinen, die weitere Ladungsträger generieren. Aufgrund des von außen eingeprägten elektrischen Feldes werden die Ladungsträger getrennt. Dabei lagern sich die Elektronen vor der Anode an, die Ionen sind aufgrund ihrer Trägheit annähernd ortsfest im Entladungsraum. Zusammen erzeugen sie ein Gegenfeld zum von außen eingeprägten Feld, das die resultierende Gapspannung in ca. 60 ns einbrechen lässt. (In diesem Beispiel bricht die Gapspannung um ca. 400 V ein.)
- c) In diesem Zeitraum, der ca.  $2\,\mu$ s dauert, bewegen sich freie Ionen in Richtung der Kathode. Trotz ansteigender Lampenspannung fällt die Gapspannung leicht ab.
- d) Eine weitere Zündung wird dadurch eingeleitet, dass die äußere Spannung auf null Volt abgesenkt wird. Aufgrund der getrennten Ladungsträger, wird die Gapspannung bereits negativ obwohl die äußere Spannung noch positiv ist. Da das von außen eingeprägte Feld sinkt, überwiegt das Feld bzw. die Anziehungskraft der getrennten Ladungsträger. Sie bewegen sich aufeinander zu. Es kommt zu einer weiteren Entladung, die auch Rückzündung genannt wird.
- e) Es folgt eine Pause bzw. eine Ruhephase, in der annähernd keine Spannung an der Lampe anliegt. In diesem Zeitraum haben die Elektronen und Ionen Zeit, um sich so zu verteilen bzw. zu rekombinieren, dass der Gasraum als quasi feldfrei angesehen werden kann.

### 3.3.3 Elektronen- und Ionen-Laufzeiten in einer DBE

Um eine zeitliche Vorstellung über Driftgeschwindigkeiten und Laufzeiten von den Elektronen und Ionen zu bekommen, die sich im Gap bewegen, wurden anhand von Literaturwerten grobe Überschlagsrechungen gemacht. Diese Werte sollen darüber Aufschluss geben, welches zeitabhängige elektrische Verhalten von welchem Ladungsträger beeinflusst wird. Um mit Literaturwerten die gewünschten Werte zu ermitteln, muss zunächst das **reduzierte Feld** E/N [ $\frac{V}{m} \cdot m^3$ ] berechnet werden. Dabei ist Edas elektrische Feld, das auf die Elektronen bzw. die Ionen wirkt und Ndie Gesamtteilchendichte.

$$N = \frac{\text{Teilchenzahl}}{\text{Volumen}} = \frac{p}{k \cdot T} \left[ \frac{\text{N/m}^2}{\text{J/K} \cdot \text{K}} \right]$$

Mit

$$p = 300 \text{ mbar} = 3 \cdot 10^4 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \quad \text{(Gasdruck in der Lampe)}$$
$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}} \qquad \text{(Boltzmann-Konstante)}$$
$$T = 300 \text{ K}$$

ergibt sich für die in dieser Arbeit benutzten Lampen eine Gesamtteil- chendichteNvon

$$N = 7,24 \cdot 10^{24} \,\mathrm{m}^{-3},$$

die der Atomdichte für Edelgase (hier Xenon) entspricht. Bei einer Zündspannung im Gap von ca. 1000 V, einem Gapabstand von ca. 2 mm und der Annahme, dass keine Feldverzerrung im Entladungsraum vorhanden ist, ergibt sich die reduzierte Feldstärke zu

$$E/N = \frac{1000 \text{ V}}{2 \text{ mm}} \cdot \frac{1}{7,24 \cdot 10^{24} \text{ m}^{-3}} = 69 \cdot 10^{-21} \text{ Vm}^2 = 69 \text{ Td} \quad ,$$

mit  $10^{-21}$  Vm<sup>2</sup> = 1 Td (Townsend).

**Elektronenlaufzeit:** Für eine reduzierte Feldstärke von 70 Td wird in [29] eine Elektronen-Driftgeschwindigkeit von  $4 \cdot 10^4 \text{ ms}^{-1}$  angegeben. (Dieser

Wert wurde über das BOLSIG Programm berechnet [30].) Mit einem Gapabstand von ca. 2 mm benötigt ein Elektron bei einer reduzierten Feldstärke von 70 Td 50 ns um das Gap zu durchlaufen.

$$t_e = \frac{d}{v_e} = \frac{2 \text{ mm}}{4 \cdot 10^4 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 50 \text{ ns}$$

(Alle Berechnungen gelten für den idealen Fall, d.h. dass keine Feldverzerrung im Gap vorhanden ist. Somit ist dieser Wert für die anfängliche Townsend-Entladung gültig)

**Ionenlaufzeit:** In derselben Arbeit wird die Driftgeschwindigkeit von Ionen angegeben [29]. Sie berechnet sich zu

$$v_i = \frac{E/N}{a + b\sqrt{\left|E/N\right|}}$$

Mit den Parametern a und b für einfach ionisierte Xenonatome und einfach ionisierte Xenonexcimere ergeben sich die entsprechenden Driftgeschwindigkeiten für eine reduzierte Feldstärke von 70 Td. In Tabelle 3.2 sind die entsprechenden Werte aufgetragen. Bei einem Gapabstand von ca. 2 mm

	a	b	$v_i  [\mathrm{m/s}]$
$Xe^+$	0,343	0,0373	106,9
$Xe_2^+$	$0,\!235$	0,0193	$176,\! 6$

**Tabelle 3.2:** Parameter für die Ionendriftgeschwindigkeit von einfach io-<br/>nisierten Xenonatome bzw. Xenonexcimeren und die zuge-<br/>hörige Driftgeschwindigkeit für E/N = 70 Td

benötigen die Ionen mit den angegebenen Driftgeschwindigkeiten 18,7  $\mu$ s für die einfach ionisierten Xenonatome bzw. 11,32  $\mu$ s für die einfach ionisierten Xenonexcimere, um das Gap zu durchlaufen. (Auch hier gilt wieder: alle Berechnungen gelten für den idealen Fall, d.h. dass keine Feldverzerrung im Gap vorhanden ist.)

Zusammenfassend werden nochmals die Driftgeschwindigkeiten und die Laufzeiten für ionisierte Xe-Atome bzw. Excimere und Elektronen für die reduzierte Feldstärke E/N = 70 Td in Tabelle 3.3 angegeben. Ist die Zeit,

	v  [m/s]	$\tau \; [\mu \mathrm{s}]$
$Xe^+$	106, 9	18,7
$Xe_2^+$	$176,\! 6$	11,32
е	40000	$0,\!05$

**Tabelle 3.3:** Laufzeiten und Driftgeschwindigkeiten in einem Gap von 2mm und einer reduzierten Feldstärke von 70 Td



Abbildung 3.16: Dynamisches Lampenmodell

in der die äußere Spannung an einer DBE anliegt, kurz genug, wie z.B. bei der Pulsanregung, so tragen die im Feld driftende Xenonionen nicht wesentlich zum Stromfluss in einer Excimerentladung bei. Erst wenn das äußere Feld eine längere Zeit an der DBE anliegt, z.B. bei einem Sinusoder Rechteckbetrieb, haben auch die Ionen einen größeren Anteil am Stromfluss und somit auch an der Leistungsaufnahme der elektrisch eingekoppelten Energie.

## 3.3.4 Simulationsmodell

Es stellt sich nun die Frage, wie das Verhalten von Elektronen und Ionen im Gap einer DBE in einem makroskopisch elektrischen Modell beschrieben werden kann. Dieses Modell soll für die Anregung mit Spannungspulsen genutzt werden, um die Schaltung des adaptiven Impuls-EVG zu simulieren. Nach der Diskussion in Kapitel 3.3.2 über die dynamischen elektrischen Felder im Gap, die makroskopisch gesehen eine zeitlich- und



Abbildung 3.17: Elektrisches Lampenmodell für unipolaren Pulsbetrieb

spannungsabhängige veränderliche Gapkapazität darstellen, liegt es nahe, eine zeit- und spannungsabhängige **Plasmakapazität**  $C_{plas}$  einzuführen (Abbildung 3.16). Somit repräsentiert die Kapazität  $C_{aap}$  die Kapazität zwischen den zwei Wandkapazitäten, wenn keine freien Ladungsträger im Gap vorhanden sind (Vakuumkapazität). Die Plasmakapaziät  $C_{plas}$  ist der Teil der hinzukommt, sobald freie Ladungsträger im Gasraum entstehen und diese im vorhandenen Feld getrennt werden. Die Größe der Plasmakapazität ist zeit-, spannungs- und anregungsabhängig. Wird die Lampe nicht betrieben, rekombinieren die freien Ladungsträger und die Plasmakapazität nimmt den Wert null Farad an. Allein mit der dynamischen Plasmakapazität  $C_{plas}$  aus Abbildung 3.16 ist es jedoch nicht möglich, eine Zündbedingung zu definieren. Für die Zündbedingung existiert kein direkter Zusammenhang mit der Gapspannung und den äußeren Größen  $U_{Lampe}$  und  $I_{Lampe}$ . Der Zusammenhang wird durch die Einführung einer Plasmaimpedanz  $Z_{Ion}$  hergestellt, wie in dem Modell aus Abbildung 3.17 dargestellt ist. In dem Modell wird das Gap in eine statische Vakuumkapazität  $C_{gap}$  und einen dynamischen Teil, der die Plasmaentladung beschreibt, unterteilt. Letzterer Teil besteht aus einem Serienglied, das sich aus einer dynamischen Impedanz und einer jetzt nicht mehr dynamischen, sondern statischen Plasmakapazität  $C_{Plasma}$  zusammensetzt. Dabei nimmt  $C_{Plasma}$ , je nach Art der Anregung, einen anderen festen Wert an. Die Zündbedingung besteht darin, dass eine gewisse Spannung über der noch hochohmigen Plasmaimpedanz  $Z_{Ion}$  abfällt. Sobald die Zündbedingung erfüllt ist, erhöht sich der Leitwert exponentiell von Null auf einen Maximalwert, was grob dem Verhalten einer Elektronenlawine entspricht. Es beginnt ein Plasmastrom  $I_{Ion}$  zu fließen, der sich aus folgenden Strömen zusammensetzt:

$$I_{Ion} = I_{Lampe} - I_{Gap}$$

Wie aus der Gleichung zu entnehmen ist, setzt sich der Plasmastrom aus dem äußeren Lampenstrom und einem Gapstrom zusammen. Die Ladungsträger, die auf der Gapkapazität gespeichert sind, entladen sich zum Teil in die Plasmakapazität  $C_{Plasma}$ , sobald die Plasmaimpedanz  $Z_{Ion}$  sinkt. Ist die Plasmakapazität aufgeladen und ist die äußere Spannungsänderung null, so kommt der Plasmastrom zum Erliegen. Die Leistung, die an der Impedanz  $Z_{Ion}$  umgesetzt wird, entspricht der Energie, die benötigt wird, um die Ladungsträger im Gas zu erzeugen bzw. zu trennen.

Dieses Modell besitzt dieselben Komponenten wie das Modell, das bereits in [10] vorgestellt wurde, da beide Modelle teilweise in Zusammenarbeit und teilweise unabhängig voneinander entwickelt wurden. Die Modelle unterscheiden sich in den Randbedingungen bzw. den Voraussetzungen für das Modell.

Den Modellen gemeinsam ist, dass der Entladungsraum bzw. das Gap aus den elektrischen Komponenten wie in Abbildung 3.17 beschrieben wird, dass die Zündbedingung durch die Spannung  $U_{Ion}$  festgelegt wird, dass  $C_{Plasma}$  die Raumladung im Gasraum beschreibt und dass durch die örtliche Trennung von Ionen und Elektronen ein inneres Feld entsteht, das dem von außen eingeprägten Feld entgegensteht.

Im Unterschied zu dem hier vorgestellten Modell, das von einer zeit- und anregungsabhängigen Plasmakapazität  $C_{Plasma}$  ausgeht (Kapitel 3.3.2 und Abbildung 3.22), wird in [10] angenommen, dass die Größe von  $C_{Plasma}$ der von  $C_{gap}$  gleicht. Begründet wird diese Annahme damit, dass die in der Entladung entstandenen Elektronen und Ionen als ungebunden betrachtet werden können und somit die Polarisierung des Plasmas vernachlässigt werden kann. In [10] wird angenommen, dass sich die Schwerpunkte der Ladungsdichten nach der Entladung auf den Barrieren befinden. Der Gapabstand wird als Abstand der Ladungsdichten angesetzt und gefolgert, dass  $\epsilon_r = 1$  ist. Mit den geometrischen Dimensionen des Entladungsraums und der angenommenen Dielektrizitätszahl wird ein C<sub>Plasma</sub> berechnet, das der Größe von C<sub>gap</sub> gleicht. Es wird also angenommen, dass C<sub>Plasma</sub> nach der Entladung einen konstanten Wert besitzt, der unabhängig von der Art der Anregung der Entladung ist. Auf den zeitlichen Verlauf und die Größe von Z<sub>Ion</sub> wird in [10] nicht eingegangen. Somit unterscheiden sich die beiden Modelle im Verhalten der Plasmakapazität C<sub>Plasma</sub>.

Wie in Kapitel 3.1.3 beschrieben, setzt sich der Plasmastrom aus einer Elektronen basierten Stromkomponente und einer Ionen basierten Stromkomponente zusammen. Um dem Modell aus Abbildung 3.17 das Verhalten des ionenbasierten Stromanteils hinzuzufügen, muss das Modell der Plasmaentladung wie in Abbildung 3.18 um ein weiteres RC-Glied erweitert werden. Vor allem für die Impedanz des neuen Zweigs gilt ein anderes Verhalten, da mit diesem die Laufzeit der viel langsameren Ionen beschrieben werden soll. Somit sind die Komponenten für das elektrisch makroskopische Modell einer DBE für Puls- und Sinusanregung beinahe festgelegt.

Die letzte Komponente, die dem Modell noch zugefügt werden kann, ist eine weitere Kapazität, die parallel zu den Impedanzen anliegt (Abbildung 3.19 (b) ). Dieses Element beinhaltet Ladungen, die bereits vor der Zündung, abhängig von der Art der Anregung, fließen können. Vor allem bei starker Ionisierung des Gases, d.h. steilen Spannungsflanken und kurzen Pulslängen, tritt ein "erster" Plasmastrom auf. Die Ursache dafür sind ungebundene Elektronen und Ionen, die sich nach der vorhergehenden Anregung noch im Entladungsraum befinden. Wie in Abbildung 3.19 (a) zu sehen, bewirken sie bei Anlegen eines Feldes im Gasraum einen Strom, der nicht dem kapazitiven Verschiebungsstrom entspricht. Dieser Strom wird dem Plasmastrom zugeordnet.

Das Auftreten solchen Verhaltens und seine Abhängigkeit von Anstiegsflanke, Pulslänge, Pulspause, Gasdruck usw. wurde in dieser Arbeit nicht weiter untersucht. Deshalb wird auch nicht näher auf diese Kapazität eingegangen. Aus experimentellen Erfahrungen wurde für die Größe der Kapazität parallel zu  $Z_{Ion}$  der Wert von  $C_{gap}$  eingesetzt. In Serie zu dieser Kapazität muss noch eine Impedanz liegen, die die Verluste durch Bewegen der Ladungen beschreibt. Für diese Impedanz gibt es keine Er-



Abbildung 3.18: Elektrisches Lampenmodell unter Berücksichtigung der Elektronen- und Ionenströme



(a) Plasmastrom und Lampenstrom vor Lampenzündung



Abbildung 3.19: Modell für Gap mit Plasmastrom vor Lampenzündung



Abbildung 3.20: Schnittdarstellung der Laborlampe, an der die inneren Größen gemessen wurden

fahrungswerte.

### Abschätzung der Bauteilgrößen

Um auf die Größen der elektrischen Komponenten schließen zu können, wurden Messungen an einer zweiseitig behinderten DBE in Flachbauweise gemacht, die von der französischen Firma Saint-Gobain gefertigt wurde [31]. Dabei wurden zusätzlich zu den äußeren Größen die Spannung  $U_{Gap}$  und der Strom  $I_{Ion}$  bestimmt. Das praktische Verfahren, um diese Werte zu messen, wird in [14] und [31] beschrieben. Bei der Lampe (Abbildung 3.20) handelt es sich um zwei 3,85 mm dicke Glasplatten, die durch einen Glaslotrahmen miteinander luftundurchlässig verbunden wurden. Der Abstand der Platten beträgt 2 mm. Als Elektroden (TCO) dienen zwei SnO<sub>2</sub>:F Schichten, die auf den Glasplatten aufgetragen sind. Die Elektrodenfläche A ist  $150\,\cdot\,73\,\mathrm{mm^2}$ groß. Eine ausführliche Beschreibung der Laborlampe ist in [31] zu finden<sup>3</sup>. Die kapazitiven Größen einer DBE werden mit Hilfe ihrer geometrischen Daten bestimmt. Bei flächigen Lampen werden diese mit Formel 3.3 berechnet. Bei einer beidseitig behinderten Entladungslampe ergeben sich somit die Größen  $C_{Wand1}$ ,  $C_{gap}$  und  $C_{Wand2}$ . Die Dielektrizitätszahl des Glases Planilux wurde in [31] bestimmt. In Abhängigkeit von der Frequenz bewegt sich der Wert im Bereich von 8,53 (bei 10 kHz) bis 7,96 (bei 10 MHz). Die Dielektrizitätszahl für Xenon wurde zu  $\epsilon_r = 1$  angenommen. Es ergeben sich folgende Werte für die Lampe:

 $<sup>^{3}\</sup>mathrm{Im}$ Gegensatz zu der beschriebenen Laborlampe ist die benutzte Laborlampe in Bezug auf die Fläche kleiner und es befindet sich auf dieser kein Leuchtstoff

Größe	Wert	Einheit	
Elektrodenfläche	$73 \cdot 150$	$mm^2$	
$C_{Lampe}$	31	pF	
$C_{Barriere}$	100	pF	
$C_{Gap}$	45	pF	

Tabelle 3.4: Kapazitäten der Laborlampe im nicht gezündeten Zustand

### Bestimmung der Plasmakapazitäten bei unterschiedlichen Betriebsmodi

Ausgehend von der Gleichung für die Kapazität eines Kondensators soll über die von außen geflossene Ladung auf die Plasmakapazität geschlossen werden.

$$C_{Gap} + C_{Plasma}(t) = \frac{Q(t)}{U_{gap}(t)} = \frac{\int_0^t I_{Lampe}(t)dt}{U_{Gap}(t)}$$
(3.4)

$$C_{Plasma}(t) = \frac{\int_0^t I_{Lampe}(t)dt}{U_{Gap}(t)} - C_{Gap}$$
(3.5)

mit  $C_{Gap} = \text{const}, C_{Plasma}(\text{ungezündet}) = 0 \text{ F} \text{ und } U_{Lampe}(t = 0 \text{ s}) = 0 \text{ V}$ 

Es wurde für den Sinusbetrieb und den Pulsbetrieb die zeitabhängige Plasmakapazität berechnet. Dabei besteht das Problem, dass Gleichung 3.5 nur in einem kleinen Zeitfenster Gültigkeit hat. Das ist der Bereich, nachdem die Zündung erfolgt ist, d. h. ab dem Zeitpunkt, zu dem die Gapspannung ihr Minimum erreicht hat, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der äußere Lampenstrom sein Vorzeichen wechselt (Abbildung 3.21 (b)). Der Grund dafür ist, dass ein Teil der Ladungsträger, die nach der Entladung entstanden sind, an der Anode bzw. an der Kathode gebunden sind. Somit verhält sich das Gap nicht mehr wie ein Kondensator. Außerhalb des beschriebenen Bereichs hat die Gleichung keine Gültigkeit.

In Abbildung 3.21 (a) ist der berechnete Verlauf der gesamten Plasmakapazität für den Sinusbetrieb aufgetragen. Sobald der Scheitelwert der äußeren Lampenspannung überschritten ist, d.h. der Betrag der Lampenspannung sinkt, steigt die berechnete Plasmakapazität ins Unendliche an. Das liegt daran, dass der größte Teil der erzeugten Ladungsträger an den



(a) dünne Linien (linke Achse): Lampenspannung und Gapspannung; dicke Linie (rechte Achse): berechnete Plasmakapazität; grauer Bereich: Gültigkeitsbereich der berechneten Plasmakapazität



(b) dünne Linien (linke Achse): Lampenspannung und Gapspannung; dicke Linie (rechte Achse): äußerer Lampenstrom; grauer Bereich: Gültigkeitsbereich der berechneten Plasmakapazität

Abbildung 3.21: Verlauf der berechneten Plasmakapazität einer DBE

Name	sin1	$\sin 2$	
	Sinus 32 kHz	Sinus $75\mathrm{kHz}$	
$U_{max}$	$1100\mathrm{V}$	$1150\mathrm{V}$	
Anstiegszeit	$207{ m V}/\mu{ m s}$	$555\mathrm{V}/\mathrm{\mu s}$	
$C_{Plasma}$ vor Zündung	$50\mathrm{pF}$	$46\mathrm{pF}$	
$C_{Plasma}$ nach Zündung	$160\mathrm{pF}$	$232\mathrm{pF}$	
$C_{Plasma}$ bei $I_{Lampe} = 0$ A	$300\mathrm{pF}$	$287\mathrm{pF}$	

**Tabelle 3.5:** Kapazitäten der Laborlampe im gezündeten Zustand bei Sinusanregung, 125 mbar Xenon

Wänden der Barriere gebunden sind und nicht der äußeren Lampenspannung folgen kann. Ist die äußere Spannung groß genug, so lösen sich u.a. die Ladungsträger von den Wänden. Die freien Ladungsträger bewegen sich entlang des elektrischen Felds und das Gap erhält seinen kapazitiven Charakter zurück. Wie bereits erwähnt, hängt die Größe der Plasmakapazität davon ab, wie viele Ladungsträger im Entladungsraum vorhanden sind und wo sie sich befinden. Die Anzahl der vorhandenen Ladungsträger hängt stark von der Anregung des Plasmas ab. In Tabelle 3.5 und 3.6 sind gemessene Plasmakapazitäten für Sinusanregung und Pulsanregung aufgetragen. Von besonderem Interesse sind die Kapazitäten zu folgenden Zeitpunkten.

- 1. **Plasmakapazität vor dem Zündzeitpunkt:** Im Betrieb ist eine Plasmakapazität vor dem Zündzeitpunkt vorhanden. Diese ist für den gemessenen Plasmastrom verantwortlich, der vor der Zündung fließt. Bei den in dieser Arbeit durchgeführten Messungen war diese Kapazität ungefähr so groß wie die Gapkapazität. Es wird vermutet, dass diese Kapazität restliche freie Ladungsträger beinhaltet.
- 2. Plasmakapazität direkt nach der Zündung: Nachdem die Gapspannung eingebrochen ist, hat die Plasmakapazität einen Wert " $C_{Plasma}$ nach Zündung" angenommen, der durch die Elektronenlawinen gebildet wird.
- 3. Plasmakapazität bei Stromnulldurchgang des äußeren Stroms: Aufgrund der viel langsameren Ionen wächst der Wert der Plasma-

Name	puls1	puls2	puls3	puls4
Pulslänge	$700\mathrm{ns}$	$690\mathrm{ns}$	$600\mathrm{ns}$	$500\mathrm{ns}$
U <sub>max</sub>	$2500\mathrm{V}$	$2500\mathrm{V}$	$2500\mathrm{V}$	$2500\mathrm{V}$
Betriebsfrequenz	30 kHz	$30\mathrm{kHz}$	$30\mathrm{kHz}$	$30\mathrm{kHz}$
Anstiegszeit	$19\mathrm{kV}/\mu\mathrm{s}$	$19\mathrm{kV}/\mu\mathrm{s}$	$19\mathrm{kV}/\mu\mathrm{s}$	$19\mathrm{kV}/\mu\mathrm{s}$
$C_{Plasma}$ vor Zündung	32 pF	$36\mathrm{pF}$	$56\mathrm{pF}$	$51\mathrm{pF}$
$C_{Plasma}$ nach Zündung	240 pF	$258\mathrm{pF}$	$288\mathrm{pF}$	$258\mathrm{pF}$
$C_{Plasma}$ bei $I_{Lampe} = 0 \mathrm{A}$	$285\mathrm{pF}$	$310\mathrm{pF}$	$348\mathrm{pF}$	$324\mathrm{pF}$

**Tabelle 3.6:** Kapazitäten der Laborlampe bei Pulsanregung; Spannungs-<br/>anstieg konstant; Variation der Pulslänge; Lampenkapazi-<br/>tät: 31 pF ; Gapkapazität: 45 pF; 150 mbar Xenon

kapazität, der durch Diffusion der Ionen gebildet wird, erst nach und nach an. Das Maximum dieser Kapazität wird erreicht, wenn der äußere Lampenstrom zu null wird. Ist die Dauer der angelegten Lampenspannung kürzer als die Zeit, die die Ionen zum Durchwandern des Gaps benötigen, so kann die ionenbasierte Plasmakapazität nicht zu ihrem maximalen Wert anwachsen. Dies ist vor allem der Unterschied eines Pulsbetriebs zu einem Rechteck- bzw. Sinusbetrieb mit Betriebsfrequenzen unter 40 kHz. In Tabelle 3.5 vergrößert sich die Plasmakapazität nach der Lampenzündung bei einer Frequenz von 32 kHz bis zum Stromnulldurchgang des äußeren Stroms um den Faktor 1,8. Bei einer Frequenz von 75 kHz hat das Verhältnis von Plasmakapazität bei Stromnulldurchgang zu Plasmakapazität nach Lampenzündung den Wert 1,2. Dieses entspricht ungefähr dem bei Pulsanregung (Tabelle 3.6).

In Tabelle 3.7 wurde in einer weiteren Messung (mit einer anderen Laborlampe) die Plasmakapazität bei Pulsanregung berechnet. Dabei wurde die Anstiegszeit der Lampenspannung variiert und die Pulslänge bei ca. 800 ns konstant gehalten. Das Ergebnis ist ein Anstieg der Plasmakapazität, der proportional zur Anstiegsgeschwindigkeit verläuft (Abbildung 3.22), d.h. die Plasmakapazität direkt nach der Zündung ist um so größer, je größer die Flankensteilheit der Lampenspannung ist.

Anstiegszeit	$C_{DBE}$ nach $C_{Plasma}$ na Entladung Entladung		Entladungs- dauer	$G_{Ion\_e}/A$
$kV/\mu s$	pF	pF	ns	$\mu S/cm^2$
8	68	11	120	0,98
8,35	94	79	120	7,01
9,22	128	237	94	26,90
10,74	145	369	60	$65,\!57$
12,34	165	661	50	140,90
14,93	181	1200	52	245,10
15,63	185	1330	56	253,47

Tabelle 3.7: Gesamtkapazität und Plasmakapazität der Laborlampe bei<br/>Pulsanregung; Variation des Spannungsanstiegs ; Pulslänge<br/>konstant auf 800 ns; Betriebsfrequenz: 31 kHz; Lampenka-<br/>pazität: 63 pF ; Gapkapazität: 91 pF; Gas: 125 mbar Xenon;<br/>Elektrodenfläche: 216,09 cm²



Abbildung 3.22: Plasmakapazität nach der Lampenzündung, in Abhängigkeit von der Anstiegsflanke; dicke Linie: Plasmakapazität; dünne Linie: Lampenkapazität

Es wird angenommen, dass die Plasmakapazität, die durch Ionen gebildet wird, in der selben Größenordnung liegt wie die Plasmakapazität, die nach der Lampenzündung durch Elektronen gebildet wird. Aus Tabelle 3.6 kann man entnehmen, dass die Kapazität der DBE nach der Lampenzündung weiterhin zunimmt. Die Vermutung ist, dass die Ursache dafür driftende Ionen sind. Die Ionen durchlaufen den Entladungsraum im zeitlichen Bereich von 11  $\mu$ s bis 18  $\mu$ s. Sobald die äußere Spannung nicht mehr anliegt, kommt auch der Ionenstrom zum Erliegen und die Kapaziät wächst nicht mehr weiter an.

Für das Modell wird angenommen:

$$C_{Plasma\_+} = C_{Plasma\_e}$$

#### Bestimmung der Plasmaimpedanz bzw. der Plasmaleitwerte

Bei der Bestimmung der Plasmaimpedanz bzw. der Plasmaleitwerte ist es sehr schwer einen Wert anzugeben, da sich dieser in Abhängigkeit von der Zeit ändert. Unter der Annahme, dass der Leitwert nach der Zündung annähernd konstant ist und dass die Plasmakapazität bereits bekannt ist, kann durch Bestimmen der Entladedauer auf den mittleren Ladewiderstand bzw. auf den mittleren **Elektronenleitwert**, der durch den Driftstrom der Elektronen entsteht, geschlossen werden. Als Entladedauer wird die Länge des Strompulses des Plasmastroms angenommen. Sowohl bei der Pulsanregung als auch bei der Sinusanregung wird nur die Zeitdauer benötigt, in der die Plasmakapazität auf einen gewissen Endwert  $U_C$  aufgeladen wird. Hier ist  $\frac{U(t)}{U_{max}}$  das Verhältnis der Spannung U(t) zur maximalen Spannung, auf die die Plasmakapazität in der Zeit t aufgeladen wurde. In den Berechnungen wurde das Verhältnis jeweils zu 0,9 angenommen. Als Kapazität für die Berechnung wurde die jeweilige Kapaziät " C<sub>Plasma</sub> nach Zündung " (Tabelle 3.5 und 3.6) genommen.

$$U(t) = U_{max}(1 - e^{-t/RC})$$
(3.6)

$$1 - \frac{U(t)}{U_{max}} = e^{-t/RC}$$
(3.7)

$$ln(1 - \frac{U(t)}{U_{max}}) = -t/RC \tag{3.8}$$

$$G = \frac{1}{R} = -\frac{C}{t} \cdot \ln(1 - \frac{U(t)}{U_{max}})$$
(3.9)



Abbildung 3.23: Spezifischer Plasmaleitwert, gebildet durch freie Elektronen im Gap, in Abhängigkeit vom Spannungsanstieg der Lampenspannung

Berücksichtigt man die aktive Entladungsfläche, so ergibt sich der spezifische Leitwert, der von der Steilheit der Spannungsflanke abhängt. Die Ergebnisse für einige Puls- und Sinusanregungen stehen in Tabelle 3.7 und 3.8. In Tabelle 3.7 wurde die Anstiegszeit der Lampenspannung variiert. Wie in Abbildung 3.23 dargestellt, steigt der Leitwert mit zunehmender Anstiegsgeschwindigkeit. In Tabelle 3.8 stehen für verschiedene Sinusund Pulsanregungsformen die zugehörigen Leitwerte. Die Anregungsformen selbst sind bereits in Tabelle 3.6 beschrieben. Bei diesen Pulsen wurde die Anstiegsflanke konstant gehalten und die Pulslänge variiert. Hier ändert sich der relative Leitwert, der durch Elektronen verursacht wird, unwesentlich. Bei der Sinusanregung, bei der die Betriebsfrequenz verändert wurde, ändert sich automatisch die Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung. Die damit verbundene Zunahme der Leitfähigkeit ist ersichtlich.

Zur Bestimmung des Ionenleitwerts wird der Weg über das Ohmsche Gesetz gegangen, wie es bereits in [14] vorgeschlagen wurde. Der durch den Ionenfluss gebildete Leitwert wird alleine aus den Größen Gapspannung nach der Lampenzündung und Plasmastrom abgeschätzt. Bei der Pulsanregung wird davon ausgegangen, dass die Kapazität  $C_{Plasma\,+}$ vor einer Lampenzündung vollständig entladen ist. Für die Sinusanregung

Name	$\sin 1$	$\sin 2$	puls1	puls2	puls3	puls4
Anstiegszeit $[kV/\mu s]$	0,207	0,555	15	15	15	15
$C_{Ion  e}  [\mathrm{pF}]$	160	232	240	258	288	258
$U_C/U$	$0,\!9$	0,9	0,9	$0,\!9$	$0,\!9$	0,9
Ladezeit $C_{Ion e}$ [ns]	600	300	60	60	60	60
$G_{Ion e}/A \ [\mu S/cm^2]$	$5,\!6$	16,3	84,1	90,4	100,9	90,4
$U_{gap}$ nach Zündung [V]	348	320	650	628	581	580
$I_{plas}$ nach Zündung [A]	0,013	0,046	0,29	$0,\!3$	0.27	0,28
Widerstand k $\Omega$	26,8	6,96	2,24	2,09	$2,\!15$	2,07
$G_{Ion+}/A  [\mu S/cm^2]$	0,34	1,31	4,07	4,36	4,24	4,41

**Tabelle 3.8:** Spezifische Plasmaleitwerte für das Lampenmodell in Ab-<br/>hängigkeit von der Anregung; Entladungsfläche: 109,5 cm<sup>2</sup>

wird angenommen, dass die Spannung über  $C_{Plasma\,+}$  über eine Periode mittelwertfrei ist. Damit dies erfüllt ist, darf zum Zündzeitpunkt keine Spannung anliegen, d.h. auch hier kann wie bei der Pulsanregung vorgegangen werden. Aus Tabelle 3.8 ist ersichtlich, dass der spezifische Elektronenleitwert um so größer wird, je steiler die Anstiegsflanke der Lampenspannung ist. Auch der Ionenleitwert nimmt mit der Anstiegsflanke zu. Es ist noch nicht geklärt, ob ein direkter Zusammenhang zwischen Anstiegsflanke und spezifischem Ionenleitwert hergestellt werden kann. Für die Werte in Tabelle 3.7 konnten keine Ionenleitwerte bestimmt werden, da der Spannungspuls zu kurz war und sich kein Strom nach der eigentlichen Lampenzündung ausbilden konnte. Da das Bestimmen der Zusammenhänge zwischen Anstiegsflanke und spezifischen Leitwerten diese Arbeit übersteigt, wurde für das Modell abhängig von der Anregungsart der entsprechende Parametersatz aus den Messungen übernommen.

### Zustandsbedingungen des Lampenmodells

Mit den hier ermittelten Größen kann nun das Modell für die DBE erstellt werden. Es müssen jedoch Übergangsbedingungen definiert werden, so dass eindeutige Kriterien für das Zünden und Erlöschen der Entladung existieren. Für die Zündung gibt es keine direkt messbare Größe, an der man eindeutig die Bedingung für den Lawinendurchbruch erkennen kann. Sowohl die äußere Spannung als auch die Gapspannung können, vor allem bei der Sinusanregung, nach der Zündung nochmals den Wert der Zündspannung erreichen (siehe Abbildung 3.24 (a)). Dennoch kommt es zu keinem weiteren Zündvorgang. Das Problem wird mit Hilfe der Spannung  $U_{Ion\_e}$  gelöst (Abbildung 3.25). Im zeitlichen Verlauf steigt diese Spannung auf einen Maximalwert, der als Zündbedingung festgelegt wird. Ist die Zündbedingung erreicht, steigt der Leitwert an und die Spannung  $U_{Ion\_e}$ bricht ein. Die Kapazität  $C_{Plasma\_e}$  wird um- bzw. aufgeladen. Nach diesem Umlade- bzw. Aufladevorgang wird die Impedanz  $Z_{Ion\_e}$  wieder hochohmig. Trotz eines weiteren Spannungsanstiegs der Lampenspannung wird die Zündbedingung nicht nochmals erreicht.

Das Ablaufdiagramm aus Abbildung 3.26 soll das Modell aus Abbildung 3.25 verdeutlichen:

Bei jedem Schritt der Simulation wird überprüft, ob an der Impedanz  $Z_{Ion\_e}$  eine Zündbedingung erreicht wird. Ist dies der Fall, so steigt der spezifische Elektronenleitwert exponentiell nach folgender Formel auf einen Maximalwert an und sinkt dann wieder gegen Null:

$$Z_{Ion\_e}(t) = \left[ Z_{Ion\_e\ max} \cdot \left( 1 - \exp\frac{t - t0}{\tau 1} \right) + Z_{Ion\_e\ 0} \right] \cdot \exp\frac{t - t0}{\tau 2} \quad (3.10)$$

mit  $\tau 1 = 100$  ns,  $\tau 2 = 1000$  ns und t0 = Zündzeitpunkt<sup>4</sup>

Für die Simulation mit Sinusanregung wird zusätzlich die Impedanz  $Z_{Ion_+}$ , die das Verhalten der Ionen simuliert, über den jeweiligen Schalter S1 und S2 für einen gewissen Zeitraum aktiviert. Dieser Zeitraum ist um den Faktor 10 bis 100 größer als die Zeitkonstante der Elektronenleitung. In diesem Modell wurde davon ausgegangen, dass die Ionen beim Umpolen der äußeren Spannung nicht mehr zurückfließen können. Dieses Verhalten wird mit den Dioden nachgebildet. Inwieweit diese Vorstellung der Realität entspricht wird in weiteren Arbeiten zu klären sein.

Besonders für die Simulation eines Pulses ist es wichtig, dass der Leitwert nach der ersten Zündung sehr schnell wieder gegen null geht. Ist dies nicht der Fall, kann bei der abfallenden Spannungsflanke keine weitere Zündbedingung erreicht werden, da die an der Impedanz  $Z_{Ion_e}$  anliegende Spannung nicht anwachsen kann. Um bei der Pulsanregung nach der

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Diese Werte dienen als Beispiel. Diese müssen auf die individuelle Lampe angeglichen werden.



(b) Pulsanregung

Abbildung 3.24: Innere Größen bei der Simulation einer DBE; blau (1): Lampenspannung; grün (2): Gapspannung; rot (3): Spannung  $U_{Ion e}$  über Plasmaimpedanz  $Z_{Ion e}$ ; schwarz (4): Spannung an der Kapazität  $C_{Plasma e}$ 



Abbildung 3.25: Lampenmodell zu dem Ablaufdiagramm aus Abbildung 3.26

Rückzündung zu gewährleisten, dass die Plasmakapazität  $C_{Plasma\_e}$  vollständig entladen wird, wird der Leitwert erst später auf Null zurückgesetzt. Alternativ zu dem Leitwertverhalten aus Gleichung 3.10 wird für die Pulsanregung folgender Leitwertverlauf vorgeschlagen:

• erste Zündung (Hinzündung): Der Verlauf des Leitwerts wird mit einer Gaußverteilung beschrieben.

$$Z_{Ion\,e}(t) = Leitwert_{max} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{t-t0-u}{s}\right)^2\right) \qquad (3.11)$$

mit  $u = 200 \exp(-9)$ ,  $s = 50 \exp(-9)$  und t0 = Zündzeitpunkt

• zweite Zündung (Rückzündung): Der Verlauf des Leitwerts wird mit einer Planckverteilung beschrieben.

$$Z_{Ion\_e}(t) = Leitwert_{max} \cdot a \cdot \frac{1}{\left(t - t0 + dt\right)^x} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{b}{t - t0 + dt}\right) - 1}$$
(3.12)



Abbildung 3.26: Ablaufdiagramm für das Lampenmodell aus Abbildung 3.25;  $\tau_3=5\mu$  s

mit  $a=\frac{1}{14}\exp(\text{-}17),\,b=10\,\exp(\text{-}7),\,dt=60\,\exp(\text{-}9),\,x=3$ und t0= Zündzeitpunkt

In den Abbildungen 3.27 und 3.28 ist zu sehen, wie gut mit diesem Modell die Wirklichkeit sowohl für die Sinusanregung als auch für die Pulsanregung wiedergegeben werden kann. Der Unterschied zwischen Simulation und realer Messung kommt zu einem Großteil durch das Quellenverhalten der Spannungsversorgung zustande. In den realen Messungen ist hauptsächlich der Stromzufluss während der Zündung begrenzt, so dass bei Zündung die äußere Spannung einbrechen kann. Damit existiert nun ein elektrisches Modell, mit dem unterschiedliche Schaltungstopologien für DBE-Lampen simuliert werden können.



(b) simuliert

Abbildung 3.27: Vergleich: Spannungs- und Stromverläufe einer sinusangeregten DBE Entladung; (a) gemessen; (b) simuliert



Abbildung 3.28: Vergleich: Spannungs- und Stromverläufe einer pulsangeregten DBE Entladung; (a) gemessen; (b) simuliert

# 4 Adaptives Betriebsgerät zur Erzeugung unipolarer Pulse

Für den Schaltungsentwurf eines Betriebsgeräts ist es wichtig, das Verhalten der zu betreibenden Last zu berücksichtigen. Für ein Betriebsgerät für dielektrisch behinderte Entladungslampen stellt die Last während der Lade- und Entladezeit annähernd eine Kapazität dar und während der kurzen Zündphase einen niederohmigen Verbraucher. Das Entladeverhalten der DBE hängt u.a. von der Anstiegszeit der angelegten Lampenspannung und der Pulsdauer ab. Das Betriebsgerät sollte DBE-Lampen mit unterschiedlich großen Flächen, bei gleichbleibendem Gap, betreiben können. Da die Lampenkapazität proprotional zur Lampenfläche ist, bedeutet dies, dass die zu betreibenden Lampen unterschiedlich große Kapazitäten besitzen. Um den optimalen Spannungsanstieg an unterschiedlichen DBEs einstellen zu können, ist es notwendig, dass das Betriebsgerät unterschiedliche Ströme treiben kann. Folgende Punkte muss das geforderte Betriebsgerät erfüllen:

- Das Gerät muss eine Kapazität als Last betreiben können.
- Das Gerät muss einen schnellen Spannungsanstieg (großes  $\frac{dU}{dt}$ ) an der Lampe ermöglichen.
- Der Ladestrom, der die Lampe lädt, muss variabel einstellbar sein.
- Die Pulsdauer muss veränderbar sein. Vor allem für kurze Pulse muss das Gerät geeignet sein.

Das in dieser Arbeit entwickelte Schaltungskonzept wurde von dem ARPI-Konzept (Kapitel 4.1.1) abgeleitet und als eigenständiges Konzept zum Betrieb von DBE-Lampen patentiert [9].



Abbildung 4.1: Schaltplan ARPI Schaltung

# 4.1 Entwicklungsschritte zum adaptiven Betriebsgerät zur Erzeugung unipolarer Pulse

## 4.1.1 Auxiliary Resonant Pole Inverter (ARPI)

Ausgangspunkt für die Entwicklung des adaptiven Betriebsgeräts ist der Auxiliary Resonant Pole Inverter (ARPI) [32] in Abbildung 4.1. Diese Schaltung wurde im Zuge der Entwicklung von neuen Schaltungstopologien (u. a. ARCPI) für ohmsch-induktive Verbraucher oberhalb 100 kW beschrieben. Dabei lag das Augenmerk auf Konzepten, die ein verlustarmes, resonantes Schalten ermöglichen. Für die Anwendung im höheren Leistungsbereich (10 kW aufwärts) mit hohen Strömen wurde diese Schaltung jedoch als "akademisch" bezeichnet und aus Gründen der Unwirtschaftlichkeit wenig beachtet. Die Hauptgründe waren die große Anzahl der Schaltelemente, verbunden mit der aufwändigen Ansteuerung und der Tatsache, dass die resonante Induktivität  $L_r$  ein Element des Leistungspfades ist. Wegen der hohen Ströme im Leistungspfad erzeugt diese Induktivität einen erheblichen Anteil in der Bilanz der Verluste.

Für den Betrieb einer DBE ist dieses Schaltprinzip jedoch geeignet, da die Induktivität kurzzeitig wie eine Stromquelle wirkt. Die Induktivität lädt die Kapazität der DBE mit einem definierten Strom auf, so dass auch die Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs definiert ist. Damit die Induktivität kurzzeitig die Eigenschaft einer Stromquelle besitzt, muss sie geladen werden. Dies geschieht dadurch, dass die Induktivität zwischen den Pluspol und den Minuspol einer Spannungsquelle geschaltet wird. Der Strom, der über die Induktivität fließt, magnetisiert diese auf. Wird die Induktivität nun mit der DBE verbunden, so wirkt sie als Stromquelle und lädt die Kapazität auf. Um die Eigenschaft des Stromquellencharakters der ARPI-Schaltung auszunutzen, kann das ursprüngliche Schaltmuster der ARPI-Schaltung, aus Gründen des Entladeverhaltens, nicht völlig beibehalten werden. Desweiteren entstehen beim Betrieb einer DBE Verluste, die im ursprünglichen Betrieb von ohmsch-induktiven Lasten nicht auftreten.

### 4.1.2 Ladevorgang der DBE

Das Prinzip des Vorladens der Speicherdrossel und anschließendem Laden einer Kapazität bzw. einer DBE entspricht dem Prinzip des Hochsetzstellers und ist als Ersatzschaltbild in Abbildung 4.2 zu sehen. Während des Ladevorgangs der Speicherdrossel befindet sich der Schalter S in Position 1. Hat die Drossel L ausreichend Energie gespeichert, wird der Schalter S in Position 2 gebracht und die Spannung  $U_C$  der Kapazität steigt an. Im Folgenden wird die Spannung  $U_C$  in Abhängigkeit von der Gleichspannung  $U_{DC}$  und dem Drosselstrom  $I_S$  berechnet. Zum Zeitpunkt t = 0 wird der Schalter S von der Stellung 1 auf die Stellung 2 umgeschaltet. Um eine zeitliche Abhängigkeit der Spannung  $U_C$  zu erhalten muss eine Differentialgleichung gelöst werden. Dies geschieht mit Hilfe der Laplace-Transformation. Das Aufstellen der Maschengleichung ergibt:

$$\sigma(t) \cdot U_{DC} = U_L(t) + U_C(t)$$
mit  $\sigma(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ 1 & \text{für } t > 0 \end{cases}$ 

$$(4.1)$$

Für die Kapazität gilt:

$$I = C \cdot \frac{dU_C(t)}{dt} \tag{4.2}$$

Für die Drossel gilt:

$$U_L = L \cdot \frac{dI}{dt} \tag{4.3}$$

Werden Gleichung 4.1 bis 4.3 in den Laplacebereich transformiert, so ergeben sich folgende Gleichungen:



Abbildung 4.2: Ladevorgang einer Kapazität mit geladener Speicherdrossel

$$\frac{1}{s} \cdot U_{DC} = U_L(s) + U_C(s)$$
 (4.4)

$$I(s) = C \cdot (s \cdot U_C(s) - U_C(+0)$$

$$(4.5)$$

$$U_L(s) = L \cdot (s \cdot I(s) - I(+0))$$
(4.6)

mit  $I(+0) = I_S$  und  $U_C(+0) = 0$  V

 $(I_S \text{ ist der Strom, der zum Schaltzeitpunkt durch die Drossel fließt.})$ Einsetzen der Gleichungen 4.5 und 4.6 in 4.4 ergibt:

$$\frac{1}{s} \cdot U_{DC} = \frac{1}{s \cdot C} \cdot I(s) + s \cdot L \cdot I(s) - L \cdot I_S$$

$$\frac{1}{s} \cdot U_{DC} + L \cdot I_S = I(s) \cdot \left(s \cdot L + \frac{1}{s \cdot C}\right)$$

$$I(s) = \frac{\frac{1}{s} \cdot U_{DC} + L \cdot I_S}{s \cdot L + \frac{1}{s \cdot C}}$$

$$I(s) = \frac{U_{DC}}{s^2 \cdot L + \frac{1}{C}} + L \cdot I_S \cdot \frac{1}{s \cdot L + \frac{1}{s \cdot C}}$$

$$I(s) = \frac{U_{DC}}{L} \cdot \frac{1}{s^2 + \frac{1}{L \cdot C}} + L \cdot I_S \cdot \frac{s}{s^2 \cdot L + \frac{1}{C}}$$

$$I(s) = \frac{U_{DC}}{L} \cdot \frac{1}{s^2 + \frac{1}{L \cdot C}} + I_S \cdot \frac{s}{s^2 + \frac{1}{L \cdot C}}$$

$$(4.7)$$



Abbildung 4.3: Ladevorgang einer Kapazität mit Transformator bei geladener Speicherdrossel

Die Rücktransformation in den Zeitbereich ergibt den zeitabhängigen Stromverlauf nach dem Umschalten des Schalters S von Position 1 auf Position 2.

$$I(t) = \frac{U_{DC}}{L} \cdot \sqrt{LC} \cdot \sin \frac{t}{\sqrt{LC}} + I_S \cdot \cos \frac{t}{\sqrt{LC}}$$
(4.8)

Um nun den Spannungsverlauf am Kondensator zu erhalten wird Gleichung 4.8 in Gleichung 4.2 eingesetzt. Man erhält:

$$U_{C}(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{0}^{t} \left( I_{S} \cdot \cos \frac{t}{\sqrt{LC}} + \frac{U_{DC}}{L} \cdot \sqrt{LC} \cdot \sin \frac{t}{\sqrt{LC}} \right) dt$$

$$U_{C}(t) \cdot C = I_{S} \cdot \int_{0}^{t} \cos \frac{t}{\sqrt{LC}} dt + U_{DC} \cdot \frac{\sqrt{LC}}{L} \cdot \int_{0}^{t} \sin \frac{t}{\sqrt{LC}} dt$$

$$U_{C}(t) \cdot C = I_{S} \cdot \left[ \sqrt{LC} \cdot \sin \frac{t}{\sqrt{LC}} \right]_{0}^{t} + U_{DC} \cdot \frac{\sqrt{LC}}{L} \cdot \left[ \sqrt{LC} \cdot \left( -\cos \frac{t}{\sqrt{LC}} \right]_{0}^{t} \right]_{0}^{t}$$

$$U_{C}(t) = I_{S} \cdot \frac{\sqrt{LC}}{C} \cdot \sin \frac{t}{\sqrt{LC}} + U_{DC} \cdot \left( 1 - \cos \frac{t}{\sqrt{LC}} \right)$$

$$(4.9)$$

Um zusätzlich den Einfluss des Übersetzungsverhältnis des Transformators auf die Anstiegszeit der Lampenspannung zu erfassen (Abbildung 4.3), wird nun die sekundärseitige Kapazität der DBE auf die Primärseite des Transformators transformiert. Dabei gilt:

$$C = u^2 \cdot C_{DBE} \tag{4.10}$$

$$U_C = \frac{U_{DBE}}{u} \tag{4.11}$$

Einsetzen der Gleichungen 4.10 und 4.11 in Gleichung 4.9 ergibt:

$$U_C(t) = \frac{U_{DBE}(t)}{u} = I_S \cdot \frac{\sqrt{L \cdot u^2 \cdot C_{DBE}}}{u^2 \cdot C_{DBE}} \cdot \sin \frac{t}{\sqrt{L \cdot u^2 \cdot C_{DBE}}} + U_{DC} \cdot \left(1 - \cos \frac{t}{\sqrt{L \cdot u^2 \cdot C_{DBE}}}\right)$$

$$U_{DBE}(t) = I_S \cdot \sqrt{\frac{L}{C_{DBE}}} \cdot \sin \frac{t}{\sqrt{L \cdot u^2 \cdot C_{DBE}}} + U_{DC} \cdot u \cdot \left(1 - \cos \frac{t}{\sqrt{L \cdot u^2 \cdot C_{DBE}}}\right)$$
(4.12)

Aus Gleichung 4.12 folgt, dass der Spannungsanstieg an der Sekundärseite des Transformators von zwei unabhängigen Mechanismen beeinflusst wird, wenn an der Sekundärseite des Transformators eine Kapazität bzw. eine DBE als Last angeschlossen ist.

- 1. Der Spannungsanstieg wird durch das Vorladen der Speicherdrossel L auf den Schaltstrom  $I_S$  beeinflusst.
- 2. Der Spannungsanstieg wird durch Zuschalten der Zwischenkreisspannung  $U_{DC}$  beeinflusst.

Der Spannungsanstieg ist Teil einer resonanten Schwingung mit der Resonanzfrequenz

$$f_{res} = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L \cdot u^2 \cdot C_{DBE}}} \tag{4.13}$$

Während im zweiten Summand der Gleichung 4.12 - unter Vernachlässigung der Dämpfung - die Amplitude ausschließlich von  $U_{DC}$  und dem Übersetzungsverhältnis u abhängig ist, ist das Maximum des ersten Summands von allen elektrischen Bauelementen  $(L, C_{DBE}, u)$  und dem Schaltstrom  $I_S$  abhängig. Durch Variation des Schaltstroms  $I_S$ , der durch die



(a) Spannungsverlauf an einer (b) Stromverlauf an einer DBE DBE

Abbildung 4.4: Spannungs- und Stromverlauf an einer ungezündeten DBE:  $(\cdots)$  Der Verlauf wird erzeugt durch den Schaltstrom  $I_S$ , der von der Drossel L getrieben wird; (--) Der Verlauf wird erzeugt durch die Spannungsquelle  $U_{DC}$ ; (---) resultierender Verlauf an der DBE

Dauer der Ladezeit bestimmt werden kann, ist also auch die Anstiegszeit der Lampenspannung in gewissen Bereichen variierbar. In Abbildung 4.4 ist beispielhaft der Spannungsverlauf an einer DBE über die Zeit aufgetragen. Mit den Werten aus Tabelle 4.1 wurde der Spannungsverlauf berechnet: Der minimale Spannungsanstieg, der eingestellt werden kann,

$U_{DC}$	$200\mathrm{V}$		
$I_S$	$25\mathrm{A}$		
L	$4\mu\mathrm{H}$		
$C_{DBE}$	$680\mathrm{pF}$		
$u = \frac{n_2}{n_1}$	4		

Tabelle 4.1: Werte für die Berechnung des Spannungsverlaufs

ist durch die Gleichspannung  $U_{DC}$  und die Größen der elektrischen Komponenten vorgegeben. Der Schaltstrom  $I_S$  ermöglicht es, die Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung zu vergrößern. Die Berechnungen wurden für ideale Bauteile durchgeführt. Es wurde keine Dämpfung durch ohmsche Verluste berücksichtigt. Damit hängt die Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung direkt mit den Größen L, u und  $C_{DBE}$  zusammen. Zum Berechnen der maximale Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung wird Gleichung 4.12 zweimal nach der Zeit abgeleitet.

$$\frac{dU_{DBE}(t)}{dt} = I_S \cdot \frac{1}{u \cdot C_{DBE}} \cdot \cos \frac{t}{\sqrt{L \cdot u^2 \cdot C_{DBE}}} + U_{DC} \cdot \frac{1}{\sqrt{L \cdot C_{DBE}}} \cdot \sin \frac{t}{\sqrt{L \cdot u^2 \cdot C_{DBE}}}$$
(4.14)

$$\frac{d^2 U_{DBE}(t)}{dt^2} = I_S \cdot \frac{1}{u^2 \cdot C_{DBE}} \cdot \frac{1}{\sqrt{L \cdot C_{DBE}}} \cdot \left(-\sin\frac{t}{\sqrt{L \cdot u^2 \cdot C_{DBE}}}\right) + U_{DC} \cdot \frac{1}{L \cdot u \cdot C_{DBE}} \cdot \cos\frac{t}{\sqrt{L \cdot u^2 \cdot C_{DBE}}}$$

$$(4.15)$$

Gleichsetzen der Gleichung 4.15 mit null ergibt den Zeitpunkt des maximalen Spannungsanstiegs.

$$t = u \cdot \sqrt{L \cdot C_{DBE}} \cdot \arctan\left(\frac{u \cdot U_{DC}}{I_S} \cdot \sqrt{\frac{C_{DBE}}{L}}\right)$$
(4.16)

Einsetzen der Gleichung 4.16 in Gleichung 4.14 ergibt den maximalen Spannungsanstieg in Abhängigkeit der Geräteparameter.

$$\frac{dU_{DBE}(t)}{dt}max = I_S \cdot \frac{1}{u \cdot C_{DBE}} \cdot cos \left[ arctan \left( \frac{u \cdot U_{DC}}{I_S} \cdot \sqrt{\frac{C_{DBE}}{L}} \right) \right] + U_{DC} \cdot \frac{1}{\sqrt{L \cdot C_{DBE}}} \cdot sin \left[ arctan \left( \frac{u \cdot U_{DC}}{I_S} \cdot \sqrt{\frac{C_{DBE}}{L}} \right) \right]$$

$$(4.17)$$

Der Verlauf der maximalen Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung in Abhängigkeit von dem Schaltstrom  $I_S$  und der Zwischenkreisspannung  $U_{DC}$  ist in Abbildung 4.5 aufgetragen.

### 4.1.3 Adaptives Betriebsgerät für den Rechteckbetrieb -Topologie, Schaltzustände

Wie bereits im vorigen Abschnitt erwähnt, wurde die ARPI Schaltung als Ausgangsschaltung gewählt, da diese Schaltung so betrieben werden kann,



Abbildung 4.5: Maximale Anstiegsgeschwindigkeiten der Lampenspannung in Abhängigkeit von dem Schaltstrom  $I_S$  und der Zwischenkreisspannung  $U_{DC}$ ; L = 4  $\mu$ H; C<sub>DBE</sub> = 680 pF; u = 4

dass sie zeitweise einen Stromquellencharakter aufweist. Mit ihr können Strompulse mit unterschiedlichen Maximalwerten erzeugt werden, die zum schnellen Laden der DBE-Kapazität notwendig sind [20]. Dies wird dadurch realisiert, dass die Speicherdrossel  $L_S$  zwischen den Schaltelementen  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$  und  $S_4$  angeordnet ist (Abbildung 4.6). Werden nun z. B. die Schalter  $S_1$  und  $S_2$  leitend gemacht, so fließt ein Strom über die Drossel  $L_S$ . Die Größe des Stroms I(t) hängt von der Versorgungsspannung , von der Induktivität der Speicherdrossel und von der Zeit während  $S_1$  und  $S_2$  leitend sind ab.

$$I(t) = \int_0^t \frac{1}{L(t)} \cdot U(t)dt + I(t=0)$$
(4.18)

Mit

U(t) = konstant,

L = konstant und

$$I(0) = 0 A$$



Abbildung 4.6: Betriebsgerät für bipolaren Rechteckbetrieb

folgt

$$I(t) = \frac{1}{L} \cdot U \cdot t \tag{4.19}$$

Hat die Drossel den gewünschten Maximalstrom erreicht, so wird der Schalter S<sub>2</sub> nicht leitend gemacht. Der Strom, der von der Drossel getrieben wird, fließt nach dem Schaltvorgang über den Kondensator  $C_{Trenn}$ und den Transformator und lädt die Kapazität der DBE auf. Die Spannung an der Lampe steigt an.

Mit diesem Schaltungsprinzip ist es möglich, allein über die Ladezeit der Speicherdrossel, d.h. über die Zeit in der zwei diagonal liegende Schaltelemente gleichzeitig leiten, die Anstiegszeit der Lampenspannung einzustellen. In Abbildung 4.7 (a) sieht man den Stromverlauf der Speicherdrossel und den Verlauf der Lampenspannung, der mit diesem Schaltkonzept erzeugt werden kann. In Abbildung 4.7 (b) ist das Schaltmuster aufgetragen, mit dem der Spannungsverlauf erzeugt werden kann.

Zur Erläuterung des Schaltmusters werden die einzelnen Schaltphasen des adaptiven Betriebsgeräts für den bipolaren Rechteckbetrieb beschrieben (siehe auch Abbildung 4.8).

a) Schalter  $S_1$  und  $S_2$  sind im leitenden Zustand. Es fließt ein Strom über die Drossel  $L_S$ . Der Strom verhält sich nach Gleichung 4.19.

b) Schalter  $S_2$  wird gesperrt. Der Strom fließt über den Trennkondensator  $C_{Trenn}$  und den Transformator in die Lampe. Dabei wird die Kapazität der DBE geladen. Erfüllt die Lampenspannung die Zündbedingung der


Abbildung 4.7: Schaltzeitpunkte des adaptiven Betriebsgeräts für bipolaren Rechteckbetrieb



Abbildung 4.8: Schaltphasen des adaptiven Betriebsgeräts für bipolaren Rechteckbetrieb

DBE, so entsteht für kurze Zeit ein Plasma im Gasraum der Lampe. Dabei muss das Übersetzungsverhältnis des Transformators so ausgelegt sein, dass die Zündbedingung an der Lampe erreicht wird, bevor an S<sub>2</sub> das Potential der Versorgungsspannung U anliegt. Tritt letzterer Fall ein, so wird die Primärseite des Transformators über die Inversdiode des Schalters S<sub>3</sub> auf die Versorgungsspannung geklemmt. Die Lampenspannung kann nicht weiter ansteigen und die Zündspannung der DBE wird nicht erreicht.

c) Überschreitet das Potential an  $S_2$  die Versorgungsspannung U, so wird die Inversdiode des Schalters  $S_3$  leitend. Solange der Schalter  $S_1$  nicht geschlossen wird, fließt ein Kreisstrom, der durch die Drossel  $L_S$ , die noch Restenergie gespeichert hat, getrieben wird.

d) Um die Verluste möglichst gering zu halten und die Restenergie der Speicherdrossel in die Spannungsversorgung zurückzuspeisen, muss der Schalter  $S_1$  schnell geöffnet werden. Der Drosselstrom kommutiert auf die Inversdiode des Schalters  $S_4$ . Die Energie, die noch in der Drossel gespeichert ist, wird in den Zwischenkreis zurückgespeist. Dabei kommt der Drosselstrom zum Erliegen. Betrachtet man den Stromverlauf der Drossel in Abbildung 4.7 (a), so sieht man, dass nach dem dreieckförmigen Stromverlauf ein Strom in die entgegengesetzte Richtung fließt. Das Auftreten dieses Stroms wird hervorgerufen durch das Sperrverhalten der Inversdiode  $S_4$  [12]. Damit diese sperren kann, muss die Sperrverzögerungsladung aus der Raumladungszone der Diode fließen. Durch diesen Stromfluss wird die Drossel nochmals aufgeladen. Die Drossel treibt einen Strom über die Inversdiode von  $S_1$  und den Schalter  $S_3$ , in die entgegengesetzte Richtung.

e) Da mit dieser Schaltung ein bipolarer Rechteckbetrieb realisiert werden soll, ist es notwendig die Primärseite des Transformators auf das Potential der Versorgungsspannung zu klemmen. Dazu muss der Schalter S<sub>3</sub> geschlossen werden, solange dessen zugehörige Inversdiode noch im leitenden Zustand ist. Dieser Schaltvorgang ist nahezu verlustfrei, da er unter ZVS-Bedingung erfolgt. Die zulässige maximale Dauer der angelegten Spannung wird durch den Kern des Transformators und die Windungszahl der Primärseite bestimmt. Ist das Spannung-Zeit-Produkt an der Primärseite zu groß, so gerät der Transformatorkern in Sättigung.

Ist die gewünschte Zeit, in der die positive Spannung an der Lampe angelegt ist, verstrichen, wird der Umpolvorgang eingeleitet. Dazu wird der Schalter S<sub>4</sub> geschlossen (ZCS). Der Strom über die Drossel L<sub>S</sub> beginnt linear anzusteigen, bis ausreichend Energie für den folgenden Umladevorgang in der Drossel gespeichert ist. f) Sobald der Schalter  $S_3$  geöffnet wird, wird die Lampenspannung in einer definierten Zeit auf die negative Spannung umgepolt. Die Umladezeit ist abhängig von dem maximalen Drosselstrom, der Lampenkapazität und der angelegten Versorgungsspannung. Während dieses Umladevorgangs erfolgt die zweite Zündung der DBE innerhalb einer Periode.

g) Ist die DBE vollständig umgeladen, treibt die Speicherdrossel weiterhin einen Strom. Dadurch baut sich an der Inversdiode des Schalters  $S_2$ eine positive Spannung in Flussrichtung auf. Nach Erreichen der Diodenspannung wird diese leitend und es entsteht wiederum ein Kreisstrom wie in c), jedoch in der unteren Masche der Schaltung. Auch dieser Kreisstrom ist unerwünscht.

h) Um den Kreisstrom zu unterbinden, wird der Schalter  $S_4$  so bald wie möglich geöffnet. Der Drosselstrom kommutiert auf die Inversdiode des Schalters  $S_1$ . Die restliche Energie, die in der Drossel gespeichert ist, wird in die Versorgung zurückgespeist. Damit die Lampenspannung negativ bleibt und kein Schwingen aufkommt, wird während des kleiner werdenden Drosselstroms der Schalter  $S_2$  geschlossen. Dieser Zustand ist wiederum durch die Spannungs-Zeit-Fläche über dem Transformator zeitlich begrenzt. Auch hier entsteht ein Kreisstrom über L,  $S_2$  und die Inversdiode von  $S_4$ . Um den nächsten Umladevorgang der DBE einzuleiten wird der Schalter  $S_1$  geschlossen (a)) und die Speicherdrossel  $L_S$  wird geladen.

## 4.2 Adaptives Betriebsgerät zur Erzeugung unipolarer Pulse

### 4.2.1 Rückzündung

Mit dem in Kapitel 4.1.3 vorgestellten Betriebsgerät wurden erste Messungen an dielektrisch behinderten Entladungslampen gemacht, um das Verhalten solcher Entladungslampen kennenzulernen. Aufgrund mehrerer Veröffentlichungen [24], [17], [18] wurde vor allem auf den Einfluss der Pulslänge auf das Entladeverhalten geachtet. Verglichen mit einem Rechteckbetrieb mit einem Tastverhältnis von 50% und einer Betriebsfrequenz von 40 kHz erhöhte sich der Lampenwirkungsgrad bei einer Pulslänge im Bereich von 500 ns bis ca.  $4 \,\mu$ s und einer Betriebsfrequenz im Bereich von 1 kHz bis ca. 60 kHz um einen Faktor von bis zu 1,6. In [31] wurde der Zusammenhang zwischen Pulslänge, Lampenleistung, Leuchtdichte



<sup>(</sup>c) Duty-Cycle: 50%

Abbildung 4.9: Bipolarer Rechteckbetrieb: Variation des Duty-Cycles zum Betrieb einer DBE; Betriebsfrequenz: 40 kHz



Abbildung 4.10: Leistungseinkopplung in Abhängigkeit von der Pulslänge; oben: Spannung; unten: Leistung

und Lampeneffizienz untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass der Lampenwirkungsgrad bei gleichbleibender Betriebsfrequenz maßgeblich erhöht werden kann, wenn die Pulslänge verkürzt wird. Bei hinreichend kurzen Pulsen kann bei der abfallenden Spannungsflanke ein weiteres Mal Leistung in die Lampe eingekoppelt werden. Dies ist in Abbildung 4.10 in zwei Spannungspulsen mit gleicher Anstiegsflanke und unterschiedlichen Pulslängen zu sehen. Während bei dem langen Puls nur während des Spannungsanstiegs Energie in die Lampe eingekoppelt wird, wird bei dem kurzen Puls zusätzlich am Ende des Pulses Energie eingekoppelt. Zur Erzeugung kurzer Pulse sind vier Schalter nicht notwendig. Das bisher vorgestellte Betriebsgerät wurde um zwei aktive Schalter und deren dazugehörige Beschaltung reduziert. Zusätzlich kann das Kernvolumen des Transformators aufgrund der reduzierten Spannungs-Zeit-Fläche um ca. 80% reduziert werden (PM74 auf ETD39). Es entsteht ein Schaltkonzept mit zwei unterschiedlichen Rückspeisekonzepten.

Das erste Konzept ist in Abbildung 4.11 abgebildet. Die dazugehörigen Schaltphasen sind identisch zu den Schritten a) bis d) der Abbildung 4.8



Abbildung 4.11: Betriebsgerät für unipolare Pulse mit Rückspeisediode

des bipolaren Rechteckbetriebs.

- Die Speicherdrossel  $L_S$  wird geladen, indem die beiden MOSFET-Schalter  $S_1$  und  $S_2$  geschlossen werden (Punkt a).
- Schalter S<sub>2</sub> wird geöffnet. Der Strom, den die Speicherdrossel in die DBE treibt, lädt die Kapazität der DBE und die Spannung steigt (Punkt b).
- Erreicht das Potential an Punkt  $P_1$  das der Zwischenkreisspannung U, so wird die Diode  $D_5$  leitend. Es beginnt ein verlustbehafteter Kreisstrom zu fließen (Punkt c).
- Der Kreisstrom endet, wenn die Drossel keinen Strom mehr treiben kann, oder wenn der Schalter  $S_1$  geöffnet wird (Punkt d). Ist dies der Fall, treibt die Drossel  $L_S$  einen Strom über die Dioden  $D_2$  und  $D_5$ , der die restlich gespeicherte Energie in die Spannungsquelle U zurückspeist.

Im Unterschied zum bipolaren Rechteckbetrieb ändert sich ab diesem Zeitpunkt das Schaltmuster. Die Spannung, die an der Primärseite des Transformators anliegt, ist nicht mit der Versorgungsspannung verbunden. Da die Hauptinduktivität des Transformators weiterhin einen Strom treibt, wird die Spannung an der Primärseite des Transformators reduziert. Wenn lange genug gewartet wird, hat sich die gesamte Energie, die noch in der DBE gespeichert ist, im EVG ausgebreitet und wandelt sich an den elektrischen Komponenten in Wärme um. Eine ausführliche Beschreibung ist



Abbildung 4.12: Betriebsgerät für unipolare Pulse mit resonanter Rückspeisung

in Kapitel 4.2.2 zu finden. Wird der Schalter  $S_2$  eingeschaltet, solange noch ausreichend Spannung an der DBE anliegt, so kann ohne zusätzliches Zuführen von Energie eine weitere Zündung in der DBE initiiert werden<sup>1</sup>. Leider kann mit diesem Schaltmuster keine ungenutzte Energie in die Zwischenkreisspannung zurückgespeist werden. Zusätzlich muss die Zwischenkreisspannung so hoch sein, dass die Zündspannung an der DBE erreicht wird. Andernfalls kommt es nicht zur Zündung der DBE.

Das zweite Konzept nutzt die Diode  $D_1$  parallel zum MOSFETS<sub>1</sub> (Abbildung 4.12). Hier wird die Energie, die auf der DBE gespeichert ist und für die Entladung nicht genutzt werden kann, in einem resonanten Umschwingvorgang in die Versorgung zurückgespeist. Erst wenn dieser Vorgang beendet ist, wird der Schalter S<sub>2</sub> geschlossen und die restliche Energie, die sich noch auf der Kapazität der DBE befindet, wird entladen. Hier sind die ersten zwei Schaltphasen identisch zu denen der zuvor beschriebenen Schaltungskonzepten:

- Die Speicherdrossel  $L_S$  wird geladen, indem die beiden MOSFET-Schalter  $S_1$  und  $S_2$  geschlossen werden (Punkt a).
- Schalter S<sub>2</sub> wird geöffnet. Der Strom, den die Speicherdrossel nun in die DBE treibt, lädt die Kapazität der DBE und die Spannung steigt (Punkt b).
- Die Spannung an der DBE steigt auf Grund des LC-Kreises (Spei-

 $<sup>^{1}</sup>$ Dieser Effekt und sein physikalischer Hintergrund wird in einer separaten Dissertation beschrieben, die durch die Ergebnisse dieser Arbeit ermöglicht wurde.

cherdrossel - Lampenkapazität) auf einen Maximalwert (Resonanzüberhöhung) und schwingt dann zurück. Dadurch wird ein Teil der nicht benötigten Energie, die auf der DBE gespeichert ist, in die Versorgung zurückgespeist.

- Unter Umständen kann der Schalter  $S_1$  unter ZVS-Bedingung ausgeschaltet werden. Dies ist dann der Fall, wenn der MOSFET erst beim Zurückschwingen des Stroms geöffnet wird. In diesem Fall übernimmt die Diode  $D_1$  die Stromführung und es entstehen nur geringe Verluste beim Ausschalten von  $S_1$ .
- Um die bereits oben erwähnte Rückzündung zu erreichen, wird der Schalter  $S_2$  geschlossen.

## 4.2.2 Berechnung der Schaltzustände

Die Topologie aus Abbildung 4.12 erwies sich als das aussichtsreichste Prinzip in Hinsicht auf den elektrischen Wirkungsgrad, die Lampeneffizienz und den Schalteraufwand. Um vor der Simulation der Schaltung bereits die kritischen und verlustbehafteten Schaltzustände kennenzulernen, werden die Differenzialgleichungen für die einzelnen Schaltzustände aufgestellt. Das Ziel ist es, für die wesentlichen elektrischen Komponenten die Differenzialgleichungen zu lösen, ohne den elektrischen Bauteilen feste Werte zuzuweisen. Dadurch ist es möglich, bereits im Vorfeld den Zusammenhang zwischen Zwischenkreisspannung, Ladestrom, Zündspannung, Resonanzfrequenz usw. zu begreifen. Je nach Startbedingung und Anzahl der Bauteile, die beteiligt sind, ist die allgemeine Lösung über die Laplacetransformation nicht möglich. Um dennoch eine allgemeine Lösung zu erhalten, wird der zu berechnende Kreis auf die wesentlichen Elemente so stark reduziert, dass wieder eine allgemeine Lösung berechnet werden kann. Das elektrische Modell der DBE, das in Kapitel 3 aufgestellt wurde, ist hierbei hilfreich.

#### Unterteilung der Schaltzyklen

Eine Periode des Pulsgeräts wird in folgende Schaltzyklen unterteilt:

1. Ladephase der Drossel



Abbildung 4.13: Ersatzschaltbild: Ladephase der Drossel

- 2. Ladephase der DBE
- 3. Zündung der DBE
- 4. Rückschwingen und Rückzündung
- 5. Entmagnetisierung der induktiven Bauelemente
- 6. Ruhephase

Für die einzelnen Phasen werden Ersatzschaltbilder erstellt und damit die Differentialgleichungen aufgestellt:

#### Ladephase der Drossel

In Abbildung 4.13 sind nur die Komponenten des Betriebsgeräts dargestellt, die in der ersten Schaltphase beteiligt sind. Mit der Annahme, dass die Leitendwiderstände der Schalter vernachlässigbar sind, ist nur die Spannungsquelle und die Drossel in der ersten Schaltphase beteiligt. Dadurch beschränken sich die Gleichungen auf die Drosselgleichung

$$U_L = U_{DC} = L \cdot \frac{dI}{dt} \tag{4.20}$$

$$I_L = \frac{1}{L} \cdot \int_0^{T_{load}} U_{DC} dt \qquad (4.21)$$

Wird die Spannungsquelle durch eine Kapazität ersetzt, wie es in der Realität ist, so wird das Berechnen des Drosselstroms bereits um einiges aufwändiger. Nach Aufstellen der Knoten- und Maschengleichungen

$$-I_C(t) = I_L(t) \tag{4.22}$$

$$U_C(t) = U_L(t) \tag{4.23}$$

$$U_L(t) = L \cdot \dot{I}_L(t) \tag{4.24}$$

$$I_C(t) = C \cdot \dot{U}_C(t) \tag{4.25}$$

werden die Gleichungen nach dem Transformieren in den Laplacebereich gelöst.

$$-I_C(s) = I_L(s) \tag{4.26}$$

$$U_C(s) = U_L(s) \tag{4.27}$$

$$U_L(s) = L \cdot (s \cdot I_L(s) - I_L(+0)) \text{ mit } I_L(+0) = 0 A$$
(4.28)

$$I_C(s) = C \cdot (s \cdot U_C(s) - U_C(+0))$$
(4.29)

Einsetzen von Gleichungen 4.28 und 4.29 in 4.26 unter Berücksichtigung von 4.27 ergibt:

$$-C \cdot (s \cdot U_C - U_C(+0)) = \frac{1}{L} \cdot U_C \cdot \frac{1}{s}$$
(4.30)

$$U_C \cdot \left(s \cdot C + \frac{1}{s \cdot L}\right) = C \cdot U_C(+0) \tag{4.31}$$

$$U_C = U_{C(+0)} \cdot \frac{s}{s^2 + \frac{1}{LC}}$$
(4.32)

Damit ergibt sich das zeitliche Verhalten der Spannung am Kondensator zu:

$$U_C(t) = U_C(+0) \cdot \cos(\sqrt{\frac{1}{LC}} \cdot t)$$
(4.33)

Einsetzen von 4.33 in 4.25 und Auflösen ergibt den zeitabhängigen Strom, der während der Ladephase durch die Drossel fließt:

$$I_L = U_C(+0) \cdot \sqrt{\frac{C}{L}} \cdot \sin(\sqrt{\frac{1}{LC}} \cdot t)$$
(4.34)

Somit ist das zeitabhängige Verhalten der beteiligten Bauteile während der ersten Schaltphase bestimmt. Der Widerstand, der zum Beispiel durch Leitungen und den Schalter  $S_2$  gebildet wird, wird hier nicht berücksichtigt, da er keine wesentliche Veränderung des Stromverlaufs bewirkt.



Abbildung 4.14: Ladephase der DBE

#### Ladephase der DBE

Hat die Drossel ausreichend Energie gespeichert bzw. fließt der gewünschte Maximalstrom  $I_L(+0)$  durch die Drossel, so wird der Schalter S<sub>2</sub> nicht leitend gemacht und es beginnt die Ladephase der DBE. Die wesentlichen Komponenten für diese Schaltphase sind in Abbildung 4.14 dargestellt. Dabei spielen nicht nur die Speicherdrossel L und die Kapazität der DBEeine Rolle, sondern auch die Haupt- und Streuinduktivitäten des Transformators und die Kapazität des Schalters S<sub>2</sub>. Bei näherer Betrachtung dieser Schaltphase stellt sich heraus, dass diese nochmals in zwei Phasen unterteilt werden muss.

- 1. Ausschaltvorgang des Schalters  $S_2$  bzw. des MOSFETs
- 2. Spannungsanstieg an der DBE

Ausschaltvorgang des Schalters S<sub>2</sub>: Um eine allgemeine Lösung für diesen Vorgang zu erhalten, werden nur die wesentlichen Komponenten aus Abbildung 4.14 berücksichtigt. Es handelt sich um die Spannungsquelle  $U_{DC}$ , die Ladedrossel L, die Kapazität  $C_{S2}$  des Schalters S<sub>2</sub> und eine Induktivität  $L_{Tr}$ , die die Hauptinduktivität und die Streuinduktivitäten des Transformators kombiniert wiedergibt (Abbildung 4.15). Die Kapazitäten des Trennkondensators und der DBE werden hier vernachlässigt, da sie während dieses Zeitabschnitts Kurzschlüsse darstellen. Die Induktivität  $L_{Tr}$  entspricht etwa der Summe der beiden Streuinduktivitäten. Nach Aufstellen der Maschen- und Knotengleichungen für dieses



Abbildung 4.15: Ersatzschaltbild für den Ausschaltvorgang des Schalters  $\mathrm{S}_2$ 

Ersatzschaltbild ergibt sich folgende Formel für das Spannungsverhalten am Kondensator  $C_{S2}$ :

$$U_C = \frac{I_L(+0)}{C \cdot \omega} \cdot \sin \omega t + \frac{U_{DC}}{L \cdot C \cdot \omega^2} \cdot (1 - \cos \omega t)$$
(4.35)

$$U_C = I_L(+0) \sqrt{\frac{L \cdot L_{Tr}}{C \cdot (L + L_{Tr})}} \cdot \sin \omega t + U_{DC} \frac{L_{Tr}}{L + L_{Tr}} \cdot (1 - \cos \omega t)$$

$$(4.36)$$

mit 
$$\omega^2 = \frac{L + L_{Tr}}{L \cdot L_{Tr} \cdot C}$$

Mit dieser Formel, die in Kapitel A.1 hergeleitet wird, wird der Spannungsanstieg am Schalter S<sub>2</sub> beschrieben. Vergleicht man Gleichung 4.36 mit Gleichung 4.9, so sieht man, dass sie sich bis auf die Berechnung der resultierenden Induktivität gleichen. Auch der Verlauf der Spannung an der Kapazität C<sub>S2</sub> besteht aus zwei Summanden, von denen der eine vom Schaltstrom  $I_L(+0)$  abhängt und der andere von der Versorgungsspannung  $U_{DC}$ . Folgende Werte wurden in die Gleichung 4.36 eingesetzt:

- $I_L(+0)$  (Drosselstrom zu Beginn des Ausschaltvorgangs) = 30 A
- $U_{DC} = 400 V$



Abbildung 4.16: Spannungsverlauf am Schalter S<sub>2</sub>:  $I_L(0+) = 30 \text{ A}$ ;  $U_{DC} = 400 \text{ V}$ ;  $C_{S2} = 70 \text{ pF}$ ;  $L = 4 \mu \text{H}$ ;  $L_{Tr} = 2 \mu \text{H}$ 

- $C_{S2}$  (Kapazität des Schalters): ca. 70 pF bei 400 V Drain-Source-Spannung (Infineon SPW20N60C3)
- L (Induktivität der Speicherdrossel) =  $4 \,\mu \text{H}$
- $L_{Tr}$  (Gesamtinduktivität des Transformators von der Primärseite gesehen) = 2  $\mu$ H

Durch die sehr kleine Kapazität des MOSFETs, der sich an der Stelle von  $S_2$  befindet, gerät die vorläufige Resonanzfrequenz an diesem Bauteil in den MHz-Bereich. Mit den oben genannten Werten ergibt sich eine Resonanzfrequenz von 16,5 MHz, d.h. nach Ausschalten des Schalters  $S_2$  liegt nach ca. 15 ns maximale Spannung an. Diese Anstiegsgeschwindigkeit muss mit geeigneten Maßnahmen verringert werden, so dass der Schalter nicht im kritischen Bereich betrieben wird. Dies wird hier mit einer weiteren Kapazität parallel zum Schalter  $S_2$  gemacht. In Abbildung 4.16 ist der Spannungsverlauf an der Kapazität  $C_{S2}$  über der Zeit aufgetragen, der nach Formel 4.36 berechnet wurde. Sowohl die Anstiegsgeschwindigkeit als auch die Maximalspannung sind kritische Werte, die für die weitere Auslegung des Schaltungskonzepts berücksichtigt werden müssen.



Abbildung 4.17: Ersatzschaltbild für die Ladephase der DBE

**Spannungsanstieg an der DBE:** Zur Berechnung des allgemeinen Verhaltens der Spannung an der DBE wird nun wieder ein Ersatzschaltbild (Abbildung 4.17) mit den wichtigsten Komponenten benutzt. Hier werden nur die Speicherdrossel, die Hauptinduktivität des Transformators und die Kapazität der DBE berücksichtigt. Sowohl die elektrischen Komponenten als auch die Anordnung entsprechen der im letzten Absatz beschriebenen Problematik, so dass für den Verlauf der Spannung an der DBE Gleichung 4.36 benutzt werden kann.

$$U_C = I_L(+0) \sqrt{\frac{L \cdot L_M}{C \cdot (L + L_M)}} \cdot \sin \omega t + U_{DC} \frac{L_M}{L + L_M} \cdot (1 - \cos \omega t)$$

$$(4.37)$$

mit 
$$\omega^2 = \frac{L + L_M}{L \cdot L_M \cdot C}$$

Die Bauteile besitzen hier jedoch andere Größen:

- $I_L(+0)$  (Drosselstrom zu Beginn des Ladevorgangs der DBE) = 30 A
- $U_{DC} = 400 V$
- C (Kapazität der DBE, multipliziert mit dem Übersetzungsverhältnis des Transformators zum Quadrat) =  $600 \,\mathrm{pF} \cdot 4^2 = 9.6 \,\mathrm{nF}$
- L (Induktivität der Speicherdrossel):  $4\,\mu\mathrm{H}$
- L<sub>M</sub> (Hauptinduktivität des Transformators von der Primärseite gesehen) =  $300 \,\mu\text{H}$

Für die Ströme  $I_L$ ,  $I_M$ ,  $I_C$  (Herleitung: Kapitel A.1) ergeben sich folgende zeitliche Abhängigkeiten:

$$I_M(t) = t \cdot \frac{U_{DC}}{L + L_M} - \frac{U_{DC}}{L + L_M} \cdot \frac{1}{\omega} \cdot \sin \omega t + I_L(+0) \cdot \frac{L}{L + L_M} \cdot (1 - \cos \omega t)$$

$$(4.38)$$

$$I_C(t) = I_L(+0) \cdot \cos \omega t + \frac{U_{DC}}{L} \cdot \frac{1}{\omega} \cdot \sin \omega t$$

$$I_L(t) = I_M + I_C$$
(4.39)

$$L(t) = I_M + I_C$$
  
=  $t \cdot \frac{U_{DC}}{L + L_M} + U_{DC} \cdot \frac{1}{\omega} \cdot \frac{L_M}{L \cdot (L + L_M)} \cdot \sin \omega t$   
+  $I_L(+0) \cdot \frac{L}{L + L_M} \cdot (1 - \cos \omega t) + I_L(+0) \cdot \cos \omega t$  (4.40)

mit 
$$\omega = \sqrt{\frac{L + L_M}{C \cdot L \cdot L_M}}$$

Folgende Ergebnisse sind in den Gleichungen 4.37 bis 4.40 enthalten:

- Der Vorladestrom  $I_L(+0)$  beschleunigt den Spannungsanstieg an der Kapazität bzw. der DBE.
- Die maximal erreichbare Spannung an der Kapazität C hängt von dem Vorladestrom  $I_L(+0)$  ab.
- Das Vorladen der Speicherdrossel ermöglicht es, mit diesem Schaltprinzip für unterschiedlich große Kapazitäten den gleichen Spannungsanstieg einzustellen.
- Es wird Energie in der Hauptinduktivität des Transformators gespeichert. Diese Energie muss bei der Betrachtung der Verluste berücksichtigt werden.

Die zeitlich abhängigen Spannungs- und Stromverläufe sind in Abbildung 4.18 dargestellt. Hierbei handelt es sich um den Spannungsverlauf an einer Kapazität bzw. an einer nicht gezündeten DBE. Kommt es zur Zündung, so hat sowohl Spannung als auch Strom einen anderen zeitlichen Verlauf. Der Spannungsverlauf an der Kapazität ist auf die Primärseite des Transformators bezogen. Um die sekundärseitige Spannung zu erhalten, müssen die Werte mit dem Übersetzungsverhältnis des Transformators multipliziert werden. Dasselbe gilt für den Strom, der in die Kapazität fließt. Um die sekundärseitigen Stromwerte zu erhalten, müssen die Werte von  $I_C$  durch das Übersetzungsverhältnis geteilt werden. Die Dämpfung durch ohmsche Verluste wurde nicht berücksichtigt.

#### Zündung der DBE

Hat die Spannung an der DBE die Zündbedingung erreicht, so entsteht ein Plasma im Gap der DBE. Ausgehend von dem Modell aus Kapitel 3, entspricht das aktuelle Ersatzschaltbild Abbildung 4.19 (a). Unter Vernachlässigung des Trennkondensators  $C_{trenn}$ , der Streuinduktivitäten und des idealen Transformators ergibt sich das Ersatzschaltbild aus Abbildung 4.19 (b). Für die allgemeine Lösbarkeit werden zusätzlich die Wandkapazität der DBE und der Plasmawiderstand vernachlässigt. Dies bedeutet eine Abweichung der berechneten Lösung von der Realität, zeigt aber dennoch das prinzipielle Verhalten der Schaltung beim Zünden der DBE auf. Nach Auflösen der Maschen- und Knotengleichungen ergibt sich folgender Ausdruck für den Entladestrom  $I_P$ , die in Kapitel A.2 hergeleitet wird:

$$I_P(t) = U_G(+0) \cdot \frac{C_G \cdot C_P}{(C_G + C_P)} \cdot \delta(t)$$
  

$$- U_G(+0) \cdot \frac{C_G \cdot C_P}{(C_G + C_P)} \cdot \omega \cdot \sin \omega t$$
  

$$+ (I_L(+0) - I_M(+0)) \cdot \frac{C_P}{(C_G + C_P)} \cdot \cos \omega t$$
  

$$+ U_{DC} \cdot \frac{1}{L} \cdot \frac{C_P}{(C_G + C_P)} \cdot \frac{1}{\omega} \cdot \sin \omega t$$
  
mit  $\omega = \sqrt{\frac{L + L_M}{L \cdot L_M}} \cdot \frac{1}{C_G + C_P}$   
(4.41)

Gleichung 4.41 unterteilt sich in vier Mechanismen:

1. Umladevorgang von Ladungsträgern aus der Gap-Kapazität  $C_G$  in die Plasmakapazität. Der Umladevorgang dauert so lange bis das Potentialgefälle zwischen  $U_G$  und  $U_P$  zu null geworden ist. Dieser Stromanteil ist wichtig für die Entladung, da er sehr schnell fließt



(b) Stromverläufe für  $I_L$  und  $I_C$  (linke Achse);  $I_{LM}$  (rechte Achse)

Abbildung 4.18: Berechnete Spannungs- und Stromverläufe während der Ladephase einer nicht gezündeten DBE;  $U_{DC} =$  $400 \text{ V}; I_L(0) = 30 \text{ A};$  $L = 4 \,\mu\text{H}; L_M = 300 \,\mu\text{H}; C_{DBE} = 600 \,\text{pF};$  ü-Trafo: 4:1



Abbildung 4.19: Ersatzschaltbilder der Zündphase

und unter allen Strömen die größte Amplitude aufweist. Der Maximalwert des Umladestroms hängt von der Leitfähigkeit des Plasmas ab. Da in der Berechnung der Widerstandswert zu null Ohm angenommen wurde, ist der Umladevorgang hier ein Dirac-Impuls, d.h. die Amplitude dieses Stromanteils kann mit dieser Gleichung nicht angegeben werden. Der Umladestrom aus der Gapkapazität  $C_G$  in die Plasmakapazität  $C_P$  mit dem Widerstand  $R_P$  würde sich wie in folgender Formel verhalten:

$$I_P(t) = \frac{U_G(+0)}{R_P} \cdot e^{-\frac{C_G + C_P}{R_P \cdot C_G \cdot C_P} \cdot t}$$

- 2. Entladen bzw. Umladen der Lampenkapazität (hier:  $C_G$  und  $C_P$ ) über die Induktivitäten L und  $L_M$ .
- 3. Stromanteil, der von der Drossel L zum Zündzeitpunkt geliefert wird. Dabei trägt nicht der gesamte Strom, der von der Drossel L getrieben wird, zur Entladung bei. Der Drosselstrom wird zum einen durch den Strom der Hauptinduktivität des Transformators reduziert, zum anderen teilt sich der Anteil des Stroms, der in die Lampe fließt, auf. Ein Teil fließt in die Gapkapazität, der andere in die Plasmakapazität bzw. in die Entladung.
- 4. Stromanteil, der durch die Spannungsversorgung  $U_{DC}$  geliefert wird: Dieser Stromanteil hat zum Zündzeitpunkt den Wert Null und wächst sinusförmig mit der Eigenfrequenz  $\omega$  an, da der Strom durch die Speicherdrossel L und die Streuinduktivitäten des Transformators gehemmt wird. Da, wie in Kapitel 3 beschrieben, die Entladung im Bereich von 60 ns bis 100 ns stattfindet, kann dieser Stromanteil keinen wesentlichen Anteil zum Entladestrom beitragen.

Die Formel für den Plasmastrom ist nur eine grobe Näherung, um zu verstehen welche Mechanismen in der Lage sind, die Entladung zu unterstützen bzw. zu fördern. Da die Plasmakapazität  $C_P$  eine dynamische Größe ist (Kapitel 3) und Werte im Bereich von 0 F bis ca.  $5 \cdot C_G$  durchläuft, können die berechneten Ströme und Frequenzen nur grobe Anhaltspunkte für die wirklichen Größen sein.



Abbildung 4.20: Ersatzschaltbilder der zweiten Zündphase (Rückzündung)

#### Rückschwingen und Rückzündung

Nachdem die Lampe gezündet hat, wird der Schalter  $S_1$  aus Abbildung 4.12 geöffnet, so dass die Primärseite des Transformators von der Spannungsquelle getrennt ist. Durch den Strom  $I_M$  (Abbildung 4.19 (b)), der weiterhin von der Hauptinduktivität des Transformators getrieben wird, wird die Kapazität der DBE umgeladen. Wird kein weiterer Schaltvorgang vorgenommen, so sinkt die Lampenspannung mit einer nicht allzu steilen Flanke auf null Volt. Das Plasma kann nicht nochmals zünden und der Schaltzyklus ist nach dem Ausschwingen beendet.

Wird Schalter  $S_2$  nach einer gewissen Zeit (im Bereich von 500 ns bis 3  $\mu$ s) nach der ersten Zündung geschlossen, so wird die Kapazität hauptsächlich über die Streuinduktivität L<sub>Streu1</sub> und den Schalter S<sub>2</sub> umgeladen, da diese Induktivität (ca. 1  $\mu$ H) viel kleiner ist als die Hauptinduktivität (ca. 300  $\mu$ H). Dauert dieser Umladeprozess nicht allzu lange, d.h. ist die zeitliche Spannungsänderung groß genug, so zündet die Lampe ein weiteres Mal. Das Ersatzschaltbild für den beschriebenen Vorgang ist in Abbildung 4.20 (a) und (b) zu sehen. Mathematisch wird der Umschwingvorgang durch folgende Formel beschrieben, die prinzipiell Gleichung 4.34 entspricht:

$$I_{Streu1} = U_{DBE}(+0) \cdot \frac{1}{u} \cdot \sqrt{\frac{C_{DBE} \cdot u^2}{L_{Streu1} + L_{Streu2}}}}{\sqrt{\frac{1}{(L_{Streu1} + L_{Streu2}) \cdot C_{DBE} \cdot u^2}} \cdot t}$$

$$(4.42)$$

Dabei wird der Strom, der von der Hauptinduktivität getrieben wird, vernachlässigt. Die maximale negative Spannung, die an der DBE nach dem Umschwingvorgang kurzzeitig anliegt, hängt davon ab, wie stark der Kreis gedämpft ist. Wird die Bedingung für die Rückzündung erreicht<sup>2</sup>, erfolgt wie im vorigen Abschnitt beschrieben eine weitere Lampenzündung. Dabei ist nun die Plasmakapazität geladen und kann sich durch den Zündvorgang wieder entladen. Dieser Zündvorgang bringt einen weiteren Stromimpuls. Da jedoch Induktivitäten im Entladekreis liegen, die eine sprunghafte Stromänderung verhindern, wird der mögliche Maximalwert des Strompulses begrenzt.

 $<sup>^2 \</sup>rm Die$ Bedingung für eine Rückzündung ist bis jetzt noch nicht vollständig erforscht und wird Aufgabe weiterer Untersuchungen sein.

#### Entmagnetisierung der induktiven Bauelemente

Ist das Umladen der Lampenkapazität vollständig erfolgt, wird die Energie, die zu diesem Zeitpunkt auf der Lampenkapazität gespeichert ist, in Wärme umgewandelt. Das geschieht dadurch, dass die Spannung, die an der DBE anliegt, auch über der Speicherdrossel L aus Abbildung 4.20 (c) abfällt. Die Drossel wird aufmagnetisiert und es fließt ein Strom durch L. Über die Freilaufdioden kann diese sich entmagnetisieren. Die gesamte Energie, die in der Drossel zwischengespeichert ist, wird nun an den Bauelementen der unteren Masche in Wärme umgewandelt.

## 4.2.3 Dimensionierung der Bauteile für das adaptive Betriebsgerät für unipolare Pulse

Um die Dimensionen der Bauteile für das Betriebsgerät abschätzen zu können, ist es notwendig geeignete Betriebsparameter für die Lampe zu ermitteln. Aus elektrischer Sicht gibt es drei Parameter, die auf jeden Fall für die Dimensionierung der Bauteile berücksichtigt werden müssen:

- 1) Größe der Lampenkapazität: Als erster Wert muss die Größe der Lampenkapazität im nicht gezündeten Zustand bekannt sein. Dieser Wert kann entweder über geometrische Berechnungen oder durch Messung an einer LCR-Messbrücke ermittelt werden. In dieser Arbeit wurden unter anderem DBE benutzt, deren Kapazität im Bereich von 700 pF lagen.
- 2) Zündspannung: Diese Spannung ist eine dynamische Größe und hängt stark von der Art der Anregung ab [6]. Im Fall der unipolaren Pulsanregung betrug die Wiederzündspannung ca. 2200 V.
- 3) Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung: Um eine homogene Entladung zu erhalten, ist eine gewisse Anstiegszeit notwendig. Da der Mechanismus für die homogene Entladung noch nicht vollständig erforscht ist, wurde in experimentellen Untersuchungen als geeigneter Wert 8 kV/μs ermittelt [31].

Mit diesen Randbedingungen muss nun Schritt für Schritt ermittelt werden, wie die Bedingungen, die von der DBE gefordert werden, mit den zur Verfügung stehenden Bauteilen erfüllt werden können.



Abbildung 4.21: Anordnung von Primär- und Sekundärwicklung eines Transformators, für eine gute Kopplung bzw. für geringe Streuinduktivitäten

Als Erstes werden die Randbedingungen für die Spannungsfestigkeit der MOSFETs und das Übersetzungsverhältnis des Transformators festgelegt.

# Dimensionierung des Transformators und der Spannungsfestigkeit der MOSFETs

Um die Zündspannung an der Lampe zu erreichen, muss der Schalter  $S_2$ aus Abbildung 4.12 für diese Spannung geeignet sein. Da einzelne MOS-FETs für 2400 V auf dem Markt nicht erhältlich sind, muss mit Hilfe eines Transformators die Spannung übersetzt werden, so dass der Schalter  $S_2$ nicht beschädigt wird. In dieser Arbeit fiel die Wahl auf MOSFETs mit einer Spannungsfestigkeit von 600 V. Daraus ergibt sich ein Übersetzungsverhältnis des Transformators von 4:1. Aufgrund der geforderten steilen Anstiegsflanken muss der Transformator so ideal wie möglich gebaut werden, d.h. die parasitären Eigenschaften des Transformators müssen klein gehalten werden. Dies gilt vor allem für die Streuinduktivitäten. Um geringe Streuinduktivitäten im Transformator zu erhalten, müssen die Primärund Sekundärwicklungen so angeordnet werden, dass eine gute Kopplung zwischen den beiden Wicklungen besteht. In Abbildung 4.21 ist zu sehen, wie die Kopplung von der Anordnung der Wicklungen abhängt.

Für die Auswahl des Ferrits ist es wichtig, dass das Material für die zu übertragenden Frequenzanteile geeignet ist, dass das Kernvolumen groß genug ist, um die benötigte Scheinleistung zu übertragen, und dass die anliegende Spannungs-Zeit-Fläche nicht den Kern in Sättigung treibt [16]. Daraus ergibt sich die Forderung nach einer großen Hauptinduktivität  $L_M$  für den Transformator. Neben dem Problem der Sättigung wird Energie in der Hauptinduktivität des Transformators gespeichert, wenn an der Primärseite Spannung anliegt. Diese gespeicherte Energie kann in diesem Schaltprinzip nicht genutzt und auch nicht zurückgespeist werden. Für die selbe anliegende Spannungs-Zeit-Fläche über dem Transformator werden die Verluste für steigende Werte der Hauptinduktivität kleiner. Es gelten folgende Beziehungen:

$$U = L \cdot \frac{dI}{dt} \implies I = \frac{U \cdot \Delta t}{L}$$
 (4.43)

$$E = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 \tag{4.44}$$

Einsetzen der beiden Gleichungen ineinander ergibt:

$$E = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{L} \cdot U^2 \cdot \Delta t^2 \tag{4.45}$$

Gleichung 4.45 besagt, dass die gespeicherte Energie in der Hauptinduktivität, bzw. die daraus folgenden Verluste quadratisch mit der angelegten Spannungs-Zeit-Fläche wachsen und umgekehrt proportional mit der Größe der Hauptinduktivität sinken. Unter diesem Gesichtspunkt wäre ein größeres Übersetzungsverhältnis des Transformators geeigneter, da dann die primäre Spannung sinken kann. Dies würde aber zur Folge haben, dass die Ströme in der Drossel und in den Schaltern steigen.

#### Dimensionierung der Speicherdrossel

Die wichtigste Vorgabe, die die Speicherdrossel erfüllen muss, ist, dass die DBE mit einem Spannungsanstieg von  $8 \,\mathrm{kV}/\mu$ s auf die Zündspannung geladen wird. Die DBE muss bei einer Zündspannung von 2200 V innerhalb von 275 ns geladen werden. Als erster grober Überschlag wird der benötigte Ladestrom für die DBE ermittelt:

$$I(t) = C \cdot \frac{dU}{dt} \tag{4.46}$$

Für eine Kapazität von 680 pF und einen Spannungsanstieg von  $8 \text{ kV}/\mu \text{s}$  muss die Kapazität mit einem Strom von 5,44 A geladen werden. Mit einem Übersetzungsverhältnis des Transformators von 4:1 ist der primärseitige Strom und damit der Drosselstrom 21,76 A. Als erste Bedingung für die

Drossel gilt nun, dass sie bei dem Spitzenstrom im Bereich von hier 22 A nicht in Sättigung gerät. Damit die Kapazität bzw. die DBE in der vorgegebenen Zeit auf die Zündspannung geladen wird, wird Gleichung 4.12 hinzugezogen, die hier nochmals aufgeführt ist:

$$U_{DBE}(t) = I_S \cdot \sqrt{\frac{L}{C_{DBE}}} \cdot \sin \frac{t}{\sqrt{L \cdot u^2 \cdot C_{DBE}}} + U_{DC} \cdot u \cdot \left(1 - \cos \frac{t}{\sqrt{L \cdot u^2 \cdot C_{DBE}}}\right)$$
(4.47)

Für folgende Werte würde die DBE in 275 ns auf 2234 V aufgeladen werden:  $C_{DBE} = 680 \text{ pF}$ ;  $\ddot{u} = 4$ ;  $U_{DC} = 200 \text{ V}$ ;  $I_S = 22 \text{ A}$ ;  $L = 4 \mu \text{H}$ . Durch Variation der Größen  $U_{DC}$ ,  $I_S$  und L kann auch für andere Parameter die Zündspannung in 275 ns erreicht werden.

Für die Dimensionierung der Speicherdrossel sollten noch weitere Aspekte berücksichtigt werden:

- Je kleiner die Induktivität der Speicherdrossel ist und je größer die Versorgungsspannung ist, desto kürzer ist die Ladezeit bis der Maximalstrom erreicht ist: Können die Schalter und die Ansteuerung diese kurze Ladezeit realisieren?
- Je größer die Induktivität der Speicherdrossel ist, desto länger treibt die Drossel nach der Lampenzündung einen Strom: Fördert ein weiterer Ladungstransport zur Lampe nach der Lampenzündung das Entladeverhalten der Lampe oder wird es behindert?
- Wie hängt der Gerätewirkungsgrad mit der Größe der Drossel, der Versorgungsspannung und dem Schaltstrom  $I_S$  zusammen?

Auf diese Fragen wird im nächsten Kapitel eingegangen.

#### Dimensionierung des Trennkondensators

Der Trennkondensator hat die Aufgabe zu verhindern, dass der Transformatorkern in Sättigung gerät. Dies geschieht dann, wenn der Strom über die Primärwicklung einen Gleichanteil besitzt, der den Kern aufmagnetisiert. Der Trennkondensator sorgt dafür, dass der Primärstrom mittelwertfrei bleibt. Um eine ausreichende Energiezufuhr zur DBE zu ermöglichen und damit die Spannung, die über dem Trennkondensator abfällt, möglichst klein ist, sollte seine Kapazität mindestens 100 mal größer sein als die Kapazität der DBE, wenn sie auf die Primärseite des Transformators gerechnet wird. In dieser Arbeit wurde ein Trennkondensator mit der Größe von  $1\,\mu\text{F}$  benutzt.

# 5 Simulation des elektrischen Betriebs einer DBE

## 5.1 Simulationssoftware

Zur prinzipiellen Erprobung des Schaltverhaltens von Schaltungstopologien werden Simulationsprogramme eingesetzt. Diese ermöglichen das Überprüfen komplexer Schaltungen und Schaltzyklen auf ihre Tauglichkeit. Zusätzlich kann damit abgeschätzt werden, ob die geplanten Bauelemente richtig bemessen wurden. Somit können in der Findungsphase eines Schaltprinzips die gröbsten Fehler einer Schaltung behoben werden, bevor Schaden an Bauteilen und Schaltung, aber auch an Personen entstehen. Bei der Simulationsumgebung handelt es sich um das Programm Simplorer der Firma Ansoft [33]. Für diese Arbeit wurde die Simulation im Zeitbereich gewählt.

# 5.2 Implementierung des Lampenmodells und des Pulsgeräts in Simplorer

Für die Simulation der Topologie wird das vorgestellte Modell aus Kapitel 3 benutzt. Um die Komplexität des Modells zu begrenzen, wird jedoch nicht das Modell aus Abbildung 3.18 verwendet, sondern das aus Abbildung 3.17. Der Grund hierfür ist, dass in der Simulation ausschließlich kurze Pulse simuliert werden sollen. Dazu ist es nicht notwendig, das Verhalten der Ionen im Entladungsraum zu berücksichtigen. Die Lampe, die simuliert werden soll, ist eine Planilum <sup>1</sup>. Die aktive Fläche der Lampe beträgt 2000 cm<sup>2</sup> bzw.  $0,2 \text{ m}^2$ . Die elektrischen Parameter dieser Lampe, die für dieses Modell wichtig sind, werden in Tabelle 5.1 aufgelistet. Folgende Werte werden zusätzlich noch ausführlich erklärt:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Planilum ist ein registrierter Warenname der Firma Saint-Gobain.







Abbildung 5.2: Ersatzschaltbild Elektrodenimpedanz

#### R\_Elektrode

Die großflächige transparente Elektrode hat abhängig vom Material einen spezifischen Widerstand. Bei der simulierten Lampe beträgt dieser ca.  $30 \,\Omega/\text{m}^2$  und die aktive Elektrodenfläche beträgt  $0,2 \,\mathrm{m}^2$ . Der elektrische Widerstand der Elektrode für ein Entladungssegment hängt von der Entfernung zur metallischen Kontaktierstelle ab. Das entspricht dem Ersatzschaltbild aus Abbildung 5.2. Dabei stellen die Kapazitäten jeweils ein Entladungssegment dar, zu dem Energie für die Entladung gebracht werden muss. In dieser Simulation wurde auf das Verständnis der Elektrodenverluste kein Schwerpunkt gesetzt. Aufgrund von Erfahrungswerten wurde der Elektrodenwiderstand zu  $1 \,\Omega$  angesetzt. Dies soll den Eindruck eines allzu großen Lampenwirkungsgrades verhindern. Durch die ohmschen Verluste in der leitfähigen Schicht nimmt der simulierte Plasmawirkungsgrad zwar zu, da mehr Energie im Lampenmodell umgesetzt wird. Für das Verständnis des Entladeverhaltens tragen diese Verluste jedoch nicht bei.

#### **G\_Elektronen**

Mit diesem Leitwert wird die eingekoppelte Leistung in die Entladung bestimmt. Dabei stellte sich in Kapitel 3.3.4 heraus, dass der Leitwert abhängig ist von der gesamten Fläche, die zum selben Zeitpunkt zündet. Die zum selben Zeitpunkt zündende Fläche hängt aber von der Anstiegsflanke ab, so dass sich, abhängig von der Anstiegsflanke der Lampenspannung, die Leitfähigkeit verändert. In den folgenden Simulationen wurden als Maximalwert des spezifischen Plasmaleitwerts 60  $\mu$ S/cm<sup>2</sup> angenommen.

Für die Entladung muss ein stetiger Verlauf der Leitfähigkeit gewährleistet werden. Der hier verwendete Verlauf wurde heuristisch ermittelt, so dass eine Hin- und eine Rückzündung im Lampenmodell möglich ist. Für die Hinzündung wurde ein gaussförmiger Verlauf der Leitfähigkeit angenommen und für die Rückzündung ein Verlauf, der einer Planckverteilung entspricht. Der Verlauf des Leitwerts für die Hinzündung lautet:

$$G_{Gaussverteilung}(t) = Leitwert_{max} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{t-t_0-u}{s}\right)^2\right)$$
(5.1)

Dabei sind:

- $Leitwert_{max}$ : der maximale spezifische Leitwert hier:  $60 \,\mu S/cm^2$
- $t_0$ : Zündzeitpunkt er wird durch die Zündbedingung festgelegt
- $\bullet~u$ : Konstante, die das Maximum der Gaussverteilung verschiebt hier: 200 ns
- s: Breite der Gaussverteilung (Standardabweichung) hier: 50 ns

Der Verlauf für die Rückzündung lautet:

$$G_{Planckverteilung}(t) = Leitwert_{max} \cdot a \cdot \frac{1}{\left(t - t_0 + \Delta t\right)^x} \cdot \frac{1}{exp(\frac{b}{t - t_0 + dt}) - 1}$$
(5.2)

Dabei sind:

- $Leitwert_{max}$ : der maximale spezifische Leitwert hier:  $60 \,\mu S/cm^2$
- $t_0$ : Zündzeitpunkt er wird durch die Zündbedingung festgelegt

Name	Wert	physikalischer Hintergrund		
R_Elektroden	$30 \ \Omega/\mathrm{m}^2$ - hier $1 \ \Omega$	ohmscher Widerstand der		
		Elektroden		
C_Gap	870 pF	Kapazität des Entladungs-		
		raums im ungezündeten Zu-		
		stand		
C_Wand	1930 pF	Kapazität der gesamten		
		Barrieren (hier Glas)		
G_Elektronen	$60 \ \mu S/cm^2 \cdot 2000 \ cm^2$	Leitwert im Entladungs-		
	$= 0.12 \text{ S} = 1/8.33 \Omega$	raum, die durch die Elek-		
		tronen dargestellt wird		
C_Plasma	3000 pF	Kapazität, die das Verhal-		
		ten der erzeugten bzw. ge-		
		trennten Ladungsträger si-		
		muliert		
C_Restleitfähigkeit	C_Gap	freie Elektronen, die nach		
		bzw. vor dem Entladungs-		
		vorgang im Entladungs-		
		raum vorhanden sind		
R_Restleitfähigkeit	$1 \Omega$	Widerstand, der den Ener-		
		gieverlust durch Bewegen		
		der freien Ladungsträger		
		darstellt		

Tabelle 5.1: Ele	ektrische Parameter	der Planilum	für das	Lampenmodell
------------------	---------------------	--------------	---------	--------------



Abbildung 5.3: Verlauf des Leitwerts von G\_Elektronen

- $\Delta t$ : Konstante, die eine zeitliche Verschiebung der Planckverteilung bewirkt hier: 60 ns
- <br/> a: Faktor, der die Verteilung auf 1 normiert hier: <br/>  $714\cdot 10^{-21}$
- b: Konstante, die den Anstieg der Verteilung beeinflusst hier:  $1\,\mu {\rm s}$
- x: Exponent, der die Abfallgeschwindigkeit des Leitwerts beeinflusst - hier: 3

Als Beispiel ist der Verlauf des Leitwerts für eine Pulsanregung einer DBE in Abbildung 5.3 dargestellt. Hier ist ersichtlich, dass bei Erfüllung der ersten Zündbedingung G\_Elektronen nur kurzzeitig Werte annimmt, die größer Null sind. Dieser Zeitraum entspricht der Dauer, in der Elektronenlawinen durch das Gap wandern. Sind sie an der Anode angelangt, lagern sie sich dort an und der elektronenbasierte Plasmaleitwert geht auf Null zurück. Für das Modell ist es wichtig, dass der Leitwert auf Null zurückgegangen ist, bevor die Spannung, die an der DBE anliegt, zu sinken beginnt. Die Spannung, die über dem Leitwert anliegt, entscheidet darüber, ob eine weitere Zündung erfolgt. Sinkt der Leitwert nicht schnell genug, bei gleichzeitigem Abfall der äußeren Spannung, so kann sich nicht nochmals eine ausreichende Spannung am Leitwert aufbauen. Die Bedingung für die Rückzündung kann nicht erfüllt werden.

Der Verlauf des Leitwerts für die Rückzündung wurde so gewählt, dass der maximale Leitwert sehr lange erhalten bleibt. Das Ziel ist es, die Kapazität C\_Plasma vollständig zu entladen, um gleichbleibende Anfangsbedingungen für den Start des nächsten Puls zu erhalten. Würde der Leitwert zu



Abbildung 5.4: Plasmastrom und äußerer Lampenstrom vor Lampenzündung - Messung

schnell gegen Null gehen, so besteht die Möglichkeit einer Restspannung auf C\_Plasma.

#### C\_Plasma

Wie in Kapitel 3.3.4 beschrieben, ändert sich die Kapazität C\_Plasma abhängig von der Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung. Da eine automatische Anpassung der Größe dieser Kapazität nicht in das Modell implementiert wurde, muss diese Größe passend zur Anstiegsgeschwindigkeit, die simuliert wird, eingegeben werden. In den folgenden Simulationen wurde die Kapazität C\_Plasma zu 5000 pF angenommen.

#### C\_ Restleitfähigkeit

Misst man den Plasmastrom, der vor einer Pulsentladung in die Lampe fließt, so sieht man, dass der Strom zu Beginn des Spannungsanstiegs nicht Null ist. Die Interpretation dieses Verhaltens ist, dass sich noch freie Ladungsträger im Entladungsraum befinden, die schon zu Beginn des Spannungsanstiegs driften. Das Verhalten ist in Abbildung 5.4 zu sehen. Die Kapazität C\_Restleitfachigkeit bildet dieses Verhalten im elektrischen Lampenmodell nach. Damit kann ein Plasmastrom fließen, bevor die eigentliche Zündbedingung erreicht wird. Aufgrund von Erfahrungswerten wurde, für die Kapazität C\_Restleitfachigkeit der selbe Wert wie für C\_Gap eingesetzt.

#### R\_Restleitfähigkeit

Um die Verluste nachzubilden, die durch das Verschieben der Ladungsträger im ungezündeten Zustand entstehen, wird der Widerstand R\_Restleitfachigkeit benutzt. Hierfür gibt es keinerlei Erfahrungswerte. Experimentell erwies sich der Wert von 1  $\Omega$  bzw. 500  $\mu {\rm S/cm^2}$  als brauchbar.

Die Schaltung aus Abbildung 4.12 wurde in das Simulationsprogramm Simplorer eingegeben, um die Betriebsgrößen zum Betrieb einer DBE mit einer Entladungsfläche von 2000 cm<sup>2</sup> zu bestimmen. Die Anordnung der Bauelemente ist in Abbildung 5.5 (a) zu sehen. Das Schaltmuster für die Ansteuerung der Halbleiterschalter ist in Abbildung 5.5 (b) zu sehen. Zusätzlich ist der zeitliche Verlauf in Kapitel 4 ausführlich beschrieben. Die Schaltzeiten wurden folgendermaßen eingestellt:

- TL1 = 300 ns (Ladezeit der Drossel)
- TE1 = 500 ns (Einspeisezeit: Spannung steigt an bis die Lampe zündet)
- TT1 = 700 ns (Plateauphase: der Schalter MOS2 ist nicht leitend; Spannung über MOS2 ist auf die Zwischenkreisspannung E1 geklemmt)
- TW1 = 31,83  $\mu \rm s$  (Rückzündung und Pulspause; der Schalter MOS2 leitet)

Mit diesen Schaltzeiten wird der Spannungspuls angeschnitten, d.h. der Schalter MOS2 leitet, bevor die Spannung an der DBE und an MOS2 auf null Volt zurückgegangen ist. Dafür ist durch die Rückzündung der Lampe eine höhere Leistungseinkopplung in die Lampe gegeben und damit verbunden eine Reduktion des Blindleistungsanteils. In Tabelle 5.2 sind die Größen der Bauteile aufgelistet. In der Simulation wurde auf detailgetreue Modelle der Leistungs-MOSFETs verzichtet, da hier das prinzipielle Verhalten der Schaltung untersucht werden soll, d.h. Ein- und Ausschaltverluste wurden nicht berücksichtigt. Die Kapazitäten C2 und C4 werden in den



(a) Schaltplan mit Elementen für die Leistungserfassung



Abbildung 5.5: Simulierte Schaltung
Name	Größe	Bauteil
E1	250 V	Gleichspannungsquelle
D2, D3, D4	1 V Fv	Dioden
C1	$1 \ \mu F$	Trennkondensator
C2	0 pF	(spätere Pufferkapazität)
C4	70 pF	(spätere Snubberkapazität)
L1	$4 \ \mu H$	Speicherdrossel
MOS1, MOS2	$190 \text{ m}\Omega$	RDSon Leistungs-MOSFET
TFR1P2W1		Transformator
LS1	$0,4 \ \mu H$	primäre Streuinduktivität
LS2	$30 \ \mu H$	sekundäre Streuinduktivität
LM	$300 \ \mu H$	Hauptinduktivität
RW1	$1 \ \mu \Omega$	primäre Wicklungsverluste
RW2	$1 \ \mu \Omega$	sekundäre Wicklungsverluste
RE	10 Ω	Ersatzwiderstand Eisenverluste
ü	4:1	Übersetzungsverhältnis

Tabelle 5.2: Bauteilgrößen für die Simulation

ersten Simulationen zu Null und erst in den folgenden Unterkapiteln auf größere Werte gesetzt. Sie werden jedoch bereits hier schon eingeführt.

### 5.3 Simulationsergebnisse

### 5.3.1 Bestimmung der Betriebsgrößen

Simuliert man mit den vorgegebenen Größen das Verhalten der Schaltung, so interessiert zunächst der Stromverlauf der Drossel L1. In Abbildung 5.6 (a) sieht man wie der Strom auf einen Maximalwert von ca. 20 A ansteigt, auf 0 A abfällt und negativ wird. Da die Drossel während der Schaltphase TE1 einen Strom in Richtung der Lampe treibt, wird die Spannung, die am Bauteil MOS2 anliegt, größer als die Versorgungsspannung. Durch dieses Spannungsgefälle in Richtung der Versorgungsspannung kann ein negativer Strom durch die Drossel fließen - es findet Energierückspeisung statt. Der Rückspeisevorgang wird in diesem Beispiel unterbrochen, da der Schalter MOS2 bei  $3,5 \,\mu$ s leitend gemacht wird (Abbildung 5.6 (b)). Die Spannung über der Drossel wird zu null und der Strom hört auf zu flie-



spannung

Abbildung 5.6: Verlauf des Drosselstroms

ßen. Nach einer Pause von ca. 500 ns beginnt wieder ein positiver Strom durch die Drossel zu fließen. Die Spannung über der Drossel, die dazu benötigt wird, kommt dadurch zustande, dass sich an der Lampe eine negative Spannung aufbaut - verursacht durch die Hauptinduktivität und die sekundäre Streuinduktivitäten des Transformators. Diese negative Spannung liegt auch an der Primärseite des Transformators an. Die Spannung ist für die Drossel positiv. Ein positiver Strom beginnt zu fließen, der stufenförmig ansteigt (Abbildung 5.6 (b), ab  $4,1\,\mu s$ ). Dies liegt an der oszillierenden Drosselspannung, deren Ursprung auf das Ausschwingen des Schwingkreises zurückgeht. Er besteht aus der primären Streuinduktivität des Transformators und der Kapazität der Lampe. Der Effektivstrom durch die Drossel ergibt sich hier zu ca. 4,2 A. Betrachtet man den Drosselstrom, der nach dem gewünschten Strompuls im Bereich von ca.  $5 \,\mu s$ bis 20  $\mu$ s fließt, so fällt auf, dass diese Energie nicht zurückgewonnen wird. Sie wird nach und nach im unteren Stromkreis, bestehend aus den Bauteilen L1, MOS2 und D4, in Wärme umgesetzt. Dies sind die Hauptverluste diese Schaltprinzips. Die Leistung, die in Wärme umgesetzt wird, ist ca.

$$P_{Verluste} = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 \cdot f = \frac{1}{2} \cdot 4 \,\mu \mathrm{H} \cdot 10 \,\mathrm{A}^2 \cdot 30 \,\mathrm{kHz} = 6 \,\mathrm{W}$$

Die gesamten Verluste, die im unteren Strompfad entstehen, bestehend aus den Elementen D4, L1 und MOS2, ergeben in der Simulation 8,5 W. In Abbildung 5.7 sind der Strom- und Spannungsverlauf des Schalters MOS2 dargestellt. Zur Dimensionierung des Schalters MOS2 erhält man mit der Simulation, dass der Schalter einer Maximalspannung von ca. 2,7 kV ausgesetzt wird. Wie bereits in Kapitel 4.2.2 berechnet, liegt dies an den Streuinduktivitäten des Transformators, die verhindern, dass sofort nach dem Ausschaltvorgang des Schalters MOS2 der Drosselstrom durch den Transformator fließen kann. Die berechnete Frequenz der Spannung, die an MOS2 anliegt, stimmt mit der simulierten Frequenz von 16,5 MHz überein. Da die Streuinduktivität des Transformators, trotz Optimierung, nur in einem gewissen Bereich reduziert werden kann, können die maximalen Spannungswerte nur durch eine Kapazität reduziert werden, die parallel zu MOS2 liegt. Diese Kapazität muss so dimensioniert werden, dass die Spannung am Bauteil MOS2 nicht die zulässige Maximalspannung überschreitet. Mit Gleichung 4.36, die hier nochmals aufgeführt ist,



(b) Verlauf Strom und Spannung von MOS2 - aufgelöst; - - - Strom; — Spannung

Abbildung 5.7: Verlauf Strom und Spannung von MOS2

kann die Kapazität berechnet werden.

$$U_C = I_L(+0)\sqrt{\frac{L \cdot L_{Tr}}{C \cdot (L + L_{Tr})}} \cdot \sin \omega t + U_{DC}\frac{L_{Tr}}{L + L_{Tr}} \cdot (1 - \cos \omega t) \quad (5.3)$$

Dabei wird der zweite Summand dieser Gleichung vernachlässigt, da er einen unwesentlichen Beitrag für die Maximalspannung an MOS2 liefert. Nach Umformen dieser Gleichung ergibt sich für die Kapazität, die die Maximalspannung reduzieren soll:

$$C4 = \left(\frac{I_L}{U_C}\right)^2 \cdot \frac{L \cdot L_{Streu}}{L + L_{Streu}}$$
(5.4)

Mit

- C4: Kapazität, die parallel zu MOS2 gesetzt werden muss, damit die maximal zulässige Spannung nicht überschritten wird
- $I_L$ : Drosselstrom, bei dem MOS2 nichtleitend gemacht wird
- $U_C$ : maximal zulässige Spannung an MOS2
- L: Induktivität der Speicherdrossel
- $L_{Streu}$ : von der Primärseite gesehene Streu<br/>induktivität des Transformators

Um die maximal zulässige Spannung  $U_C$  von 600 V nicht zu überschreiten, muss die Kapazität C4 abhängig vom maximalen Drosselstrom  $I_L$ dimensioniert werden. In Tabelle 5.3 sind für einige Drosselströme die notwendigen kapazitiven Größen aufgetragen. Diese Maßnahme zum Schutz des Schalters MOS2 hat zur Folge, dass die Verluste in der Schaltung ansteigen, da diese Schaltung keine Möglichkeit vorsieht, die Energie, die in jedem Schaltzyklus auf C4 gelagert wird, zurückzugewinnen. Eine zusätzliche Herausforderung für das Schaltkonzept, die dieses Problem noch verstärkt, wird in Kapitel 5.4 erläutert. Dabei handelt es sich um die Pufferung der DBE durch eine parallel liegende Kapazität.

Zunächst werden nun alle Effektiv- und Maximalströme dieses Schaltkonzepts mit den bereits beschriebenen Betriebsgrößen (Tabelle 5.2) in Tabelle 5.4 aufgeführt. Dabei werden die Größen einmal für C4 = 70 pF aufgetragen, was der Kapazität des Schalters MOS2 entspricht und einmal für

$\hat{I}_L$ in A	C4 in F
15	8,33e-10
20	1,48e-9
25	2,31e-9
30	3,33e-9
35	4,45e-9
40	5,93e-9
45	7,50e-9
50	9,26e-9
55	11,2e-9
60	13,3e-9

**Tabelle 5.3:** Kapazität  $C\overline{4}$  zum Beschränken der maximalen Spannung<br/>auf 600 V an MOS2 in Abhängigkeit des Drosselstroms  $I_L$ 

	C4 =	$70\mathrm{pF}$	C4 =	= 2 nF
Bauteil	$I_{eff}$ [A]	$I_{max}$ [A]	$I_{eff}$ [A]	$I_{max}$ [A]
MOS1	2,12	20,92	2,31	$23,\!05$
D3	0,67	6,75	1,11	12,67
D4	3,57	$10,\!39$	3,34	9,58
L1	4,2	20,92	4,28	23,04
MOS2	3,48	27,07	3,82	310,75
C1	3,05	24,71	3,18	28,28
DBE	0,77	6,33	0,80	7,22

Tabelle 5.4: Effektiv- und Maximalströme der einzelnen Bauteile

 $C4 = 2 \,\mathrm{nF}$ . Dies ist der Wert bei dem die zulässige Maximalspannung an MOS2 nicht überschritten wird. Durch die größere Kapazität C4 wird wie bereits beschrieben die Maximalspannung an MOS2 reduziert. Dafür steigen sowohl die Effektivströme als auch die Spitzenströme für beinahe alle Elemente an. Beim Schließen von MOS2 wird die Parallelkapazität kurzgeschlossen, was den großen Spitzenstrom verursacht. Von Vorteil ist, dass die Ströme in der Lampe auch ansteigen, was eine Erhöhung der Lampenleistung bewirkt.

### 5.3.2 Bestimmung der Verluste

Wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben, beruht der pulsförmige Betrieb einer DBE darauf, dass die Kapazität der DBE so lange geladen wird, bis über ihr die Zündspannung anliegt. Der Gasraum wird kurzzeitig leitfähig, es wird Energie in das Plasma eingekoppelt, das wiederum Strahlung emittiert. Anschließend erlischt die Entladung. Durch eine geeignete Pulsform bzw. ein geeignetes Puls-Pausen-Verhältnis, ist es möglich das Gas zu einer weiteren Strahlungsemission anzuregen. Dazu muss das von außen in den Gasraum eingekoppelte elektrische Feld in kürzester Zeit zu null bzw. negativ werden. Für das Betriebsgerät bedeutet dies: nur in dem kurzen Zeitraum der Entladung, der ungefähr 60 ns bis 100 ns andauert, kann Wirkleistung in der DBE umgesetzt werden. Alle weiteren Ströme, die im Betriebsgerät fließen, erzeugen ausschließlich Verluste. Somit ist leicht einzusehen, dass mit solch einem System kaum ein Gerätewirkungsgrad erreicht werden kann, den Betriebsgeräte für Verbraucher mit ohmschen Verhalten erreichen (bis zu 95%), wie z.B. eine Gasentladungslampe deren Elektroden sich im Gasraum befinden und die im kHz-Bereich betrieben wird.

Die Verluste in diesem Schaltprinzip setzen sich nun folgendermaßen zusammen:

- 1. Leitend-Verluste: Damit die DBE ge- und entladen wird, muss Ladung zwischen der Versorgungsquelle und der Lampe hin- und herpendeln. Abhängig von den ohmschen Widerständen, die in dem Leistungspfad liegen, entstehen die Leitend-Verluste.
- 2. Schaltverluste: Verluste, die beim Öffnen und Schließen der MOSFET-Schalter entstehen, wenn keine ZVS bzw. ZCS Bedingung eingehalten wird. Diese Verluste werden in den Simulationen nicht berücksichtigt.
- 3. Verluste durch vagabundierende Energie: Das vollständige Entladen einer Kapazität und das Ziel diese Energie so zu speichern, dass sie später genutzt werden kann ist nicht trivial. In diesem ersten Schaltkonzept wird auf diese Problematik nicht eingegangen. Die gesamte Energie, die auf der Kapazität der DBE gespeichert ist und nicht für die Entladung genutzt wird, geht verloren. Dies wirkt sich besonders stark auf den Gerätewirkungsgrad aus. Je größer das Verhältnis

Bauteil	Energieumsatz	prozentualer Anteil
$\mathbf{P}_{System}$	$51 \mathrm{W}$	$100 \ \%$
$\mathbf{P}_{DBE}$	38 W	74~%
$P_{D3}$	$0,7 \mathrm{W}$	1,3~%
$P_{MOS1}$	$1,75 { m W}$	3,4~%
$P_{D2}$	$0,33 \mathrm{W}$	0,6~%
$P_{D4}$	$1,9 { m W}$	3,7~%
$P_{MOS2}$	4,8 W	9,4 %
$P_{L1}$	1 W	1,9~%
$P_{Trafo}$	$2,5 \mathrm{W}$	4,9~%

Tabelle 5.5: Leistungsumsatz in den einzelnen Bauteilen, mit C4 = 2 nF

Kapazität der DBE zu Leistungsaufnahme der DBE ist, desto größer werden die relativen Verluste. Wie in Abbildung 5.6 zu sehen, ist der Drosselstrom ab dem Zeitpunkt  $4\,\mu$ s der vagabundierenden Restenergie zuzuschreiben.

Die simulierten Verluste in den einzelnen Bauteilen sind in Tabelle 5.5 aufgeführt. Die Simulation wurde mit der Kapazität C4 = 2 nF durchgeführt, da sie hier die kleinste zulässige Kapazität ist, bei der der Schalter MOS2 noch nicht wegen Überspannung zerstört wird. Die größten Verluste sind in den Bauteilen MOS1, MOS2, D4 und dem Transformator. Dabei spiegelt der Anteil der Verluste in den Bauelementen MOS2 und D4 das Problem wider, dass die auf der DBE nicht genutzte Energie nicht zwischengespeichert werden kann. Die Verschärfung dieses Problems wird im nächsten Kapitel beschrieben.

## 5.4 Einführung einer Lampen-Parallel-Kapazität C<sub>inter</sub>

Parallel zur Arbeit dieser Promotion wurde festgestellt [34], dass die Leistungseinkopplung in einer DBE gesteigert werden kann, wenn parallel zur DBE eine weitere Kapazität geschaltet ist. Der Name für diese Kapazität stammt aus einer speziellen Bauart von DBE Lampen, deren Parallel-Kapazität bereits in der Lampe integriert ist. Aus historischen Gründen wurde dieser Kapazität der Name  $C_{inter}$  ("internal capacitance") gegeben.

Bauteil	$I_{eff}$ [A]	$I_{max}$ [A]	P[W]	Leistungsanteil
System	5,74	45,68	222,54	100%
DBE	1,61	6,61	89,97	$40,\!43\%$
MOS1	5,63	45,68	8,08	$3{,}63\%$
D3	1,09	12,73	0,72	$0,\!32\%$
L1	19,18	45,68	2,01	$0,\!90\%$
D4	18,30	38,40	13,94	6,26%
MOS2	21,89	983,04	100,98	$45,\!38\%$
Transformator	11,94	57,34	6,84	$3,\!07\%$

**Tabelle 5.6:** Elektrische Grössen der einzelnen Bauteilen im Betrieb mit  $C_{inter} = 1000 \, nF$ 

 $C_{inter}$  ist in der Lage, zum Zeitpunkt der Zündung der Lampe Ladungsträger nachzuführen. Das führt zu einer Steigerung der Leistungsdichte in der Entladung. Da die Entladung nur ca. 100 ns andauert, müssen die Ladungsträger sehr schnell nachgeliefert werden. Ist die Kapazität  $C_{inter}$ nicht vorhanden, so muss die gesamte Energie sowohl durch die Drossel L1 als auch durch den Transformator geführt werden. Da dieser kurzfristige Energieabruf im Zeitbereich von  $\mu$ s liegt, können die induktiven Bauelemente diese Energie nicht liefern. Um bei einer bestehenden Lampe die Energieeinkopplung während eines Entladevorgangs zu erhöhen, kann die Kapazität  $C_{inter}$  eingesetzt werden.

Für das Betriebsgerät bedeutet dies weitere Anforderungen hinsichtlich der Energierückgewinnung. Der DBE Betrieb wurde mit einer Parallelkapazität von  $C_{inter} = 1000 \,\mathrm{pF}$  simuliert. Dabei musste die Vorladezeit TL1 von 300 ns auf 700 ns erhöht werden, damit die geforderte Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung von 8 kV/ $\mu$ s erfüllt wird. Das ergibt ein Schaltstrom von 45 A am Schalter MOS2, so dass die Kapazität C4 auf den Wert von 7,5 nF erhöht werden muss. Aus den simulierten Werten in Tabelle 5.6 ist ersichtlich, dass mit Einführen von  $C_{inter}$  bei gleicher Anstiegsgeschwindigkeit von 8 kV/ $\mu$ s die Lampenleistung verdoppelt wurde. Diese Leistungssteigerung geht aber zu Lasten des Gerätewirkungsgrads, der auf 40 % absinkt. Die nicht verwendete Energie wird in den Bauteilen MOS2, D4 und L1 in Wärme umgesetzt, wobei MOS2 den größten Anteil daran hat. Ein Lösungsversuch dieses Problems wird im folgenden Kapitel vorgestellt.

## 5.5 Betriebsweisen einer DBE mit Parallelkapazität C<sub>inter</sub>

Um die Energie, die auf der DBE und  $C_{inter}$  nach der ersten Zündung verblieben ist, in die Versorgungsspannung zurückzuspeisen, bedarf es eines Mechanismus bzw. einer Betriebsweise, die auf dieses Ziel eingeht. Hier werden drei Topologien nebeneinander vorgestellt, um danach die Betriebsweisen zur Bestimmung der Betriebsgrößen zu simulieren. In Abbildung 5.8 (a) ist das bereits vorgestellte Schaltkonzept mit zwei MOSFET-Schaltern zu sehen. Auch hier wird die Drossel  $L_S$  vorgeladen. Es wird jedoch nicht, wie in vorigen Kapiteln beschrieben, der Schalter  $S_1$  nur bis zur Zündung der DBE leitfähig gelassen. Der Schalter  $S_1$  leitet, bis die Drossel  $L_S$  eine volle Schwingungsperiode vollführt hat, so dass die gesamte Restenergie des Systems wieder in den Zwischenkreis zurückgespeist ist. Dies kann jedoch nur dann funktionieren, wenn das Potentialgefälle zwischen dem Drain-Anschluss von S<sub>2</sub> und der Zwischenkreisspannung groß genug ist und die Dämpfung des Schwingkreises nicht zu stark ins Gewicht fällt. In der aktuellen Schaltung wurde die Zwischenkreisspannung auf 250 V gelegt und die Spannung über  $S_2$  betrug 600 V. Der Schalter  $S_2$  wird erst zum Zeitpunkt des Stromnulldurchgangs der Drossel leitend gemacht.

In Abbildung 5.8 (b) ist das Prinzip ähnlich zu dem aus (a). Der Unterschied liegt darin, dass bei (b) die gesamte Restenergie, die auf  $C_{inter}$  und der eigentlichen DBE ist, in der Drossel  $L_S$  zwischengespeichert wird, bevor sie in den Zwischenkreis zurückgespeist wird. Dazu wird der Schalter S<sub>3</sub> beim ersten Stromnulldurchgang der Drossel  $L_S$  geschlossen. Es liegt nun die transformierte Lampenspannung über der Drossel an. Ein Strom beginnt durch die Drossel zu fließen. Bei Erreichen des Maximalwerts wird S<sub>3</sub> nichtleitend gemacht und der Strom kommutiert auf die Inversdiode von S<sub>1</sub>. Das Problem dieser Topologie besteht darin, dass der Spannungsanstieg an S<sub>3</sub> bei einem Schaltstrom von z.B. 40 A sehr steil ist und die Gefahr besteht, dass der MOSFET-Schalter wieder leitend wird (siehe Kapitel A.3). Abhilfe schafft hier eine Parallelkapazität, die aber wieder andere Verluste mit sich bringt.

Um das Problem der zu schnellen Spannungsänderung an den Schaltern  $S_1$  und  $S_3$  zu lösen, wurde die Topologie 5.8 (c) untersucht. Hier wurde der MOSFET-Schalter  $S_3$  aus (b) umgedreht und in Serie mit einer Kapazität gesetzt. Der prinzipielle Stromverlauf ist in Abbildung 5.9 schematisch



(a) Pulsgerät mit 2 Schaltern, wie bereits vorgestellt



(c) Pulsgerät mit 3 Schaltern und Entlastungskapazität C3

Abbildung 5.8: Schalttopologien zum Betrieb einer DBE mit  $C_{inter}$ 



Abbildung 5.9: Schaltverlauf der Schaltung mit 3 Schaltern und Entlastungskapazität zum Betrieb einer DBE mit  $C_{inter}$ 

dargestellt. Zu Beginn eines Zyklus liegt an der Kapazität C<sub>3</sub> bereits Spannung an. Die Drossel wird geladen und die Spannung an der DBE steigt an (Teil (a)). Nun wird  $S_3$  leitend gemacht und  $S_2$  nichtleitend. Die Drossel treibt weiterhin einen Strom in die DBE und entlädt gleichzeitig die Kapazität  $C_3$ . Bei richtiger Dimensionierung sinkt die Spannung an  $C_3$  bis auf null Volt (Abbildung 5.9 (b) und (f)). Der Drosselstrom wird negativ. Die verbliebene Energie auf der DBE wird in der Drossel gespeichert. Der Drosselstrom fließt über  $C_3$ , so dass die Spannung über dieser Kapazität ansteigt (Teil (c)). Hat die Spannung an  $C_3$  die Zwischenkreisspannung erreicht fließt der Drosselstrom über die Inversdiode von  $S_1$ . Es wird Energie in den Zwischenkreis zurückgespeist (Teil (d)). Damit die Energie der Kapazität  $C_3$  nicht verloren geht, wird  $S_3$  nichtleitend gemacht. Idealerweise ist das System nach dem Rückspeisevorgang durch die Drossel energiefrei. Es findet kein weiteres Schwingen durch vagabundierende Energie statt. In Abbildung 5.9 (f) ist der Spannungsverlauf über der Kapazität  $C_3$  und der Stromverlauf der Drossel aufgetragen. Durch dieses Prinzip verlaufen die Spannungsflanken über den Schaltern  $S_1$  und  $S_3$  flacher. Zugleich wird nicht genutzte Energie so gespeichert, dass sie nochmals verwendet werden kann.

Die Schaltungen aus Abbildung 5.8 (a) und (c) wurden simuliert. Dabei wurde die Kapazität C<sub>4</sub>, die parallel zum Schalter S<sub>2</sub> liegt, so variiert, dass die maximal zulässige Spannung an S<sub>2</sub> nicht überschritten wird. Die Werte der elektrischen Bauteile wurden, wenn nicht anders angegeben aus Tabelle 5.2 übernommen. Das Hauptaugenmerk lag auf dem Spannungsanstieg der Lampenspannung. Das Ziel war es, zum einen unabhängig von der kapazitiven Last die Anstiegsgeschwindigkeit auf  $8 \text{ kV}/\mu$ s einzustellen und zum Andern, die gesamte Restenergie zurückzuspeisen. Die Ergebnisse stehen in Tabelle 5.7.

Es wird deutlich, dass sich der Wirkungsgrad zwischen dem 2- und 3-Schalter-Konzept für den resonanten Betrieb nicht wesentlich unterscheidet. Der Rückspeisemechanismus bestehend aus  $S_3$  und  $C_3$ , bringt nicht die gewünschte Verbesserung des Gerätewirkungsgrads. Die größten Verluste entstehen bei beiden Konzepten durch die Leitendwiderstände der Schalter. Im Vergleich zwischen den beiden Konzepten sieht man, dass die Summe der Schalterverluste des 2-Schalter-Konzepts denen des 3-Schalter-Konzepts gleichen.

Der elektrische Gerätewirkungsgrad sinkt mit steigender Parallelkapazität  $C_{inter}$ . Dies liegt daran, dass für den Spannungsanstieg an der DBE

Bauteil	Einheit	2-Sch	alter I	Jösung	3-Schalter Lösung	
C <sub>inter</sub>	pF	0	1000	2000	1000	2000
$C_4$	nF	4	10	30	10	30
$C_3$	nF				60	60
R <sub>DSon</sub>	$m\Omega$	190	190	190	190	190
dU/dt	$kV/\mu s$	8,13	8,03	7,62	7,95	7,61
$\eta_{el}$	%	89	71	54	74	54
$P_{DC}$	W	52	83	231	78	217
$P_{DBE}$	W	46	59	126	58	117
$S_{DC}$	VA	718	2320	5100	1850	4590
$P_{S1}$	W	1,3	9,9	$45,\!8$	6,8	39,1
$P_{S2}$	W	$1,\!0$	5,0	40,6	4,2	38,0
$P_{S3}$	W				4,1	4,8
I <sub>LRMS</sub>	А	2,9	9,3	20,1	9,4	19,6
I <sub>L max</sub>	А	21	55,5	90,3	53,2	90,3
I <sub>S1 RMS</sub>	A	2,6	7,2	$15,\!5$	6,0	14,3
I <sub>S2 RMS</sub>	А	2,3	5,1	$14,\! 6$	4,7	14,2
I <sub>S3 RMS</sub>	А				4,7	4,8

**Tabelle 5.7:** Elektrische Größen im resonanten Betrieb für die Topologien aus Abbildung 5.8 (a) und (c);  $U_{DC} = 250 \text{ V}$ ;  $C_{inter} = 0 \text{ pF}$ ; 1000 pF; 2000 pF

die Beziehung

$$I = C \cdot \frac{dU}{dt} \tag{5.5}$$

$$I + \Delta I = \left(C_{DBE} + C_{inter}\right) \cdot \frac{dU}{dt} \tag{5.6}$$

gültig ist. Da C hier aus den Kapazitäten  $C_{DBE}$  und  $C_{inter}$  gebildet wird, steigt der benötigte maximale Drosselstrom mit der Kapazität proportional an. Die Energie, die in den ohmschen Elementen nur für den Ladevorgang in der Topologie umgesetzt wird, berechnet sich zu:

$$E_{\Omega} = \int_0^{t_{load}} R \cdot I(t)^2 dt \tag{5.7}$$

Die Zeit, in der die Drossel geladen werden muss, beträgt:

$$U = L \cdot \frac{dI}{dt} \tag{5.8}$$

$$\hat{I} = U \cdot \frac{1}{L} t_{load} \tag{5.9}$$

$$\hat{I} + \Delta I = U \cdot \frac{1}{L} \left( t_{load} + \Delta t \right) = \left( C + \Delta C \right) \cdot \frac{dU}{dt}$$
(5.10)

Einsetzen der Drosselladezeit in die Gleichung für die ohmsche Energie ergibt:

$$E_{\Omega} = \int_{0}^{t_{load}} R \cdot \left( U \cdot \frac{1}{L} \cdot t \right)^{2} dt$$
(5.11)

$$=R \cdot U^2 \cdot \frac{1}{L^2} \cdot \frac{1}{3} \cdot t^3 \tag{5.12}$$

Für eine größere kapazitive Last muss die Ladezeit erhöht werden:

$$E_{\Omega} + \Delta E_{\Omega} = R \cdot U^2 \cdot \frac{1}{L^2} \cdot \frac{1}{3} \left( t + \Delta t \right)^3$$
(5.13)

$$=R \cdot U^{2} \cdot \frac{1}{L^{2}} \cdot \frac{1}{3} \left( \frac{L}{U} \cdot \frac{dU}{dt} \left[ C + \Delta C \right] \right)^{3}$$
(5.14)

$$=R \cdot \frac{L}{U} \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{dU}{dt}\right)^3 \cdot \left(C + \Delta C\right)^3 \tag{5.15}$$

Gleichung 5.15 besagt, dass bei Verdoppelung der kapazitiven Last, z.B. für  $C_{inter} = C_{DBE}$ , die ohmschen Verluste während der Ladezeit der Drossel verachtfacht werden! Das Gleiche wird auch für die Rückspeisung der Lampenenergie angenommen. Nimmt man an, dass der größte Anteil der Verluste aus Leitungsverlusten besteht, so muss bei Verdoppelung der lastseitigen Kapazität die eingekoppelte Lampenleistung verachtfacht werden, damit der Gerätewirkungsgrad konstant bleibt. Durch das Parallelschalten einer Kapazität zur DBE, z.B. durch Einführen von  $C_{inter}$ , sinkt der Gerätewirkungsgrad also, wenn die eingekoppelte Lampenleistung nicht proportinal mit den zunehmenden Leitungsverlusten ansteigt.

## 5.6 Optimierung des Gerätewirkungsgrads

Da die Anstiegsflanke der DBE-Spannung ein entscheidendes Kriterium für das Entladungsverhalten der DBE ist, ist die wesentliche elektrische Größe der Strom, der die Lampenkapazität auflädt. Die Verluste, die im Betriebsgerät entstehen, sind zu einem großen Teil die Leitendverluste.

### 5.6.1 Variation des Übersetzungsverhältnis des Transformators

Das Übersetzungsverhältnis des Transformators wird schrittweise reduziert, bei gleichzeitigem Festhalten der Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung bei  $8 \text{ kV}/\mu$ s. Das Ziel ist die Leitendverluste im Ladekreis der Speicherdrossel zu reduzieren. Das Verkleinern des Übersetzungsverhältnis bewirkt, bei gleichbleibender Zwischenkreisspannung, dass für einen gewünschten sekundärseitigen Lampenstrom der primärseitige Strom kleiner wird. Berechnet man die Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung aus Gleichung 4.12, so erkennt man den beschriebenen Zusammenhang von Übersetzungsverhältnis, primärseitigem Strom und Anstiegsgeschwindigkeit:

Bauteil	Einheit		2-Schalter Lösung				
u <sub>Trafo</sub>		4:1	3:1	3:1	2:1	2:1	
$L_{S2}$	$\mu H$	30	30	20	10	10	
L	$\mu H$	4	4	4	4	5	
dU/dt	$kV/\mu s$	7,91	8,03	8,09	8,07	8,19	
$\eta_{el}$	%	70	76	78	79	80	
$P_{DC}$	W	81	87	74	60	80	
$P_{DBE}$	W	57	66	58	48	64	
$S_{DC}$	VA	2270	1940	1770	1550	1630	
$P_{S1}$	W	11,06	8,66	7,21	5,41	6,14	
$P_{S2}$	W	7,99	5,53	4,17	4,51	4,65	
$P_{Tr}$	W	10,76	6,49	4,34	3,10	2,26	
I <sub>L RMS</sub>	А	9,07	7,77	7,07	6,22	6,51	
I <sub>L max</sub>	А	49,60	49,59	44,61	41,39	40,69	
I <sub>S1 RMS</sub>	А	7,08	6,23	5,56	4,88	5,19	
I <sub>S2 RMS</sub>	А	4,79	4,71	4,34	3,57	4,25	
ITr prim BMS	А	8.20	6.24	5.36	3.89	4.93	

$$\frac{dU_{DBE}(t)}{dt} = I_S \cdot \frac{1}{u \cdot C_{DBE}} \cdot \cos \frac{t}{\sqrt{L \cdot u^2 \cdot C_{DBE}}} + U_{DC} \cdot \left(1 - \cos \frac{t}{\sqrt{L \cdot u^2 \cdot C_{DBE}}}\right) + U_{DC} \cdot u \cdot \left(\sqrt{L \cdot u^2 \cdot C_{DBE}} \cdot \sin \frac{t}{\sqrt{L \cdot u^2 \cdot C_{DBE}}}\right)$$
(5.16)

Die Anstiegsgeschwindigkeit ist nur vom ersten Summanden abhängig, da er viel größer ist als die restlichen Summanden. Dies wirkt sich auf die Verluste im Betriebsgerät positiv aus. Mit dieser Parametervariation soll gezeigt werden, wie sich die Verluste in der Schaltung reduzieren lassen. Dabei wird nicht auf die maximal zulässige Drain-Source-Spannung des Schalters S<sub>2</sub> geachtet, die bei geringerem Übersetzungsverhältnis größer wird. In Tabelle 5.8 sieht man, dass mit reduziertem Übersetzungsverhältnis des Transformators auch die Scheinleistung und die Effektivströme reduziert werden. Dies hat zur Folge, dass der elektrische Gerätewirkungsgrad ansteigt.

Ein weiterer noch nicht betrachteter Aspekt ist die sekundärseitige Streuinduktivität. Bei Reduzieren des Übersetzungsverhältnis sinkt diese auch. Es kann beobachtet werden, dass trotz gleichbleibender Spannungsanstiegsflanke an der DBE der Rückgang der eingekoppelten Lampenleistung mit dem Rückgang der sekundären Streuinduktivität  $L_{S2}$  korreliert. Der Grund dafür ist, dass bei kleinerer Streuinduktivität während der Zündung nicht so viel Energie aus dieser nachgeführt werden kann. Dieser Leistungsrückgang kann dadurch kompensiert werden, dass eine größere Speicherdrossel in der Topologie benutzt wird (siehe Tabelle 5.8 vorletzte und letzte Spalte). Eine kleinere Streuinduktivität bewirkt zusätzlich, dass für einen gewünschten Spannungsanstieg auf der Sekundärseite der Primärstrom nicht so groß sein muss, d.h. bei einer geringeren Streuinduktivität des Trafos sinken die Effektivströme im Betriebsgerät. Für die Topologie wäre das Ubersetzungsverhältnis 1:1 optimal, d.h. der Wegfall des Transformators. Da es im Moment jedoch keine ausreichend schnell schaltenden Transistoren auf dem Markt gibt, die eine Sperrspannung von 2 kV aufweisen, ist dies eine Aufgabe, die mit Transistormodulen angegangen werden kann.

### 5.6.2 Variation der Zwischenkreisspannung

Eine weitere Möglichkeit der Parametervariation besteht in der Zwischenkreisspannung U<sub>DC</sub>. Mit einer höheren Zwischenkreisspannung lässt sich die Ladezeit TL1 der Speicherdrossel reduzieren. Ein höheres Zwischenkreispotential unterstützt den Drosselstrom während des Ladevorgangs der DBE. Dadurch werden für den Ladevorgang die Effektivströme der einzelnen Komponenten reduziert. Zusätzlich verringert sich der Maximalstrom im Ausschaltzeitpunkt des Schalters S2. Betrachtet man die Ergebnisse aus Tabelle 5.9, stellt man fest, dass diese Aussage nur bedingt richtig ist. Mit steigender Zwischenkreisspannung sinkt die benötigte Vorladezeit TL1 der Speicherdrossel L bei gleichbleibendem Spannungsanstieg (8 kV/ $\mu$ s) an der DBE. Dadurch sinken zunächst alle Effektivströme über den einzelnen elektrischen Komponenten und der Gerätewirkungsgrad steigt an.

Oberhalb der Zwischenkreisspannung von 350 V ändert sich jedoch das beschriebene Verhalten: Die Effektivströme werden wieder größer und der

Bauteil	Einheit		2-Sch	alter Lö	isung	
$U_{DC}$	V	200	250	300	350	400
TW1	ns	29073	29330	29513	29643	29733
TL1	ns	1060	800	650	490	400
TE1	ns	1000	1000	1000	1000	1000
TT1	ns	2200	2200	2200	2200	2200
dU/dt	$kV/\mu s$	7,97	7,91	8,03	8,00	8,07
$\eta_{el}$	%	69	70	72	74	73
$P_{DC}$	W	94	81	77	80	86
$P_{DBE}$	W	65	57	56	60	63
$S_{DC}$	VA	1880	2270	2700	3140	3680
$P_{S1}$	W	12,26	11,06	$10,\!67$	10,54	10,97
$P_{S2}$	W	8,91	$7,\!99$	3,76	2,71	3,31
$P_{Tr}$	W	12,00	10,76	8,91	5,92	4,46
I <sub>L RMS</sub>	А	9,42	$9,\!07$	9,00	8,98	9,21
$I_{L max}$	А	51,40	49,60	48,34	46,47	45,40
I <sub>S1 RMS</sub>	А	7,46	$7,\!08$	6,95	6,90	7,04
I <sub>S2 RMS</sub>	А	8,91	7,99	3,76	2,71	3,31
$I_{Tr \ prim \ RMS}$	A	8,6	8,2	8,0	8,1	8,5

**Tabelle 5.9:** Elektrische Größen im resonanten Betrieb für verschiedene  $U_{DC}$  und  $u_{Trafo} = 4:1$ ; f = 30 kHz;  $C_{inter} = 1000 \text{ pF}$ ;  $C_4 = 10 \text{ nF}$ ;  $R_{DSon} = 190 \text{ m}\Omega$ ;  $L = 4 \mu\text{H}$ ;  $L_{S2} = 30 \mu\text{H}$ 



Abbildung 5.10: Spannungsverlauf an der DBE mit gleicher Lampenleistung und unterschiedlicher Systemscheinleistung

Gerätewirkungsgrad nimmt ab. Dies erklärt sich durch das Verhalten der Scheinleistung. Bei zunehmender Zwischenkreisspannung von 200 V auf 400 V verdoppelt sich die Scheinleistung, die umgesetzte Leistung in der DBE bleibt jedoch annähernd konstant. Der Grund dafür ist, dass ein gewisser Ladestrom der Speicherdrossel benötigt wird, um die gewünschte Anstiegsflanke der Lampenspannung zu erzeugen. Ist die Zwischenkreisspannung groß genug, steckt in dem System Zwischenkreisspannung - Speicherdrossel noch so viel Energie, dass die Lampenspannung nach der Zündung weiter ansteigt. Nach dem Verhalten des Lampenmodells kann diese zusätzliche Energie jedoch nicht genutzt werden. Diese Blindleistung erzeugt Verluste in den Leitungen, die den Gerätewirkungsgrad nach anfänglicher Verbesserung wieder verschlechtert. In Abbildung 5.10 sind zwei Spannungspulse aufgetragen, mit denen der gleiche Leistungsumsatz in der DBE simuliert wird. In dem Puls, in dem die Lampenspannung nach der Zündung nochmals ansteigt, ist die Systemscheinleistung doppelt so groß. Es ist also notwendig die Energie, die auf das System  $C_{inter}$  - DBE in einer definierten Zeit fließt, exakt zu dimensionieren. Bei Erhöhung der Zwischenkreisspannung muss daher zusätzlich zur Reduzierung der Ladezeit der Speicherdrossel ihre Induktivität verringert werden.

### 5.6.3 Optimierung des Parametersatzes

Um den bestmöglichen Gerätewirkungsgrad zu erhalten, müssen, abgesehen von der Minimierung von Schaltverlusten, die Blindströme und somit die Scheinleistung so weit wie möglich reduziert werden. Dies geschieht durch das Anpassen des Übersetzungsverhältnisses und der Streuinduktivität des Transformators. Da der Leitendwiderstand vom MOSFET ansteigt, wenn seine maximal zulässige Sperrspannung größer wird, muss individuell das Optimum zwischen Übersetzungsverhältnis des Transformators und maximal zulässigem Strom durch den MOSFET bestimmt werden. Bei größer werdendem Übersetzungsverhältnis steigt der maximale Strom durch den MOSFET an, die maximale Spannung die am MOSFET anliegt sinkt jedoch. Von Vorteil ist, dass bei kleinerer Streuinduktivität die zeitliche Stromverteilung während des Pulses besser auf die Leistungsaufnahme der Lampe angepasst werden kann. Der zweite Parameter ist die Zwischenkreisspannung. Durch Erhöhung dieser kann die Ladezeit der Speicherdrossel reduziert werden, so dass sich der Effektivstrom verringert. Als Abschluss des Kapitels wurde die Schaltung mit optimalen Parametern simuliert, um den höchsten Gerätewirkungsgrad zu erhalten. In Tabelle 5.10 sind die optimalen Einstellungen der vorigen Parametervariationen und die Kombination dieser beiden Parametervariationen dargestellt. Als bester Wirkungsgrad wird bei geringem Übersetzungsverhältnis des Transformators, geringer Streuinduktivität des Transformators und hoher Zwischenkreisspannung ein elektrischer Gerätewirkungsgrad von ca. 84 % simuliert. Mit zunehmendem Gerätewirkungsgrad sinkt jedoch die Leistungsaufnahme der Lampe, da die Energie, die der Lampe zur Entladung bereitgestellt wird, so weit reduziert wird, dass das Verhältnis zwischen umgesetzter Lampenleistung zu Verlustleistung in dem Betriebsgerät maximal wird.

Größe	Einheit	2-Schalter Lösung				
$\eta_{el}$	%	83,9	79	74		
U <sub>DC</sub>	V	400	250	350		
L	$\mu H$	3	4	4		
$L_{S2}$	$\mu H$	10	10	30		
u		2:1	2:1	4:1		
TW1	ns	30513	31083	29643		
TL1	ns	220	650	490		
TE1	ns	1000	700	1000		
TT1	ns	1600	900	2200		
dU/dt	$kV/\mu s$	8,02	8,07	8,00		
$P_{DC}$	W	64,7	60,4	80,39		
$P_{DBE}$	W	54,3	47,6	59,56		
$S_{DC}$	kVA	2,06	$1,\!55$	3,14		
$P_{S1}$	W	3,81	5,41	10,54		
$P_{S2}$	W	1,70	4,51	2,71		
$P_{Tr}$	W	4,05	3,10	5,92		
I <sub>L RMS</sub>	А	5,15	6,22	8,98		
I <sub>L max</sub>	А	38,77	41,39	46,47		
I <sub>S1 RMS</sub>	А	4,01	4,88	6,90		
I <sub>S2 RMS</sub>	А	2,34	$3,\!57$	3,27		
ITr prim BMS	A	4.17	3.89	8.12		

**Tabelle 5.10:** Elektrische Größen im resonanten Betrieb für optimalen Gerätewirkungsgrad; f = 30 kHz;  $C_{inter} = 1000 \text{ pF}$ ;  $C_4 = 10 \text{ nF}$ ;  $R_{DSon} = 190 \text{ m}\Omega$ 

## 6 Messergebnisse

### 6.1 Verwendete Laborlampe

Bei der verwendeten Laborlampe handelt es sich um eine Dielektrisch Behinderte Entladungslampe der Firma Saint-Gobain. Die auf dem Markt erhältliche entsprechende Lampe heißt Planilum (Abbildung 6.1). Sie entspricht der Laborlampe, die bereits in Kapitel 3.3.4 benutzt wurde. Jedoch handelt es sich hier um die achtzehnfache Entladungsfläche, so dass alle kapazitiven Größen in diesem Verhältnis größer sind. Der prinzipielle Aufbau ist bereits in Abbildung 3.20 dargestellt. Die berechneten bzw. gemessenen Größen stehen in Tabelle 6.1.

Im unipolaren Pulsbetrieb der Lampe befindet sich die Zündspannung im Bereich zwischen 1900 V und 2200 V. In Abbildung 6.2 ist ein Spannungs- und Stromverlauf einer betriebenen Planilum zu sehen. Besonders ausgeprägt ist der Strom bei der zweiten Zündung oder Rückzündung zum Zeitpunkt 1,75E-05 s, der bis auf -6 A ansteigt. Die oszillierende Lampenspannung und der oszillierende Lampenstrom nach der Rückzündung kommt von der verbliebenen Restenergie, die bei dem Prinzip der behandelten Topologie nach Abbildung 6.3 nicht zurückgespeist werden kann.

## 6.2 Auswahl und Dimensionierung induktiver Bauelemente für das Puls-EVG

Die Transformatoren, die zur Untersuchung der Schalttopologie benutzt wurden, haben alle einen ETD 39 Kern der Firma Epcos mit dem Material N87. Dieses Material wurde ausgewählt, da dessen Frequenzbereich von den niedersten Frequenzen bis zu 500 kHz geeignet ist. Für die Übertragung von Pulsen erschien dieses Material am geeignetsten. Es wurden Transformatoren mit den Übersetzungsverhältnissen 2:1, 3:1, 4:1 und 5:1



Abbildung 6.1: Planilum - DBE Lampe der Firma Saint-Gobain

Größe	Wert	Einheit
Lampenabmessung	$600 \cdot 600$	$\mathrm{mm}^2$
Elektrodenfläche	$447 \cdot 447$	$\mathrm{mm}^2$
$C_{Lampe}$	600	$\mathrm{pF}$
C <sub>Barriere</sub>	1850	pF
$C_{Gap}$	889	pF
Uzuend,Pulsbetrieb	1900 bis 2200	V
Uzuend,Sinusbetrieb	ca. +/- 1100	V

Tabelle 6.1: Technische Größen der Planilum Laborlampe



Abbildung 6.2: Strom- und Spannungsverlauf an einer Planilum 60 cm x 60 cm

aufgebaut. Die elektrischen Größen der einzelnen Transformatoren stehen in Tabelle 6.2. Die Windungszahl für die Primärwicklung wurde so gewählt, dass sie so klein ist, dass der Transformatorkern gerade noch nicht in Sättigung gerät. Die minimale Windungszahl wurde deswegen angestrebt, um die Streuinduktivität der Transformatoren so klein wie möglich zu halten. Bei einer anliegenden Spannungszeitfläche  $\int U(t)dt$  sollte die vom Hersteller vorgegebene maximale Flussdichte  $B_{max}$  nicht überschritten werden, da der Kern andernfalls in Sättigung gerät.

$$B(t) = \frac{1}{n_1 \cdot A_C} \int U(t)dt \tag{6.1}$$

Die Flussdichte berechnet sich nach Gleichung 6.1, wobei n1 die primäre Windungszahl des Transformators ist und  $A_C$  der wirksame Kernquerschnitt. Für den benutzten Transformatorkern war  $A_C = 125 \text{ mm}^2$ , so dass sich bei einer maximalen Flussdichte von 400 mT und der primären Windungszahl  $n_1 = 10$ , eine maximale Spannungszeitfläche von ca.  $500 \cdot 10^{-6} \text{ Vs}$ ergibt. Die enge Dimensionierung des Kernvolumens wurde bewusst gewählt, da eine spätere Verwendung in einem kommerziellen Betriebsgerät sowohl die Kosten als auch die Handhabbarkeit bzw. die Größe berücksichtigen muss. Für den Transformator mit n1 = 8 (siehe Tabelle 6.2) konnten nicht alle Betriebsmodi untersucht werden, da bei längeren Spannungspulsen der Kern in Sättigung geriet.

Für die Speicherdrosseln wurde das Kernmaterial N87 und die Kernform RM14 ausgewählt. Ausschlaggebend für die Kernform waren die

Übersetzungsverhält-	2:1	3:1	4:1	5:1
nis				
Primärwicklung	10	10	10	8
Sekundärwicklung	20	30	40	40
Kernform	ETD39	ETD39	ETD39	ETD39
Material	N87	N87	N87	N87
Hauptinduktivität/ $\mu$ H	303,2	$297,\!3$	301,4	199,1
primäre Steuinduktivi- tät / $\mu {\rm H}$	0,43	0,34	0,34	0,22
primärer Wicklungswiderstand/ m $\Omega$	16	15	14	15
sekundäre Steuinduktivität / $\mu {\rm H}$	1,8	3,9	7,09	6,7
sekundärer Wicklungs- widerstand/ m $\Omega$	129,8	202,1	285,8	279,0

Tabelle 6.2: Technische Angaben der benutzten Transformatoren

Induktivität $[\mu H]$	2,42	4,17	6,13	12,16
Wicklungszahl	3	3	5	9
Wicklungswiderstand $[m\Omega]$	$10,\!6$	10,5	12,7	16,5
Kernform	RM14	RM14	RM14	RM14
Material	N87	N87	N87	N87

Tabelle 6.3: Technische Angaben benutzter Speicherdrosseln



Abbildung 6.3: Schaltplan des vermessenen unipolaren Pulsgeräts

großen Ströme (zwischen 40 A und 50 A) bei einer Induktivität im  $\mu$ H-Bereich. Eine Optimierung der Speicherdrosseln wurde hier nicht betrieben. Die elektrischen und mechanischen Größen der verschiedenen Speicherdrosseln sind in Tabelle 6.3 aufgeführt. Der Luftspalt der jeweiligen Drossel wurde so variiert, dass die gewünschte Induktivität erzielt wurde.

## 6.3 Messung und Diskussion der elektrischen Betriebsgrößen eines Puls-EVGs

Anhand eines Beispiels wird die Funktion des Betriebsgeräts erläutert. Der Schaltplan der untersuchten Schaltung ist in Abbildung 6.3 zu sehen. Es werden zunächst die gemessenen Ströme und Spannungen der einzelnen Bauelemente dargestellt (Abbildung 6.4) und danach für jedes Bauteil die wesentlichen Aspekte und die dazugehörigen Verluste aus Tabelle 6.5

Bauteil	Name / Grösse
D1, D3	CSD20060
D2	BYT03_400
S1	SPW47N60C3
S2	APT10053
$C_{Trenn}$	$1 \ \mu \mathrm{F}$
L, Trafo	je nach Angabe

Tabelle 6.4: Elektrische Bauteile der Schaltung

diskutiert.

Für die durchgeführten Messungen betrug die Zwischenkreisspannung 250 V. Die verwendeten Bauteile stehen in Tabelle 6.4. Für diese Messung wurde die Drossel mit der Induktivität  $4\,\mu\text{H}$  und der Transformator mit dem Ubersetzungsverhältnis 3:1 verwendet. In Abbildung 6.4 (a) ist der Strom- und Spannungsverlauf des oberen Schalters  $S_1$  zu sehen. Mit dem Einschalten dieses Schalters wird der Ladevorgang der Drossel L gestartet (Abbildung 6.4 (d)). Zu Beginn des Einschaltvorgangs von  $S_1$  gibt es kurzzeitig einen Spitzenstrom, der durch die Diode  $D_3$  verursacht wird (Abbildung 6.4 (b)). Die Diode wirkt hier als Kapazität, die beim Schließen von  $S_1$  kurzgeschlossen wird. Dadurch ergibt sich ein kurzer Peakstrom durch  $S_1$  mit einem Maximalwert von ca. 10 A. Die über die geflossenen Ladungsträger berechnete kapazitive Größe der Diode  $D_3$  beträgt hier 2,15 nF. Danach fließt durch  $S_1$  der Strom der auch durch die Drossel und den Schalter S<sub>2</sub> fließt. Nach dem Ladevorgang der Drossel wird der Schalter S<sub>2</sub> nichtleitend gemacht (Abbildung 6.5 (a)). Die Spannung am Transformator und an der Lampe steigen bis zur Lampenzündung an (Abbildung 6.5 (b), (c)). Bedingt durch die Resonanz des Systems Betriebsgerät-Lampe fließt nach Erreichen des Spannungsmaximums ein Strom von der Lampe über die Drossel und die Diode  $D_3$  in den Zwischenkreis (Abbildung 6.4 (b)). Abhängig von der Zwischenkreisspannung und der Güte des Rückspeisepfads können die Lampenspannung und die Spannung an S<sub>2</sub> bis auf null Volt sinken. Dies ist der ideale Fall, da dann keine Verluste durch ungenutzte Energie entsteht. Liegt während des Einschaltzeitpunkts von  $S_2$ noch Spannung an der Lampe und an  $S_2$  an, so bedeutet diese Spannung zusätzliche Verluste. In Tabelle 6.5 stehen die Verluste, die an den ein-



Abbildung 6.4: Spannungen und Ströme an den einzelnen Bauelementen;  $U_{DC} = 250 V$ 



Abbildung 6.5: Spannungen und Ströme an den einzelnen Bauelementen;  $U_{DC} = 250 V$ 

Bauteil	Einschalt- verluste	Ausschalt- verluste	Leitendverluste	Gesamt- verluste
	[W]	[W]	[W]	[W]
S1	0,25	0,62	0,70	1,57
L				1,91
S2	0,03	1,21	2,09	3,33
Tr				3,17
DBE				37,6
D 1				0,75
D 3				0,39
D 2				1,13
Summe				49,85
Eingang				51,70

Tabelle 6.5: Verteilung der gemessenen Verluste im Betriebsgerät

zelnen Bauelementen entstehen. Durch die Summe der einzelnen Verluste wird ein Gerätewirkungsgrad von ca. 73 % erreicht. Um die Verluste theoretisch aufzuschlüsseln, werden die einzelnen Bauteile nochmals separat betrachtet und die dazugehörigen Verluste diskutiert.

### Verluste an den Schaltern

Die Verluste an einem MOSFET-Schalter untergliedern sich in die Ein- und Ausschaltphasen und die Leitendphase. Dabei stehen der Durchlasswiderstand, die Spannungsfestigkeit und die Schaltgeschwindigkeit des Bauteils im Gegensatz zueinander. Um ein verlustfreies Einschalten des MOSFETs zu erreichen, muss seine Gate-Kapazität schnell geladen werden. Dabei ist es notwendig das Miller-Plateau möglichst schnell zu durchlaufen, so dass der Zeitbereich, in dem maximale Spannung anliegt und gleichzeitig maximaler Strom fließt, minimal ist. Der Leistungsumsatz im MOSFET kann während seines Schaltvorgangs reduziert werden, wenn durch äußere Beschaltung gewährleistet wird, dass kein Strom durch den MOSFET fließt. Befinden sich eine Kapazität parallel zum MOSFET-Schalter, so kann diese die Verluste des Ausschaltvorgangs reduzieren. Gleichzeitig geht jedoch

die Energie verloren, die während des Einschaltvorgangs auf dieser Kapazität gespeichert ist. Betrachtet man den Strom- und Spannungsverlauf des Schalters  $S_1$  in Abbildung 6.4 (a), so sieht man während des Einschaltvorgangs eine Stromspitze, die durch die Kapazität der parallel liegenden Diode  $D_3$  erzeugt wird. Durch die Drossel L wird der Stromfluss, der durch die Zwischenkreisspannung erzeugt wird, während des Einschaltvorgangs begrenzt, so dass hier nur geringe Einschaltverluste entstehen. Ausschaltverluste sind in diesem Schaltelement nur geringfügig, da geschaltet wird während kein Strom durch dieses Element fließt. Aufgrund der langsamen Inversdiode des MOSFETs wurde diese mit zwei schnellen Dioden  $(D_1)$ und  $D_3$ ) ausgeblockt. Lediglich die Energie, die auf der parasitären Kapazität der Diode  $D_1$  gespeichert ist, geht während des Ausschaltvorgangs verloren. Leitendverluste entstehen während der gesamten Ladezeit der Speicherdrossel und während die Kapazität der DBE geladen wird. Aus Tabelle 6.5 erkennt man, dass in diesem Bauteil die größten Verluste während der Leitendphase entstehen. Je größer die Kapazität der DBE wird, desto größer werden auch diese Verluste.

Im Schalter  $S_2$  verhalten sich Einschaltverluste zu Ausschaltverluste genau umgekehrt zu denen von Schalter  $S_1$ . Beginnend mit den Ausschaltverlusten wird während des maximalen Stromflusses der Schalter  $S_2$  ausgeschaltet (Abbildung 6.4 (e)). Die Einschaltverluste sind in diesem Beispiel gering, da der Schalter beinahe spannungslos einschalten kann. Dies ist nicht bei jeder Betriebsweise der Fall. Vor allem wenn eine ausgeprägte Rückzündung an der DBE erzeugt werden soll, muss  $S_2$  eingeschaltet werden während noch Spannung am Schalter anliegt.

Es folgt eine lange Leitendphase, in der die gesamte Restenergie, die noch im System vorhanden ist, abgebaut wird. Ein großer Teil dieser Energie wird im Schalter  $S_2$  in Wärme umgewandelt, d.h. die Verluste in dieser Phase werden um so größer, je mehr Restenergie im System verbleibt.

### Verluste in den Dioden

Um den Reverse-Recovery-Effekt zu minimieren, d.h. um die lange Phase zu minimieren, in der die Ladungsträger aus der Raumladungszone ausgeräumt werden müssen, wurden Silizium-Carbid-Dioden (Cree CSD20060) eingesetzt. Diese Dioden sind Schottky-Dioden. Bei ihnen ist die Speicherkapazität dominant [16], die (wie oben beschrieben) zusätzliche Einschaltverluste in den MOSFET-Schaltern verursachen. Die größten Verluste in den Dioden entstehen also lediglich in den Phasen, in denen Ströme in Flussrichtung fließen. Bei den Dioden hat die Diode D2 den größten Anteil, worin auch die Verluste begründet liegen.

#### Verluste in der Drossel und im Transformator

Prinzipiell bestehen die Verluste eines induktiven Bauelements aus den Kupferverlusten und den Verlusten im Ferritkern. Dabei kann sich der Widerstand der Kupferwindungen durch den Skin-Effekt und den Proximity-Effekt vergrößern. In diesem Beispiel wurde eine HF-Litze verwendet, bei der die benannten Verdrängungseffekte vernachlässigt werden. Die Verluste in der Kupferlitze lassen sich nach folgender Gleichung berechnen:

$$P_{Kupferverluste} = \frac{1}{T} \int I(t)^2 \cdot R \, dt \tag{6.2}$$

Aus dem Stromverlauf über eine Periode und dem angegebenen Ohmschen Widerstand von  $10,5 \,\mathrm{m}\Omega$  ergibt sich eine Verlustleistung von ca.  $100 \,\mathrm{m}W$ bei einer Betriebsfrequenz von  $30 \,\mathrm{kHz}$ . Die Hystereseverluste lassen sich aus dem Datenblatt aus Abbildung 6.6 abschätzen bzw. mit der Software zum Dimensionieren von Ferriten [35] berechnen. Hier werden die Verluste für eine gewisse Betriebsfrequenz und für einen Flussdichtehub angegeben. Nach Gleichung 6.1 ergibt sich die maximale Flussdichte beim Ladevorgang der Speicherdrossel:

$$B_{max} = \frac{250 \,\mathrm{V} \cdot 480 \,\mathrm{ns}}{200 \,\mathrm{mm}^2 \cdot 3} = 200 \,\mathrm{mT} \tag{6.3}$$

Dabei liegt für 480 ns eine Spannung von 250 V an der Drossel mit 3 Windungen an. Für eine maximale Flussdichte von 200 mT, einer Ferrittemperatur von 60°C und einer Frequenz von 30 kHz werden die Hystereseverluste mit [35] zu 113 kW/m<sup>3</sup> bestimmt. Das ergibt bei einem Kernvolumen von 14000 mm<sup>3</sup> Kernverluste von 1,58 W. In diesem Beispiel hat der Drosselstrom jedoch in einer Periode folgenden Verlauf (Abbildung 6.4 (d)): Der Strom steigt auf 22,8 A an, fällt danach auf -12,8 A, steigt nochmals auf 5,6 A an und sinkt dann auf 0 A. Mit der Annahme, dass die Flussdichte proportional zum Drosselstrom ist, ergeben sich in Tabelle 6.6 die Kernverluste für die Speicherdrossel bei einer Betriebsfrequenz von 30 kHz und unterschiedlichen Maximalströmen. Daraus ergibt sich ein theoretischer Werte der gesamten Kernverluste von ca. 1,91 W. Dieser Wert stimmt



Abbildung 6.6: Hystereseverluste des Kernmaterials N87 [36]

I <sub>max</sub>	B <sub>max</sub>	$P_{loss}/Volumen$ bei 30 kHz	$P_{loss}$
А	mΤ	$\rm kW/m^3$	W
22,8	200	113	$1,\!58$
12,8	112	20	0,28
$5,\!6$	50	$3,\!5$	0,05

**Tabelle 6.6:** Kernverluste der Speicherdrossel bei verschiedenen Maxi-<br/>malströmen und einer Betriebsfrequenz von 30 kHz und ei-<br/>ner Kerntemperatur von 60°C

sehr gut mit den gemessenen Verlusten aus Tabelle 6.5 überein.

Die Kernverluste des Transformators werden wieder über die angelegte Spannungs-Zeitfläche abgeschätzt. Bei diesem Beispiel beträgt das Spannungs-Zeit-Produkt an der Primärseite des Transformators ca.  $4,07 \cdot 10^{-4}$  Vs. Mit der Querschnittsfläche des Transformators von  $125 \text{ mm}^2$  und der primären Windungszahl von n1 = 10 ergibt sich nach Gleichung 6.1 eine maximale Flussdichte von 325 mT. Mit dem Berechnungsprogramm ergeben sich Kernverluste von 2,8 W, bei einer Flussdichte von 300 mT, einer Betriebsfrequenz von 30 kHz, einer Temperatur von  $60^{\circ}\text{C}$  und einem Kernvolumen von  $11500 \text{ mm}^3$ . Da die Ohmschen Verluste der Primär- und Sekundärwicklung sich zu 170 mW ergeben, kommt der theoretische Wert den gemessenen Transformatorverluste von 3,17 W (Tabelle 6.5) sehr nahe.

## 6.4 Einfluss von Speicherdrossel und Übersetzungsverhältnis auf den Gerätewirkungsgrad

In Kapitel 5.6 wurde mit Hilfe von Simulationen gezeigt, wie der Gerätewirkungsgrad des 2-Schalter-Prinzips durch Variation des Transformator-Übersetzungsverhältnis und der Speicherdrossel verbessert werden kann.

# 6.4.1 Variation von Transformator und Drossel bei konstantem Spannungsanstieg

Diese Aussage wird anhand einer Messreihe überprüft, bei der das Übersetzungsverhältnis des Transformators und die Induktivität der Speicherdrossel variiert wurden. Das Ziel ist es, Pulse zu erzeugen, deren Anstiegsflanken auf einen festen Wert eingestellt sind (Abbildung 6.7). Der Resonanzkreis aus Lampenkapazität und Drosselinduktivität schwingt resonant zurück, so dass die Lampenspannung gegen 0 V zurückgeht. Der Schalter S<sub>2</sub> (Abbildung 6.3) wird also erst dann geschlossen, wenn sich die Lampenspannung in ihrem ersten Minimum befindet. Die Einstellungen und Bauelemente für diese Messung stehen in Tabelle 6.7. In Abbildung 6.8(a) sieht man, dass die resonante Pulslänge mit steigendem Übersetzungsverhältnis und steigender Induktivität der Speicherdrossel größer wird. Die resonante Pulslänge wird hier als die Zeit zwischen Lampenzündung und



Abbildung 6.7: Resonanter Spannungspuls an der DBE

Schaltprinzip	2-Schalter	
S1	Infineon 47N60C3	
S2	APT10053	
C parallel S2	$3,3 \mathrm{~nF}$	
Betriebsfrequenz	30 kHz	
Lampe	Planilum 60 cm x 60 cm	
$C_{inter}$	0 F	
Zwischenkreisspannung $U_{DC}$	250 V	

Tabelle 6.7: Einstellungen für die Messung: Parametervariation vonÜbersetzungsverhältnis und Speicherdrossel


Abbildung 6.8: Variation von Transformatorverhältnis und Drosselinduktivität bei angestrebtem konstanten Spannungsanstieg

erstem Spannungsnulldurchgang definiert (Abbildung 6.7).

In Abbildung 6.8 (b) sieht man, dass es trotz des adaptiven Prinzips des Vorschaltgeräts nicht gelingt für alle Transformator-Drossel-Konstellationen die selbe Anstiegsflanke einzustellen. So ist die Resonanzfrequenz zwischen Lampe, Transformator und Speicherdrossel bei kleinem Übersetzungsverhältnis und kleiner Drosselinduktivität so groß, dass allein durch die Resonanz ein sehr steiler Spannungsanstieg erzeugt wird. Dieser steile Spannungsanstieg kann bei Elementdimensionierungen mit geringen Resonanzfrequenzen nicht mit größeren Vorladezeiten der Speicherdrossel erreicht werden. Bei konstantem dU/dt korreliert die Lampenleistung mit dem Übersetzungsverhältnis des Transformators und der Pulslänge. Deutlich wird, dass ein schneller Spannungsanstieg nicht unbedingt zu einer hohen Leistungseinkopplung in die Lampe führt. Bei der Konstellation Transformator mit  $\ddot{u} = 2:1$  und Speicherdrossel mit  $L = 2,3 \,\mu H$  steigt die Lampenspannung mit  $9.1 \,\mathrm{kV}/\mu\mathrm{s}$  an. Zum Zündzeitpunkt der Lampe ist aber keine Energie mehr in den induktiven Elementen gespeichert, so dass hier die geringste Leistung in die Lampe eingekoppelt wird. Daraus resultiert auch der geringste Gerätewirkungsgrad. Ist während des Zündzeitpunkts noch Energie in den induktiven Bauelementen vorhanden, die in die Lampe eingekoppelt werden kann, steigt die Lampenleistung auf Maximalwerte.

In Hinblick auf den Gerätewirkungsgrad steigt dieser mit sinkender Drosselinduktivität. Was verwundert sind die Gerätewirkungsgradmaxima bei der Drosselinduktivität mit  $L = 4 \mu H$  und den Transformatoren mit ü = 2:1 und 3:1. Möglicherweise wird hier eine lampeneigene Resonanz getroffen, die eine optimale Leistungseinkopplung ermöglicht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein guter Gerätewirkungsgrad bei kleiner Drosselinduktivität erreicht wird. Wichtig ist, wie in der Simulation bereits erwähnt, dass zum Zündzeitpunkt ausreichend Energie vorhanden ist und nach dem Löschen der Entladung keine weitere Energie auf die Lampenkapazität gebracht wird.

# 6.4.2 Variation von Transformator und Drossel bei konstanter Lampenleistung

Die in Kapitel 6.4.1 gemachte Parameterstudie wurde wiederholt (Abbildung 6.9). Dabei wurde nun bei ausschwingendem Lampenpuls und konstanter Zwischenkreisspannung von 250 V eine konstante Lampenleistung von 60 W eingestellt. Die Leistung wurde durch Variation der Anstiegsflanke eingestellt, d.h. durch Variation der Ladezeit der Drossel.

Es gelingt beinahe mit jeder Transformator-Drossel-Kombination die Lampe mit 60 W zu betreiben. Nur für die Kombination 5:1-Trafo und  $12 \,\mu$ H-Drossel gelingt dies nicht. Aufgrund der geringen Primärwicklung dieses Transformators und der kleinen Resonanzfrequenz, die eine große Pulslänge bedeutet, gerät der Transformatorkern in Sättigung. Dies war bei dieser Messung nicht erwünscht, so dass die Messwerte dieser Einstellung nicht aufgenommen wurden. Anstiegsgeschwindigkeit und Pulslänge der Lampenspannung haben einen Einfluss auf die eingekoppelte Lampenleistung. Je geringer die Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung ist, desto länger muss der Lampenpuls sein, um dieselbe Leistung in die Lampe einzukoppeln (Abbildung 6.10). Mit steigendem Übersetzungsverhältnis des Transformators sinkt der benötigte maximale Drosselstrom (Abbildung 6.9 (b)), um die gleiche Leistung in die Lampe einzukoppeln. Der Gerätewirkungsgrad sinkt hier mit zunehmendem maximalen Drosselstrom und somit auch mit wachsendem dU/dt des Spannungspulses (Abbildung 6.9 (b) bis (d)), d.h. der Ladevorgang der Drossel beeinflusst merklich den Gerätewirkungsgrad des Pulsgeräts.

#### 6.5 Einfluss der Zwischenkreisspannung auf den Gerätewirkungsgrad

Für das Hochsetzstellerprinzip gilt allgemein, dass der Gerätewirkungsgrad und die Leistung, die bereitgestellt werden kann, direkt mit der Einund Ausgangsspannung zusammenhängt. Je größer der Potentialunterschied zwischen Ein- und Ausgangsspannung ist, desto größer sind die Verluste und desto kleiner ist die Leistung, die auf der Ausgangsseite bereitgestellt werden kann. Aufgrund des kapazitiven Verhaltens der DBE hängt der Gerätewirkungsgrad für das hier untersuchte Schaltprinzip zusätzlich mit der Leistungsaufnahme der DBE zusammen. Um den Zusammenhang zwischen Gerätewirkungsgrad und Eingangsspannung zu erhalten, wurde die Zwischenkreisspannung in 25 V Schritten erhöht. Zusätzlich wurde der maximale Drosselstrom so variiert, dass die eingekoppelte Lampenleistung bei 40 W konstant bleibt. Die Pulslänge wurde so eingestellt, dass ein resonantes Rückschwingen möglich ist und erst im Spannungsminium der



Abbildung 6.9: Variation von Transformator und Drossel bei 60 W Lampenleistung



Abbildung 6.10: Spannungsanstieg über Pulslänge bei 60 W Lampenleistung

Schalter S2 geschlossen wird (siehe Abbildung 6.7).

Das Ergebnis der Variation der Eingangsspannung ist in Abbildung 6.11 aufgetragen. Die Lampenleistung ist auf 40 W konstant gehalten. Der Gerätewirkungsgrad steigt mit zunehmender Zwischenkreisspannung auf das Maximum von 79% bei einer Spannung von  $225\,\mathrm{V}$ an und sinkt danach wieder. Laut der Aussage im Kapitel Simulation liegt die Ursache für einen geringen Gerätewirkungsgrad an der geringen Zwischenkreisspannung. Im Bereich 100 V bis 200 V werden hier die größten Verluste in der Drossel und den Schaltern S1 und S2 erzeugt. Da zum Betrieb der Lampe ein größerer Spitzenstrom in der Drossel benötigt wird (Abbildung 6.12 (b)), ergeben sich automatisch größere Leitend- und Schaltverluste in den MOSFET-Schaltern. Die größeren Verluste für die Drossel liegen aufgrund der stärkeren magnetischen Aussteuerung in den Hystereseverlusten. Der sinkende Gerätewirkungsgrad bei Zwischenkreisspannungen über 225 V hängt mit der länger anliegenden Spannung an der DBE zusammen, die automatisch zu höheren Verlusten im Transformator führt, d.h. um das System zu optimieren muss zunächst der Transformator für eine Zwischenkreisspannung von 400 V ausgelegt werden. Zusätzlich kann durch die höhere Zwischenkreisspannung die Spannung an der DBE nicht ganz auf Null zurückgehen, so dass die verbleibende Energie hauptsächlich im



(a) Gerätewirkungsgrad in Abhängigkeit der Zwischenkreisspannung



(b) Verluste in Schaltern S1 und S2; Effektivströme über S1 und S2



(c) Verluste in Transformator und Drossel in Abhängigkeit von der Zwischenkreisspannung U DC

Abbildung 6.11: Variation der Zwischenkreisspannung bei konstanter Lampenleistung



#### (a) Lampenspannung



(b) Drosselstrom

#### Abbildung 6.12: Variation der Zwischenkreisspannung bei konstanter Lampenleistung

Schalter S2 in Wärme umgesetzt wird. Dazu sind in Abbildung 6.11 (b) und (c) zu den verschiedenen Zwischenkreissspannungen die Verluste der Schalter S1, S2, Drossel und des Transformators aufgetragen.

# 7 Betrieb von Xe-Excimer Lampen am Puls-EVG mit verschiedenen Betriebsarten

#### 7.1 Variation des zeitlichen Spannungsanstiegs

Um das Verhalten von Lampe und Betriebsgerät in Hinsicht auf Variation der Lampenleistung zu untersuchen, wurden zwei Messreihen durchgeführt. Die Lampenleistung wurde über den maximalen Drosselstrom eingestellt. Der Spannungspuls, der an der Lampe anliegt, schwingt jeweils resonant zurück bevor der Schalter S2 geschlossen wird. Bei der ersten Messreihe befindet sich nur die DBE als Last am Betriebsgerät. Bei der zweiten Messreihe ist parallel zur Lampe eine Pufferkapazität  $C_{inter}$  angebracht, die zum Zeitpunkt der Lampenzündung einen zusätzlichen Strom bereitstellt.

#### Variation der Anstiegsflanke ohne Cinter

Durch unterschiedlich langes Laden der Speicherdrossel kann die eingekoppelte Lampenleistung variiert werden. In Abbildung 7.1 (a) sieht man, dass zwischen dem maximalen Drosselstrom und der eingekoppelten Lampenleistung ein linearer Zusammenhang besteht. Die Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung hat ungefähr denselben Verlauf wie der maximale Drosselstrom. Der lineare Bezug zur Lampenleistung ist hier jedoch nicht so genau wie bei der Stromspitze des Drosselstroms. Um auf die Lampenleistung regeln zu können, würde sich der maximale Drosselstrom als geeignete Größe anbieten, vor allem da diese Größe sehr leicht erfassbar ist. In Abbildung 7.1 (b) sieht man, dass mit zunehmender Lampenleistung der Gerätewirkungsgrad absinkt.



(a) maximaler Drosselstrom; Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung



(b) Gerätewirkungsgrad

Abbildung 7.1: Variation der Lampenleistung ohne  $C_{inter}$ ;  $U_{DC} = 250 \text{ V}$ ; Trafo: 3:1; Drossel:  $4 \, \mu \text{H}$ 



(a) maximaler Drosselstrom; Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung



(b) Gerätewirkungsgrad

Abbildung 7.2: Variation der Lampenleistung mit  $C_{inter}$ ;  $C_{inter} = 1,33 \text{ nF}$ ;  $U_{DC} = 250 \text{ V}$ ; Trafo: 3:1; Drossel:  $4 \mu H$ 

#### Variation der Anstiegsflanke mit Cinter

Dieselbe Messung wurde mit einer Kapazität  $C_{inter} = 1,33 \text{ nF}$  wiederholt, die parallel zur Lampe angeschlossen war. Zunächst sieht man in Abbildung 7.2 (a), dass, im Vergleich zur Messung ohne Parallelkapazität, ein größerer maximaler Drosselstrom benötigt wird, um dieselbe Leistung in die DBE einzukoppeln. Wurde für eine Lampenleistung von 70 W ein maximaler Drosselstrom von ca. 35 A benötigt, wenn sich keine Kapazität parallel zur Lampe befindet, so ist bei einer Parallelkapazität von 1,33 nF ein maximaler Drosselstrom von ca. 40 A notwendig. Auch hier hängen der Verlauf des maximalen Drosselstroms und die Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung mit der Lampenleistung linear zusammen. Der Gerätewirkungsgrad ist im Vergleich zum Betrieb der Lampe ohne Paral-



Abbildung 7.3: Variation der Pulsweite

lelkapazität um ca. 10% geringer.

#### 7.2 Variation der Pulsweite

Um das Verhalten von Betriebsgerät und Lampe in Abhängigkeit von der Pulsweite zu untersuchen, wurde die Einschaltzeit von S2 Schritt für Schritt verkürzt, ohne dass an den restlichen Schaltzeiten eine Veränderung vorgenommen wurde (Abbildung 7.4). Das Ergebnis ist in Abbildung 7.3 zu sehen. Dabei wurde die Pulslänge zu Beginn so eingestellt, dass der Schwingkreis aus Drossel und Lampenkapazität eine resonante Schwingung durchführen kann. Danach wurde der Spannungspuls an der Lampe durch hartes Schalten immer weiter verkürzt, bis die erste Lampenzündung und das Schalten von S2 zeitlich zusammenfällt. Zunächst sieht man, dass die eingekoppelte Systemleistung mit Verkürzung des Spannungspulses ansteigt. Einer der Gründe ist, dass die Energie, die auf der Lampenkapazität sitzt, nicht mehr resonant in den Zwischenkreis zurückgespeist werden kann. Die Lampenkapazität wird mit dem Schalter S2 kurzgeschlossen und die verbleibende Energie wird an den Bauteilen des Betriebsgeräts in Wärme umgesetzt. Erstaunlicher ist, dass sich die eingekoppelte Lampenleistung bei Reduzierung der Pulslänge um ca. 1/3 erhöht, d.h. bei der



Abbildung 7.4: Oszillierende Lampenspannung in Abhängigkeit von der Pulsweite

abfallenden Spannungsflanke an der DBE kann nochmals Leistung in die DBE eingekoppelt werden. Dieser Effekt hat einen plasmaphysikalischen Hintergrund, der in dieser Arbeit nicht behandelt wurde. Mit Verkürzen der Pulslänge wird bei einer Pulslänge von 800 ns ein Betriebspunkt erreicht, bei dem die Lampenspannung nur minimal ausschwingt. Dies ist in Abbildung 7.4 dargestellt. Der Grund hierfür ist, dass zum Schaltzeitpunkt von S2 keine Energie auf der DBE gespeichert ist. Dadurch ist in dem System DBE - Transformatorstreuinduktivität die geringste Energie, so dass es nur zu sehr geringem Nachschwingen kommt.

# 7.3 Variation der Leistungszufuhr nach Zündung der DBE

Um den entscheidenden Zeitpunkt der Leistungseinkopplung in die Lampe zu finden, wurde die Lampe mit einem resonant ausschwingenden Spannungspuls betrieben. Über die Ladezeit der Speicherdrossel wurde die



(c) Abhängigkeit des Gerätewirkungsgrads von der Schaltzeit TE1

Abbildung 7.5: Variation der Leistungszufuhr nach der Lampenzündung

Lampenleistung eingestellt. Nun wurde die Schaltdauer TE1 (Abbildung 7.5 (a)) des Schalters S1 (Abbildung 6.3) um jeweils 100 ns verkürzt. Dadurch wird die Zeit verkürzt, in der Energie zur Lampe fließen kann. Dies wurde für drei verschiedene Anfangsleistungen gemacht. Man sieht, dass sich bis zu einer gewissen Schaltdauer TE1 die Lampenleistung nicht verändert. Berücksichtigt man, dass bei TE1 = 0 ns die Lampenspannung zu steigen beginnt, und die Zeit bis die Zündspannung erreicht wurde ca. 250 ns beträgt, so ist ersichtlich, dass bei einer Entladungsdauer von ca. 50 bis 100 ns die Lampenleistung oberhalb einer Zeit TE1 = 300 ns konstant bleibt. Wird diese Zeit jedoch unterschritten, so wird die Energie, die für die Entladung zur Verfügung steht, reduziert (Abbildung 7.5 (b)). Die eingekoppelte Lampenleistung sinkt. Parallel dazu sinkt auch der Gerätewirkungsgrad, da die Energie, die bereits in das Betriebsgerät eingekoppelt wurde, nicht mehr in der Lampe umgesetzt werden kann.

## 7.4 Vergleich: Leistungseinkopplung durch Einfachzündung und Doppelzündung

Wie bereits in Kapitel 7.2 beschrieben, kann durch Verkürzen des Spannungspulses an der Lampe die Leistungseinkopplung erhöht werden. Dies geschieht dadurch, dass bei der abfallenden Flanke der Lampenspannung die Lampe ein zweites Mal gezündet werden kann. Die exakte Bedingung und der plasmaphysikalische Hintergrund für die zweite Zündung (Rückzündung) ist bis jetzt noch nicht ausreichend untersucht. Jedoch wurden beim Effekt der Rückzündung bereits mehrere Messungen an den inneren Größen durchgeführt [31]. Dabei stellte sich heraus, dass dieser Effekt um so deutlicher wurde, je kürzer die Zeitspanne war, nach der die Spannung an der Lampe nach der ersten Zündung anlag. Der Zeitraum bewegt sich im Bereich von ca. 100 ns nach Lampenzündung bis ca. 1000 ns nach Lampenzündung. Um festzustellen, ob dieser Effekt der Rückzündung für das Betriebsgerät von Vorteil sein kann, wurde die Lampenleistung schrittweise erhöht. Dabei wurde die Lampenleistung auf zwei unterschiedliche Arten eingestellt. Zum Einen durch das ausreichende Laden der Speicherdrossel, so dass die gesamte Energie während der ersten Lampenzündung in die Lampe eingekoppelt wurde. Die andere Variante bestand darin, dass ca. 2/3 der gewünschten Lampenleistung in der ersten Zündung beim Spannungsanstieg eingekoppelt wurde. Dann wurde die Pulslänge so weit



Abbildung 7.6: Vergleich: Leistungseinkopplung 80 W durch resonanten Puls bzw. Einfachzündung (schwarz) und angeschnittenen Puls bzw. Doppelzündung (grau)

reduziert, dass die gewünschte Lampenleistung erreicht wurde. In Abbildung 7.6 (a) bis (c) sind die Lampenspannung, der Lampenstrom und die Lampenleistung bei einer Systemleistung von 80 W, jeweils mit Einfachzündung (resonantes Ausschwingen) und Doppelzündung (angeschnittener Puls) dargestellt. Abbildung 7.6 (d) zeigt das Verhalten des Gerätewirkungsgrads. Der Gerätewirkungsgrad ist bei der Doppelzündung um ca. 8% bis 10% geringer als bei der Einfachzündung. Der Grund dafür liegt darin, dass bei der Einfachzündung ein Großteil der Energie, die auf der DBE gepeichert ist, durch resonantes Rückschwingen in den Zwischenkreis zurückgespeist werden kann. Dies ist bei der Doppelzündung nicht möglich. Die nach der Rückzündung im System noch vorhandene Restenergie geht in Wärme verloren. Von Vorteil ist, dass bei der Doppelzündung ein nicht so großer maximaler Drosselstrom benötigt wird, wodurch geringere Leitend- und Ausschaltverluste in den Schaltern entstehen. Wie beschrieben wirkt sich dies jedoch nicht positiv auf den Wirkungsgrad aus.

#### 7.5 Vergleich homogene - filamentierte Betriebsart

Um eine homogene Entladung, d.h. eine flächenfüllende, zeitlich synchronisierte Entladung in einer DBE zu erhalten, muss dafür gesorgt werden, dass während der Lampenzündung ein ausreichend großer Strom in die Lampe bzw. in die Entladung nachfließen kann. Ist der zeitliche Zufluss von Ladungsträgern beschränkt, so besteht die Entladung aus einzelnen Filamenten. Wird nun der Zufluss von Ladungsträgern erhöht, so weiten sich die einzelnen Entladungen auf, bis eine flächenfüllende Entladung entsteht. Diese homogene Entladung existiert jedoch nur bei hoher Leistungseinkopplung pro Pulsperiode. Im Gegensatz zu dieser homogenen Entladung existiert ein weiterer homogener Betrieb bei geringen Pulsleistungen und geringen Betriebsfrequenzen. Hier muss gewährleistet werden, dass bei Lampenzündung keine weiteren Ladungen auf die Lampenkapazität fließen. Die Energie für diese Entladungsart ist vor der Zündung bereits auf der Lampenkapazität deponiert. Mit exakt denselben Betriebsparametern kann aber auch eine filamentierte Betriebsart erreicht werden. Um die homogene Betriebsart zu erreichen, wird bei unveränderter Ansteuerung der Halbleiterschalter, die Zwischenkreisspannung erhöht bis die Lampe schwach aber flächendeckend homogen leuchtet. Wird die Zwischenkreiss-



Zeit [s]

#### (a) Lampenspannung und Gapspannung



(b) Lampenstrom



pannung weiter erhöht, so kippt die Entladung in eine filamentierte Entladung um. Bei Reduzieren der Zwischenkreisspannung auf die ursprüngliche Spannung, bei der ein homogener Betriebsszustand existierte, bleibt der filamentierte Zustand bestehen. Um wieder in den homogenen Betrieb zu gelangen, muss die Zwischenkreisspannung weiter reduziert werden, bis die Entladung wieder schlagartig in die homogene Entladung umspringt. Für beide Betriebsarten wurde die gleiche Lampenleistung (30 W) und der gleiche Gerätewirkungsgrad gemessen (60%). In Abbildung 7.7 sieht man, dass bei exakt gleichem Spannungsanstieg die äußere und innere Lampenspannung im filamentierten Betrieb früher einbricht als im homogenen Betrieb. So beträgt die äußere Zündspannung für den filamentierten Betrieb ca. 1880 V und im homogenen Betrieb 1960 V. Zudem ist die Entladungsdauer, d.h. die Dauer in der die Gapspannung einbricht, im filamentierten Betrieb länger als im homogenen Betrieb. Die Ursache für dieses unterschiedliche Verhalten liegt in der Stromdichte, die bei der homogenen Entladung wesentlich höher ist, als im filamentierten Betrieb. Welche Startbedingungen jedoch zu einer homogenen oder filamentierten Entladungsform führen, ist noch nicht vollständig bekannt.

# 7.6 Lampenwirkungsgrad in Abhängigkeit von verschiedenen EVG-Betriebsgrößen

Mit dem Betriebsgerät mit 2 Schaltern wurde der Lampenwirkungsgrad sowohl bei homogenem als auch bei filamentiertem Lampenbetrieb untersucht [31]. Wie in Kapitel 7.2 wurde auch bei dieser Untersuchung die Pulsweite variiert und dabei die Leuchtdichte und der Lichtstrom gemessen, so dass damit auf die Lampeneffizienz geschlossen werden kann. Diese Messung wurde an einer 30 cm x 30 cm Planilum-Laborlampe durchgeführt. Der Druck betrug p = 150 mbar bei einem Xenon-Neon-Mischverhältnis 1:1. Die Wiederholfrequenz des Spannungspulses betrug 30 kHz. Mit Verkürzen der Pulsdauer konnte eine homogene Entladung der Lampe erreicht werden. Wie in Abbildung 7.8 zu sehen, steigt die Leuchtdichte ausgehend vom filamentierten Betrieb hin zum homogenen Betrieb um ca. 50% an. Die betriebene Lampe besitzt einen Entladungsbereich mit Phosphorschicht und einen ohne. Deswegen bilden sich im Parameterbereich TT1 = 1500 ns bis 3000 ns unterschiedliche Entladungsformen für den Phosphorbereich und den Glasbereich aus. Der Lampenwirkungsgrad



Abbildung 7.8: Leuchtdichte in Abhängigkeit von TT1 [31]



Abbildung 7.9: Lampenwirkungsgrad in Abhängigkeit von TT1 [31]

weist das gleiche Verhalten wie die Leuchtdichte auf. Mit Verkürzen des Spannungspulses steigt die Effizienz an (Abbildung 7.9). Dabei bleibt der Lampenwirkungsgrad im homogenen Bereich stabil bei ca. 14 lm/W, während die Leuchtdichte durch Verkürzen der Pulslänge noch gesteigert werden kann. Durch Erhöhung des Druckes bei reinem Xenon konnte am Lichttechnischen Institut, zum Zeitpunkt dieser Arbeit, mit dem beschriebenen Betriebsgerät ein Lampenwirkungsgrad von bis zu 33 lm/W bei einer Leuchtdichte von 11000 cd/m<sup>2</sup> nachgewiesen werden [37].

Wie in mehreren Veröffentlichungen bereits erwähnt, ist der Lampenwirkungsgrad bei Sinusanregung und Rechteckanregung abhängig von der Betriebsfrequenz [6], [14]. Mit zunehmender Betriebsfrequenz sinkt der Lampenwirkungsgrad. Dies ist auch bei dem hier beschriebenen Pulsbetrieb der Fall. Es wurden Messungen an einer DBE in koaxialer Bauform gemacht, die in Kapitel 7.8 beschrieben wird. Diese wurde mit unipolaren Spannungsflanken angeregt. Die Betriebsfrequenz wurde dabei variiert. Es zeigt sich (Abbildung 7.10), dass die Leistungseinkopplung und der Lichtstrom mit ansteigender Betriebsfrequenz zunehmen. Jedoch steigt die eingekoppelte Lampenleistung stärker an als der Lichtstrom, so dass der Lampenwirkungsgrad mit zunehmender Betriebsfrequenz sinkt. Aufgrund des Gerätewirkungsgrads, der mit zunehmender Frequenz ansteigt<sup>1</sup>, und des gleichzeitig sinkenden Lampenwirkungsgrads, sinkt der Systemwirkungsgrad in diesem Frequenzbereich nur leicht.

## 7.7 Vergleich mit einem auf dem Markt erhältlichen System

Um einen Vergleich der Leistungsfähigkeit des adaptiven Pulsgeräts zu machen, wurde eine Planon 15" der Firma Osram zum Einen mit dem mitgelieferten Betriebsgerät und zum Anderen mit dem adaptiven Pulsgerät betrieben und vermessen. In Abbildung 7.11 sind elektrische und lichttechnische Größen gegenübergestellt. Wenn die Planonlampe mit dem mitgelieferten Betriebsgerät betrieben wurde, emittierte diese 950 lm, bei einer Betriebsfrequenz von 65 kHz. Um einen Vergleich zu ermöglichen, wurde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Der Gerätewirkungsgrad steigt mit zunehmender Betriebsfrequenz an. Dies liegt an der Speicherdrossel, die bei ausreichend hoher Frequenz nicht vollständig entmagnetisiert wird. Für den darauffolgenden Puls muss nicht so viel Energie aufgewendet werden, um die Speicherdrossel auf den Maximalstrom aufzuladen.



(a) Abhängigkeit des Lichtstroms, der Lampenleistung und des Lampenwirkungsgrads von der Betriebsfrequenz



(b) Abhängigkeit des Gerätewirkungsgrads, des Lampenwirkungsgrads und des Systemwirkungsgrads von der Betriebsfrequenz

Abbildung 7.10: Variation der Betriebsfrequenz an einer DBE in koaxialer Bauform (Kapitel 7.8)



Abbildung 7.11: Vergleich: Adaptives Betriebsgerät für unipolare Pulse und Planon Betriebsgerät

das adaptive Betriebsgerät für unipolare Pulse so eingestellt, dass die Planonlampe auch bei diesem Gerät einen Lichtstrom von 950 lm emittierte. Dies wurde bei einer Betriebsfrequenz von 31 kHz erreicht. Die Eingangsleistung der beiden System unterschied sich nur unwesentlich. Bei dem hier entwickelten Gerät betrug sie 39 W, bei dem Planon-Gerät betrug sie 43 W. Jedoch hat das adaptive Betriebsgerät bei dieser Messung einen Gerätewirkungsgrad von 72%. Demgegenüber steht das Planon-Gerät mit 88% Gerätewirkungsgrad. Das adaptive Betriebsgerät erzeugt den gleichen Lichtstrom mit einer geringeren Lampenleistung im Vergleich zu dem Planon-Gerät. Dieselbe Lampe wird somit einmal mit einem Lampenwirkungsgrad von 34 lm/W und zum andern mit einem Lampenwirkungsgrad von 25 lm/W betrieben. Der Systemwirkungsgrad der beiden Betriebsgerät-Lampe-Systeme unterscheidet sich unwesentlich. Dies geschieht bei dem adaptiven Betriebsgerät mit einem mäßigen Gerätewirkungsgrad und einem guten Lampenwirkungsgrad. Bei dem mitgelieferten Osram-Betriebsgerät ist der Gerätewirkungsgrad gut und der Lampenwirkungsgrad mäßig.



(a) nicht betrieben (b) betrieben

Abbildung 7.12: Koaxiallampe

## 7.8 Adaptivität des Betriebsgeräts

Um das adaptive Verhalten des Betriebsgeräts zu untersuchen, wurden an dem Betriebsgerät eine bis vier DBE-Lampen betrieben. Bei den Lampen handelte es sich um DBE in Koaxialbauweise, die mit Leuchtstoffen beschlämmt wurden (Abbildung 7.12). Dabei betrug die Lampenkapazität einer ungezündeten Lampe ca. 48 pF. Die Leistungszufuhr wurde so eingestellt, dass in jede Lampe 10 W eingekoppelt wurde, d.h. bei einer Lampe betrug die Lampenleistung 10 W bei einer kapazitiven Last von 48 pF. Bei zwei Lampen betrug die Lampenleistung 20 W bei einer kapazitiven Last von 96 pF, usw.

In Abbildung 7.13 (a) sieht man, dass zum Einkoppeln eines konstanten Verhältnisses von Lampenleistung zu Lampenkapazität ein konstanter Spannungsanstieg der Lampenspannung notwendig ist, wenn der Spannungspuls resonant zurückschwingt. Diese Größe ermöglicht es, bei gleichartigen DBE-Lampen, auf eine konstante Lampenleistungsdichte zu regeln, ohne dass bekannt ist, wie viele Lampen an dem Betriebsgerät angeschlossen sind bzw. welche kapazitive Größe die Last hat.

In Abbildung 7.13 (c) sieht man, wie der Drosselstrom zunimmt, wenn bei zunehmender Lampenkapazität die Lampenleistungsdichte konstant

bleibt. Zusammenfassend ist in Abbildung 7.13 (d) der Zusammenhang zwischen Gerätewirkungsgrad, Lampenleistung, Geräteleistung und maximaler Drosselstrom über der Lampenanzahl dargestellt. Alle Größen verhalten sich linear, bis auf den Gerätewirkungsgrad, der konstant bei 60% bleibt.

Somit ist es möglich mit dieser Topologie DBE-Lampen mit unterschiedlich großen Kapazitäten bei konstanter Lampen-Leistungsdichte zu betreiben.



Drosselstrom und Gerätewirkungsgrad über Lampenanzahl

Abbildung 7.13: Adaptivität des Betriebsgeräts

## 8 Diskussion der Ergebnisse

In dieser Arbeit wurde ein neuartiges Schaltungskonzept entwickelt und untersucht, um DBE-Lampen zu betreiben. Das Ziel bestand darin, eine Topologie zu entwickeln, mit der es möglich ist, effizient gleichartige DBE-Lampen zu betreiben, die sich in ihrer Fläche, d.h. in ihrer Kapazität, unterscheiden. Dabei ist es notwendig, dass die Wanddicke, der Gapabstand und die Gasfüllung gleich bleiben. Die Aufgabenstellung wurde mit einer neuartigen Topologie gelöst (Abbildung 6.3), die zeitweise als Stromquelle arbeitet (Kapitel 4.1.2). Der Strom, den diese Stromquelle liefert, ist über das "Timing" der digitalen Ansteuersignale für die Leistungshalbleiter einstellbar. Somit kann allein durch Anpassen des Schaltmusters die gewünschte Anstiegsflanke der Lampenspannung eingestellt werden. Desweiteren kann über das Kurzschließen der Lampenkapazität eine weitere Zündung, die Rückzündung, in der Lampe erzeugt werden. Wie in Kapitel 7.2 gezeigt, hängt diese stark davon ab, wie groß die Zeitspanne zwischen der ersten Zündung und dem Kurzschließen der Lampenkapazität ist.

### 8.1 Geräteeffizienz

Mit diesem Gerät konnte in anderen Arbeiten bei Pulsbetrieb und einer Betriebsfrequenz von 20 kHz, Lampenwirkungsgrade von bis zu 32 lm/W bei Strahldichten von 7500 cd/m<sup>2</sup> und weiß emittierendem Leuchtstoff [37] nachgewiesen werden. An einer Planon wurden 34 lm/W erreicht. Resonant schaltende Topologien, die genau auf eine Last, d.h. auf eine DBE-Lampe, angepasst werden, sind unter dem Gesichtspunkt des elektrischen Gerätewirkungsgrads deutlich im Vorteil. So werden bei reiner Sinusanregung Gerätewirkungsgrade von ca. 90% erreicht. Das Pulsgerät aus Abbildung 2.9 erreicht einen elektrischen Gerätewirkungsgrad von 88% [20]. Die Gründe für das schlechtere Abschneiden des adaptiven Betriebsgeräts in Hinblick auf den elektrischen Gerätewirkungsgrad sind vielfältig:

• Verluste in der Speicherdrossel:

Durch die hohen Maximalströme von bis zu ca. 40 A, die in der Speicherdrossel fließen, wird der Kern stark aufmagnetisiert. Durch das Kernvolumen entstehen Ummagnetisierungsverluste.

• Verluste im Transformator:

Für den Bau des Transformators wurden mehrere Ziele verfolgt. Das Kernvolumen sollte nicht allzu groß sein; es sollte gewährleistet werden, dass kein Spannungsüberschlag im Transformator auftritt; die Streuinduktivität sollte so gering wie möglich sein, damit steile Spannungsanstiege realisiert werden konnten. Diese Punkte führten dazu, dass die Flussdichte im Kern, abhängig von der Pulslänge und der Eingangsspannung, nahe an der Sättigung betrieben wurde. Dies bedeutet zusätzliche Verluste. Ein weiteres Problem bestand darin, eine Lösung zu finden, wie die Energie des aufmagnetisierten Transformatorkerns gespeichert bzw. zurückgewonnen werden konnte. Diese Energie geht in diesem Konzept verloren. Durch Variation von Parametern konnte der Gerätewirkungsgrad bei relativ geringer Leistungseinkopplung auf bis zu 78% optimiert werden. So können beispielsweise durch eine geeignete Wahl der Zwischenkreisspannung die Verluste in Drossel und Transformator minimiert werden (Abbildung 6.11 (c)).

• Verluste in den MOSFET-Schaltern:

Solange nicht resonant geschaltet wird, können die Verluste in den Schaltern dieser Topologie nicht merklich reduziert werden. Es kann nur darauf geachtet werden, dass der Schaltvorgang möglichst schnell durchgeführt wird und dass die Leitendwiderstände der Schalter möglichst gering gehalten werden.

• Verluste durch Restenergie auf der Lampenkapazität:

Ein weiteres nur partiell gelöstes Problem ist die Restenergie auf der Lampenkapazität. Diese kann nur dann teilweise zurückgewonnen werden, wenn ein resonantes Rückschwingen in die Zwischenkreisspannung ermöglicht wird. Dadurch kann jedoch keine ausgeprägte Rückzündung generiert werden. Die Leistungseinkopplung in die Lampe sinkt (Kapitel 7.2) und damit die Leuchtdichte und das homogene Entladungsverhalten (Abbildung 7.8). Zu Beginn dieser Arbeit war unklar, welche Betriebsweise geeignet ist, um eine DBE-Lampe in planarer Bauweise (Abbildung 1.2 (a)) zum einen effizient und zum andern homogen betreiben zu können. Eine geeignete Betriebsweise konnte durch Erprobung dieser entwickelten Topologie erforscht werden [31], [38], [10]. Vor allem die flexible Einstellbarkeit von Hochspannungspulsen (Pulslänge, Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs, Spannungshöhe) machten dies möglich.

Gleichzeitig stellte sich heraus, dass das Verhältnis von Leistungsaufnahme der DBE zu Lampenkapazität eine entscheidende Rolle für den Gerätewirkungsgrad spielt. Hat die DBE eine große Lampenkapazität, so muss das Betriebsgerät einen hohen Ladestrom liefern, damit ein geeigneter Spannungsanstieg erzeugt werden kann. Dadurch entstehen Verluste im Betriebsgerät. Je mehr Energie, während der Entladung, in die Lampe eingekoppelt werden kann, desto besser kann der Gerätewirkungsgrad werden. Aus dem Blickwinkel eines Betriebsgeräts hat die ideale DBE-Lampe eine kleine Lampenkapazität und eine große Leistungsaufnahme. (Das Optimum wäre eine Gasentladungslampe mit innen liegenden Elektroden, was dann natürlich keine DBE mehr ist.)

Dem großen Gewinn dieser Schaltung, der Adaptativität auf unterschiedlich große Lampenkapazitäten, steht der Nachteil im Hinblick auf den Gerätewirkungsgrad gegenüber. Die Verluste, die während des Vorladens in der Speicherdrossel und in den Leistungshalbleitern entstehen, sind rel. groß, so dass ein Gerätewirkungsgrad bei geringen Lampenleistungen (30 W bei der Planilum Lampe aus Abbildung 6.1) kaum besser als 80%werden kann. Wie in Kapitel 7.7 zu sehen, kann das adaptive Betriebsgerät, trotz der Verluste in Hinsicht auf den Systemwirkungsgrad mit kommerziell erhältlichen Betriebsgeräten Schritt halten. Der Systemwirkungsgrad liegt hierbei bei 24 lm/W. Der Betrieb mit einer Parallelkapazität ergab, dass die Leistungseinkopplung mit dieser erhöht werden kann. Jedoch bedeutet dies für das Betriebsgerät nach Gleichung 5.15 erhöhte Verluste, so dass der Systemwirkungsgrad sinkt. Die Untersuchung der Adaptivität ergab weiterhin, dass sowohl die Lampenleistung als auch die Entladungserscheinung der DBE nicht allein von dem Spannungsanstieg der Lampenspannung abhängig ist. Weitere Parameter, die die Entladung beeinflussen, sind der Strom, der während der Entladung in die Lampe eingekoppelt wird (Kapitel 7.3), die Pulslänge der Lampenspannung (Kapitel 7.2) und die sich daraus ergebende abfallende Spannungsflanke. Aufgrund der vielen Parameter, die das Entladungsverhalten beeinflussen, ist es schwierig, den optimalen Betriebsmodus für das System DBE-Betriebsgerät anzugeben. Mit steigender Leuchtdichte bzw. Lichtstrom, d.h. steiler Spannungsflanke und angeschnittenem Spannungspuls, sinkt der Gerätewirkungsgrad. Somit ist der optimale Betrieb für das hier entworfene Betriebsgerät immer ein Kompromiss zwischen elektrischem Wirkungsgrad und Lampenleistung.

#### 8.2 Lampenmodell

Das beschriebene Lampenmodell aus Kapitel 3 greift den Modellvorschlag von [10] auf und korrigiert diesen in Hinsicht auf den Einfluss, den die räumliche Trennung der gebildeten Raumladung auf die Kapazität C<sub>Plasma</sub> hat. Aus Messungen wurde die Größe der Plasmakapazität berechnet, die linear mit der Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung zusammenhängt und nicht, wie zuvor angenommen, einen festen Wert besitzt. Abhängig von der Spannungsanstiegsflanke und dem resultierenden Plasmastrom kann die Plasmakapazität einen Wert annehmen, der bis zu dreizehnmal größer ist als die Gapkapazität. Damit erklärt sich auch der Einfluss der Anstiegsgeschwindigkeit auf die Leistung, die in der Lampe umgesetzt wird. Gleichzeitig zeigen auch die Anstiegsgeschwindigkeit und der spezifische Plasmaleitwert einen linearen Zusammenhang. Sowohl die Plasmakapazität als auch der spezifische Plasmaleitwert hängen von der räumlichen Dichte der Entladungsstrecken (Filamente) ab, die mit zunehmender Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung größer wird. Zusätzlich wird mit der Erweiterung des Modells um den Zweig des ionenbasierten Plasmastroms der lang anhaltende Lampenstrom beschrieben, der nach der eigentlichen Entladung fließen kann. Dieser Strom wird durch Ionen verursacht, die sich durch die Kraft des von außen angelegten Feldes in Richtung Kathode bewegen. Damit ist das erweiterte Modell ein Werkzeug, das als Last zur Simulation von Schaltungstopologien für Barrierenentladungen dient. Da die Zündbedingung nicht mehr durch die Lampenspannung sondern durch die Spannung  $U_{Ion}$  festgelegt wird, ist es möglich mit ein und demselben Lampenmodell das Verhalten der Sinusanregung und der Pulsanregung zu beschreiben. Gleichzeitig berücksichtigt das Lampenmodell den Effekt der Rückzündung.

### 8.3 Adaptives Impuls-EVG

Der große Vorteil des adaptiven Impuls-EVG für DBE-Lampen liegt darin, dass der Spannungsanstieg an der Lampe, in einem weiten Bereich variiert werden kann. Bei einer idealen kapazitiven Last erhöht sich die maximale Spannung, die an ihr anliegt, durch längeres Vorladen der Speicherdrossel und durch eine größere Versorgungsspannung U<sub>DC</sub> (Gleichung 4.12). Somit ist bei einem schnelleren Spannungsanstieg gleichzeitig die Energie größer, die auf die Kapazität der DBE fließt. Durch den schnelleren Spannungsanstieg ist die DBE in der Lage mehr Energie in Wirkleistung umzusetzen, da sich die Kapazität C<sub>Plasma</sub> vergrößert. Die Voraussetzung eines größeren Umsatzes an Wirkleistung bei einem schnellen Spannungsanstieg ist, dass zum Zeitpunkt des Durchbruchs bzw. der Entladung ausreichend Energie zur Verfügung steht (Kapitel 7.3). Dieser Zusammenhang zeigt sich sowohl in den Simulationen als auch in den Messungen, die gemacht wurden, um die Abhängigkeit des Gerätewirkungsgrads von einzelnen Parametern zu bestimmen.

In Kapitel 6.4.1 wurde das Übersetzungsverhältnis des Transformators bei gleichbleibender Zwischenkreisspannung variiert. Durch Verkleinern des Ubersetzungsverhältnis wird ein geringerer Drosselstrom und damit weniger Energie benötigt, um dieselbe Anstiegsgeschwindigkeit zu erzeugen, als mit einem großen Übersetzungsverhältnis. Dies liegt an der resultierenden Kapazität, die durch die Lampenkapazität und den Transformator gebildet wird. Bei kleinem Übersetzungsverhältnis des Transformators sieht das Betriebsgerät eine kleinere resultierende Kapazität, als bei einem großen Ubersetzungsverhältnis. Dadurch werden die Verluste in den Bauteilen geringer, die beim Laden der Speicherdrossel beteiligt sind. Zugleich wird jedoch die Energie reduziert, die der Entladung zur Verfügung steht. Daraus folgt ein geringerer Leistungsumsatz in der Lampe. Der Gerätewirkungsgrad hängt nicht direkt mit dem Übersetzungsverhältnis zusammen. Es existiert ein Optimum, das aus einem Zusammenspiel zwischen Geräteverlusten und Lampenleistung gebildet wird. In dieser Arbeit wurde ein maximaler Gerätewirkungsgrad von 79% bei einem Ubersetzungsverhältnis von 3:1 und einer Lampenleistung von 40W erreicht.

Beim Betreiben der Schaltung mit einer größeren Zwischenkreisspannung und einer konstanten Lampenleistung reduziert sich die Ladezeit der Speicherdrossel. Dadurch werden die Ladeverluste in den Bauteilen L, S1 und S2, die an dem Ladevorgang beteiligt sind, reduziert. Bei einer höheren Zwischenkreisspannung wird jedoch die Scheinleistung im gesamten System erhöht, da nach Gleichung 4.8 und 4.9 sowohl der Lampenstrom als auch die Lampenspannung von der Zwischenkreisspannung abhängen. Mit zunehmender Zwischenkreisspannung liegt an der Primärseite des Transformators ein höheres Spannungs-Zeit-Integral an, so dass größere Verluste durch stärkeres Ummagnetisieren des Kerns entstehen. Durch eine höhere Zwischenkreisspannung kann weniger Energie in den Zwischenkreis zurückgespeist werden, so dass sich auch hier die Verluste erhöhen. Zunächst sinken die Geräteverluste in dem untersuchten Betriebsgerät bei ansteigender Zwischenkreisspannung. Bei einer Zwischenkreisspannung von ca. 250 V sind die Geräteverluste am geringsten. Steigt die Zwischenkreisspannung weiter an, nehmen die Geräteverluste wieder zu.

Variiert man das Übersetzungsverhältnis des Transformators und die Induktivität der Speicherdrossel und lässt man die Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung konstant, so stellt man fest, dass die Lampenleistung nicht allein von der Anstiegsgeschwindigkeit abhängt. Einen großen Einfluss haben die induktive Größe der Speicherdrossel und die Streuinduktivität des Transformators. Je größer diese Induktivitäten sind, um so mehr Energie ist zum Zeitpunkt der Lampenzündung vorhanden. Diese Energie wird für die Entladung genutzt, so dass die Lampenleistung ansteigt. Ist die Induktivität der Speicherdrossel zu groß, so sinkt der Anteil der Energie, der für die Entladung genutzt wird. Der Anteil der Blindleistung steigt an. Da die nicht genutzte Energie nicht optimal zwischengespeichert oder in den Zwischenkreis zurückgespeist werden kann, steigen die Verluste im Betriebsgerät. Die Streuinduktivität des Transformators hindert einen schnellen Spannungsanstieg, der für eine hohe Leistungseinkopplung in die Lampe notwendig ist. D.h. die Streuinduktivität des Transformators hindert die Entladung zum Zeitpunkt des Spannungsanstiegs. Im Gegensatz dazu unterstützt diese die Entladung zum Zündzeitpunkt der Zündung, so dass für einen optimalen Leistungsfaktor und somit auch für einen optimalen Gerätewirkungsgrad die optimale Streuinduktivität für die jeweilige Lampe angepasst werden muss.

Soll die Lampenleistung bei variabler Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung konstant gehalten werden, so kann die Lampenleistung bei geringer Leistungseinkopplung durch die Anstiegsgeschwindigkeit und die Pulslänge des Spannungspulses eingestellt werden. Bei einer kurzen Anstiegsflanke und einem kurzen Puls kann die gleiche Leistung in die Lampe eingekoppelt werden wie bei einer langen Anstiegsflanke und einem langen Puls. Wie in Kapitel 7.6 gezeigt, hängt die Lampenleistung jedoch nicht direkt mit der Lampeneffizienz zusammen. Für eine hohe Lampeneffizienz ist ein schneller Spannungsanstieg und eine kurze Pulsdauer notwendig. Im Gegensatz dazu sinkt jedoch der Gerätewirkungsgrad bei einem schnellen Spannungsanstieg, so dass ein optimierter Systemwirkungsgrad ein Kompromiss zwischen Lampeneffizienz und Gerätewirkungsgrad ist.

In Kapitel 7.1 wurde gezeigt, dass sich die eingekoppelte Lampenleistung proportional zur Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung und zum maximalen Strom der Speicherdrossel verhält. Dabei sinkt der Gerätewirkungsgrad mit zunehmender Lampenleistung. Durch das freie Einstellen der Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung ist es möglich auf die Lampenleistung zu regeln, wenn zugelassen wird, dass die Lampenspannung resonant zurückschwingen kann. Da dies jedoch bei unterschiedlich großen Lampenkapazitäten möglich sein soll, muss auch auf das resonante Rückschwingen des Schwingkreises Lampenkapazität - Speicherdrossel geachtet werden (Kapitel 7.8). Die Steuerzeit TT1 muss auf die jeweilige Eigenfrequenz angepasst werden (Abbildung 7.13). Wird dies nicht gemacht, wird der Spannungspuls bei einer geringen Resonanzfrequenz möglicherweise angeschnitten, so dass die Leistungseinkopplung nicht allein vom Spannungsanstieg, sondern auch von der Rückzündung beeinflusst wird. Wird der Spannungspuls angeschnitten, so dass die Rückzündung einsetzt, ist eine Regelung auf die spezifische Lampenleistung nicht möglich.

Mit der variablen Pulsweite kann die Leistungseinkopplung in die Lampe auf die ansteigende und abfallende Spannungsflanke verteilt werden. Es ist möglich 2/3 der Energie während der ansteigenden Spannungsflanke und 1/3 der Energie während der abfallenden Spannungsflanke in die Lampe einzukoppeln. Damit können maximale Leistungen pro Puls in der Lampe umgesetzt werden. Je stärker die Energie während der abfallenden Spannungsflanke in die Lampe eingekoppelt wird, desto mehr sinkt der Gerätewirkungsgrad. Der Grund dafür ist die Energie, die nicht in der Lampe umgesetzt werden kann und nur unzureichend in den Zwischenkreis zurückgespeist wird.

Es hat sich gezeigt, dass eine Spannungs-Puls-Pausen-Sequenz von großem Vorteil ist, wenn DBE-Lampen effizient betrieben werden sollen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass zum einen die Rückzündung in der Lampe generiert werden kann und zum andern, dass die auf der Lampenkapazität gespeicherte Energie nicht verloren geht. Dies ist mit dem hier vorgestellten adaptiven Betriebsgerät nur teilweise möglich. Für zukünftige Arbeiten muss bekannt sein, welche Spannungsformen besonders geeignet sind, damit eine DBE-Entladung effizient betrieben werden kann. Die Form der Anregungsspannung für die DBE muss sich nicht allein auf die hier vorgestellte unipolare Pulsform beschränken. Um einen guten Gerätewirkungsgrad zu erreichen, führt kein Weg an einem resonanten Betriebsgerät vorbei, das genau auf eine Lampe angepasst ist. Dabei geht jedoch die Möglichkeit verloren, dass das Betriebsgerät eigenständig auf die Lampengröße adaptiert. Wie sich gezeigt hat, ist das Vorladen einer Drossel nicht geeignet, um DBE-Lampen mit großen Lampenkapazitäten effizient zu betreiben, vor allem aufgrund der hohen Verluste während der Ladephase. Es wurde bereits untersucht, ob es möglich ist, eine DBE-Lampe ohne Transformator zu betreiben [39]. Dabei wurde wie in dieser Arbeit das gleiche Spannungsmuster angestrebt, um die Lampe anzuregen. Es wurden nur maximale Gerätewirkungsgrade von bis zu 55% erreicht. Dies lag zum einen an den hohen Leitendverlusten der Halbleiterschalter. die für Spannungen bis zu 1200 V geeignet sein mussten. Zum anderen trat auch hier das Problem der Restenergie auf der Lampenkapazität auf. Trotz resonanten Rückschwingens konnte die Energie nicht ausreichend zurückgespeichert werden. Das Konzept mit den größten Erfolgsaussichten auf einen effizienten Betrieb einer DBE-Lampe wird ein Betriebsgerät sein, das resonant schaltet und eine Spannungs-Puls-Form erzeugt, die geeignet ist, eine DBE anzuregen. Gleichzeitig muss es in der Lage sein Spannungspausen zu generieren.

# 9 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein adaptives Betriebsgerät zur Erzeugung unipolarer Spannungspulse für Dielektrisch Behinderte Entladungslampen entwickelt. Die Besonderheit dieser Topologie, die entworfen, simuliert, aufgebaut und getestet wurde, ist, dass sie sich eigenständig an verschieden große Lampenkapazitäten anpassen kann. Das Anpassen bezieht sich dabei auf den Spannungsanstieg der Lampenspannung. Dies geschieht durch eine Speicherdrossel, die abhängig von der Ladedauer verschieden große Ströme treiben kann, um die kapazitive Last zu laden. Für die Simulation wurde ein elektrisches makroskopisches Lampenmodell einer DBE entwickelt, mit dessen Hilfe das Verhalten der Topologie überprüft werden konnte. Das Lampenmodell setzt sich aus einer Reihe von Kapazitäten zusammen, die die Wandkapazitäten, die Plasmakapazität und die Gapkapazität nachbilden. Parallel zur Gapkapazität liegt die Plasmakapazität, die im nicht gezündeten Zustand verschwindet. Ist die Zündbedingung des Modells erfüllt, steigt der Wert der Plasmakapazität auf ein Vielfaches der Gapkapazität. Der Wert der Plasmakapazität ist zeitabhängig. Der maximale Wert im zeitlichen Verlauf der Plasmakapazität hängt von der Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung ab. Die Besonderheit dieses Lampenmodells ist, dass es sowohl für Sinusanregung als auch für Pulsanregung benutzt werden kann.

Die Schaltzustände der vorgestellten Topologie wurden berechnet und simuliert. Das adaptive Betriebsgerät zur Erzeugung unipolarer Spannungspulse wurde vermessen und die Verluste in Abhängigkeit der Betriebsart der Lampe aufgezeigt. Die größten Verluste entstehen in den Halbleiterschaltern und in einer Leistungsdiode. Die Verluste entstehen dadurch, dass an der DBE steile Spannungsflanken erzeugt werden. Dafür werden hohe Ladeströme (20 A bis 40 A) benötigt, die mit der Speicherdrossel realisiert werden. Durch das Aufmagnetisieren der Speicherdrossel entstehen in allen beteiligten Halbleitern Verluste – sowohl Schaltverluste als auch Durchlassverluste. Ein weiterer Verlustmechanismus kommt dadurch zustande, dass ein Teil der nicht benötigten Restenergie, die in der DBE nicht umgesetzt werden kann, in Wärme umgewandelt wird.

Weiter wurde gezeigt wie die Leistungseinkopplung in die Lampe durch Veränderung der Pulsform variiert werden kann und wie durch Verändern der Schaltzeitpunkte das Gerät die Anstiegsflanke der Lampenspannung einstellen kann.

Um das System DBE-Lampe - EVG zu verbessern, sollten in zukünftigen Arbeiten folgende Punkte untersucht werden:

- Von welchen Mechanismen hängt die Rückzündung genau ab? Von der Spannungsflanke? Vom zeitlichen Abstand zur ersten Zündung? Wie kann die Zündspannung der Rückzündung vorhergesagt werden?
- Von welchen Vorgängen hängt die homogene Entladung ab (siehe Abbildung 7.7)?
- Wie kann der Leistungsfaktor  $\eta$  einer DBE erhöht werden? Um in eine DBE Leistung einzukoppeln, muss die Lampenkapazität auf die Zündspannung geladen werden. In der Entladung kann jedoch ein Teil der Energie, die auf der Lampenkapazität gespeichert ist, nicht in Strahlung umgesetzt werden. Mit dem Erhöhen des relativen Leistungsumsatzes in der Lampe kann auch der Gerätewirkungsgrad und damit der Systemwirkungsgrad erhöht werden.
- Wie kann bei gleichbleibendem Lampenwirkungsgrad die Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung reduziert werden? Eine steile Anstiegsgeschwindigkeit der Lampenspannung, die für einen hohen Lampenwirkungsgrad notwendig ist, reduziert den Gerätewirkungsgrad aufgrund der hohen Ströme im EVG. Geringere Anstiegsgeschwindigkeiten der Lampenspannung bedeuten geringere Verluste im EVG.
- Gibt es Leuchtstoffe (Zweiphotonenleuchtstoff) mit denen ein höherer Wirkungsgrad erzielt werden kann, wenn 172 nm Strahlung in den sichtbaren Bereich konvertiert werden soll?
- Gibt es Topologien, die nicht genutzte Restenergie vollständig zwischenspeichern können?
Gelingt es diese Fragen zu beantworten, so kann auch der Systemwirkungsgrad einer DBE wesentlich gesteigert werden. Zusätzlich kann dann mit geringerem Schaltungsaufwand Energie in die DBE eingekoppelt werden.

# A Anhang

#### A.1 Herleitung - Spannungsverlauf an S2 beim Ausschalten

Zur Herleitung des Spannungsverlaufs an dem Bauteil  $C_{S2}$  aus Abbildung A.1 werden folgende Gleichungen aufgestellt:

$$U_{DC} = U_L + U_{tr} \tag{A.1}$$

$$U_{tr} = U_C \tag{A.2}$$

$$I_L = I_{tr} + I_C \tag{A.3}$$

$$U_L = L \cdot I_L \tag{A.4}$$

$$U_{tr} = L_{tr} \cdot \dot{I}_{tr} \tag{A.5}$$

$$U_C = \frac{1}{C} \cdot \int I_C \, dt \tag{A.6}$$

Einsetzten von (A.4) und (A.5) in (A.1) ergibt:

$$U_{DC} = L \cdot \dot{I}_L + L_{tr} \cdot \dot{I}_{tr} \tag{A.7}$$



Abbildung A.1: Ersatzschaltbild für den Ausschaltvorgang des Schalters S2

Einsetzen von (A.5) und (A.6) in (A.2) ergibt:

$$-L_{tr} \cdot \dot{I}_{tr} + \frac{1}{C} \int I_C \, dt = 0 \tag{A.8}$$

Gleichungen (A.3),(A.7) und (A.8) werden nun in den Laplace-Bereich transformiert:

0----

$$L \cdot (s \cdot I_L(s) - I_L(+0)) + L_{tr} \cdot (s \cdot I_{tr}(s) - I_{tr}(+0)) = \frac{1}{s} \cdot U_e$$
(A.9)

$$-L_{tr} \cdot (s \cdot I_{tr}(s) - I_L(+0) + \frac{1}{C} \cdot \frac{1}{s} \cdot I_C(s) = 0$$
 (A.10)

$$I_L(s) - I_{tr}(s) - I_C(s) = 0$$
 (A.11)

Auflösen dieser drei Gleichungen, wobei  $I_{tr}(+0) = 0$  gilt, ergibt:

$$I_{tr}(s) = \frac{s \cdot L \cdot I_L(+0) + U_{DC}}{s^2 \cdot (s^2 \cdot L \cdot L_{tr} \cdot C + L + L_{tr})}$$
(A.12)

$$I_L(s) = (1 + s^2 \cdot L_{tr} \cdot C) \cdot \frac{s \cdot L \cdot I_L(+0) + U_{DC}}{s^2 \cdot (s^2 \cdot L \cdot L_{tr} \cdot C + L + L_{tr})}$$
(A.13)

Nach  $I_C$  wird nicht aufgelöst, da über Gleichung (A.3)  $I_C$  ermittelt werden kann. Rücktransformieren der Gleichungen (A.12) und (A.13) in den Zeitbereich ergibt:



$$I_{tr}(t) = \frac{U_{DC}}{L + L_{tr}} \cdot \left(t - \frac{1}{\omega} \cdot \sin\omega t\right) + \frac{I(+0) \cdot L}{L + L_{tr}} \cdot \left(1 - \cos\omega t\right)$$
(A.14)  
$$I_L(t) = \frac{U_{DC}}{L + L_{tr}} \cdot \left(t - \frac{1}{\omega} \cdot \sin\omega t\right) + \frac{U_{DC}}{L + L_{tr}} \cdot \frac{1}{\omega} \cdot \sin\omega t$$

$$+ \frac{L + L_{tr}}{L + L_{tr}} \cdot (1 - \cos\omega t) + I_L (+0) \cdot \cos\omega t$$
(A.15)

mit  $\omega = \sqrt{\frac{L+L_{tr}}{C \cdot L \cdot L_{tr}}}$ Einsetzen von Gleichungen (A.14) und (A.15) in (A.3) ergibt:

$$I_C(t) = I_L(+0) \cdot \cos\omega t + \frac{U_{DC}}{L} \cdot \frac{1}{\omega} \cdot \sin\omega t$$
 (A.16)

Um den Spannungsverlauf an der Kapazität  $C_{S2}$  zu erhalten, wird Gleichung (A.16) in

$$U = \frac{1}{C} \cdot \int I_C \, dt$$

eingesetzt. Es ergeben sich die Formeln (4.35) und (4.36):

$$U_C = \frac{I_L(+0)}{C \cdot \omega} \cdot \sin \omega t + \frac{U_{DC}}{L \cdot C \cdot \omega^2} \cdot (1 - \cos \omega t)$$
(A.17)

$$U_C = I_L(+0) \sqrt{\frac{L \cdot L_{Tr}}{C \cdot (L + L_{Tr})}} \cdot \sin \omega t + U_{DC} \frac{L_{Tr}}{L + L_{Tr}} \cdot (1 - \cos \omega t)$$
(A.18)

### A.2 Herleitung - Plasmastrom bei Lampenzündung

Ausgehend von Abbildung A.2 werden die Maschen- und Knotengleichungen im Laplace-Bereich aufgestellt. Dabei werden die Elemente  $C_W$  und  $R_P$  als Kurzschlüsse angenommen.

$$I_L = I_M + I_G + I_P \tag{A.19}$$

$$\frac{1}{s} \cdot U_{DC} = U_L + U_M \tag{A.20}$$

$$U_M = U_G \tag{A.21}$$

$$U_M = U_P \tag{A.22}$$

$$U_L = L \cdot (s \cdot I_L(s) - I_L(+0)) \tag{A.23}$$

$$U_M = L_M \cdot (s \cdot I_M(s) - I_M(+0))$$
 (A.24)

$$U_G = \frac{1}{s} \cdot \left(\frac{1}{C_G} \cdot I_G(s) + U_G(+0)\right)$$
(A.25)

$$U_P = \frac{1}{s} \cdot \left(\frac{1}{C_P} \cdot I_P(s) + U_P(+0)\right)$$
 (A.26)



Abbildung A.2: Ersatzschaltbild der Zündphase

Mit  $U_P(+0) = 0$ . Einsetzen von Gleichung A.23 und A.24 in A.20 ergibt:

$$I_L(s) \cdot s \cdot L + I_M(s) \cdot s \cdot L_M = \frac{1}{s} \cdot U_{DC} + I_L(+0) \cdot L + I_M(+0) \cdot L_M$$
(A.27)

Einsetzen von Gleichung A.24 und A.25 in A.21 ergibt:

$$I_M(s) \cdot s \cdot L_M - I_G(s) \cdot \frac{1}{s \cdot C_G} = L_M \cdot I_M(+0) + \frac{1}{s} \cdot U_G(+0)$$
(A.28)

Einsetzen von Gleichung A.24 und A.26 in A.22 ergibt:

$$I_M(s) \cdot s \cdot L_M - I_P(s) \cdot \frac{1}{s \cdot C_P} = L_M \cdot I_M(+0)$$
(A.29)

Auflösen der Gleichungssysteme A.19, A.27, A.28 und A.29 nach  $I_P$  ergibt:

$$I_P \cdot \left[ s^2 \cdot L \cdot \left( 1 + \frac{C_G}{C_P} \right) + \frac{L_M + L}{L_M \cdot C_P} \right]$$

$$= s^2 \cdot L \cdot C_G \cdot U_G(+0) + s \cdot \left[ I_L(+0) \cdot L - I_M(+0) \cdot L \right] + U_{DC}$$
(A.30)

Transformation der Gleichung in den Zeitbereich ergibt:

•----0

$$I_P(t) = U_G(+0) \cdot \frac{C_G \cdot C_P}{(C_G + C_P)} \cdot \delta(t)$$
  

$$- U_G(+0) \cdot \frac{C_G \cdot C_P}{(C_G + C_P)} \cdot \omega \cdot \sin \omega t$$
  

$$+ (I_L(+0) - I_M(+0)) \cdot \frac{C_P}{(C_G + C_P)} \cdot \cos \omega t$$
  

$$+ U_{DC} \cdot \frac{1}{L} \cdot \frac{C_P}{(C_G + C_P)} \cdot \frac{1}{\omega} \cdot \sin \omega t$$
  
mit  $\omega = \sqrt{\frac{L + L_M}{L \cdot L_M}} \cdot \frac{1}{C_G + C_P}$   
(A.31)

#### A.3 Schaltverhalten von MOSFET bei schnellem Spannungsanstieg

Das Schaltverhalten von Hochgeschwindigkeits-MOSFET ist in [40], [12] und in vielen anderen Lehrbüchern diskutiert. Der Vollständigkeit wegen werden hier in aller Kürze die wichtigsten Eigenschaften angesprochen. Zum tieferen Studium wird auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen. Zunächst handelt es sich bei den MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) um Bauteile, deren Ausgangsstrom proportional zu der Ladung ist, die auf die Steuerelektrode gebracht wird [40]. Im Gegensatz zum Bipolartransistor kann der MOSFET, aufgrund der Steuerelektrode, einfacher angesteuert werden. Diese ist vom Strom führenden Halbleiter isoliert, so dass beim eingeschalteten MOSFET kein Steuerstrom fließt. Als weitere Eigenschaft hat der MOSFET ein Temperaturverhalten, das einem Widerstand entspricht (positiver Temperaturkoeffizient). Sind MOSFET thermisch gekoppelt, ist das Parallelschalten mehrerer von ihnen unkritisch.

In Abbildung A.3 sind die drei Hauptkategorien von MOSFET-Modulen dargestellt. Bei der Sipmos-Struktur (Abbildung A.3 (a)) handelt es sich um die erste MOSFET-Struktur für Leistungsmosfet. Der Vorteil dieser Struktur ist, dass die Stromdichte im n-Kanal des p-Bereichs reduziert werden kann. Dies geschieht durch das in die Bildebene langgezogene Gate. Die Umos-Struktur (Abbildung A.3 (b)) ist die technische Verbesserung bzw. Weiterentwicklung der Sipmos-Struktur, die eine höhere Zel-



(c) Dmos-Struktur

Abbildung A.3: Unterschiedliche MOSFET-Strukturen [40]



 (a) Modell für dU/dt induziertes (b) parasitäre Komponenten für das Einschalten [40]
 Schaltverhalten [40]

#### Abbildung A.4: MOSFET-Modelle

lendichte ermöglicht. Erkauft wird diese Verbesserung durch aufwändigere Produktionsprozesse. Die Dmos-Struktur (Abbildung A.3 (c)) ist nicht für Leistungsanwendungen geeignet. Spannung und Strom sind stark begrenzt aufgrund der großen Driftzone im n-Bereich. In dieser Zone entstehen die Durchlaßverluste, die sich aufgrund des Gate-Anschlusses schlecht abführen lassen. Diese Struktur wird hauptsächlich in Bereichen eingesetzt, wo keine großen Spannungen auftreten, wie z.B. bei der Spannungsversorgung von Mikroprozessoren. Vorteil dieser Struktur ist, dass die Kapazitäten eines solchen MOSFET kleiner sind im Vergleich zu den anderen Strukturen. Dies ermöglicht eine höhere Schaltgeschwindigkeit.

Um das Verhalten von MOSFET zu beschreiben, werden abhängig von der Anwendung, unterschiedliche Modelle benutzt. Für das dynamische Schalten sind hauptsächlich die zwei Modelle aus Abbildung A.4 wesentlich. Das Modell aus Abbildung A.4 (a) beschreibt das induzierte Einschalten bei schnellen Spannungsanstiegen über den Drain-Source-Anschlüssen. Zum einen liegt über dem kapazitiven Spannungsteiler  $C_{GD}$  und  $C_{GS}$  eine Spannung an, die proportional ist zu der Spannung, die über den Anschlüssen Drain-Source anliegt. Wird der MOSFET ausgeschaltet, steigt die Spannung über den Drain-Source-Anschlussklemmen an. Abhängig von der Anstiegsgeschwindigkeit der Spannung (dU/dt), kann die externe

Gatebeschaltung die Gatespannung nicht unter der Schaltschwelle halten. Wird diese erreicht, wird der MOSFET wieder leitend. Zum andern ergibt sich, bedingt durch den Strukturaufbau eines MOSFETs, ein parasitärer Bipolartransistor. Beim Spannungsanstieg über den Drain-Source-Anschlussklemmen fließt ein Verschiebungsstrom durch die Kapazität und den Widerstand, die parallel zu dem Bipolartransistor liegen. Ist der Verschiebungsstrom groß genug, liegt über dem Widerstand eine Spannung an, die ausreicht, einen Kollektorstrom fließen zu lassen. Dadurch entstehen zusätzliche Verluste während des Ausschaltvorgangs. Abbildung A.4 (b) zeigt das Schaltmodell mit den wichtigsten parasitären Komponenten, die vor allem das schnelle Schalten beeinflussen. Dies sind die Kapazitäten  $C_{GD}$ ,  $C_{GS}$  und  $C_{DS}$ , die parallel zu den Anschlüssen liegen, der intern liegende Gate-Widerstand und die Induktivitäten, die jeweils zwischen dem eigentlichen Schaltelement und dem Drain- bzw. Source-Anschluss liegen. Zuletzt wird noch auf den Verlauf des Einschaltens bzw. des Ausschaltens eingegangen. Wie in Abbildung A.5 zu sehen, werden die Schaltverläufe in vier Bereiche eingeteilt. Beim Einschalten wird im ersten Schritt die Spannung am Gate  $V_{GS}$  erhöht, bis die Schaltschwelle  $V_{TH}$  erreicht wird. Bis zu dieser Schwelle ist der MOSFET noch vollständig gesperrt. Es liegt die volle Spannung an den Drain-Source Anschlüssen an und es fließt kein Drain-Strom  $I_D$ . Im zweiten Bereich wird die Gate-Spannung bis zum "Miller-Plateau" erhöht. Dabei steigt der Drain-Strom bis zu seinem Maximalwert an. Die Drain-Source Spannung entspricht jedoch immer noch der Sperrspannung. Im dritten Bereich fällt die Drain-Source Spannung auf ein Minimum. Dabei bleibt die Gate-Source Spannung konstant, obwohl Ladungsträger auf das Gate fließen. Dieser Bereich wird als "Miller-Plateau" bezeichnet. Im vierten Bereich steigt die Gate-Spannung weiter an. Abhängig von der endgültigen Spannung wird der Leitendwiderstand beeinflusst. In diesem Bereich bleibt der Drain-Strom konstant, während die Drain-Source-Spannung leicht fällt.

Beim Ausschaltvorgang ist der Schaltverlauf genau umgekehrt. Zunächst fällt die Gate-Spannung bis auf das Miller-Plateau. Dabei wird der Leitendwiderstand leicht erhöht, der MOSFET ist jedoch noch voll durchgeschaltet. Beim Durchlaufen des Miller-Plateaus (Phase 2) steigt die Drain-Source-Spannung an, der Drain-Strom fließt jedoch unverändert weiter. Sobald die Gate-Spannung wieder sinkt (Bereich 3), geht der Drain-Strom zurück und kommt bei der Schaltschwelle  $V_{TH}$  zum Erliegen. Im letzten Bereich sinkt die Gate-Spannung auf null Volt.



Abbildung A.5: Schaltverläufe eines MOSFETs [40]

## Literaturverzeichnis

- DR. SCHLUZ, PAUL: Elektronische Vorgänge in Gasen und Festkörpern. G. Braun Karlsruhe, 2. Auflage, 1974.
- [2] SRINIVASAN, R: Nonthermal Ablation. J.VAc.Sci.Technol., B1(4):923, 1983.
- [3] ADLER, FRANK: Strahlungsprozesse in der dielektrisch behinderten Entladung. Doktorarbeit, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, 2000.
- [4] NÖTZOLD, D.; KANTZ, L.; JILG L.; SCHWARZ L.: Photoluminescent Materials for VUV Excitation based on Eu<sup>2+</sup> doped Alkaline Earth Aluminates. In: ZISSIS, GEORGES (Herausgeber): Proc. 10th Int. Symp. on the Science and Technology of Light Sources (LS-10), Seiten 261–262. European COST-529 Network, July 2004.
- [5] GMBH, OSRAM: Internet Auftritt Planon. http://www.planon.de/, 2005.
- [6] KLING, RAINER: Untersuchungen an hocheffizienten Excimerentladungen. Doktorarbeit, Universität Karlsruhe, Lichttechnisches Institut, 1997.
- [7] BERGER, THOMAS; BERGER, WILHELM; SEELBACH EGON: Teilvorhaben: Untersuchung flächiger Xe-Barrierenentladungen für Leuchtstofflampen. Abschlussbericht für das Verbundprojekt Energieeffiziente quecksilberfreie Niederdruckentladungen, FKZ: 13N8149, 2005. VDI-Technologiezentrum Projektträger für das Bundesministerium für Bildung und Forschung.
- [8] TRAMPERT, KLAUS; NEIGER, MANFRED; HEERING WOLFGANG: Teilvorhaben: Grundlegende Charakterisierung des Entladungsverhaltens und der Strahlungseffizienz von elektrodenlosen Xenon- Bar-

rierenentladungen; Teil A: Experimentelle Untersuchungen von Xenon - Barrierenentladungen. Abschlussbericht für das Verbundprojekt Energieeffiziente quecksilberfreie Niederdruckentladungen, FKZ: 13N8154, 2005. VDI-Technologiezentrum Projektträger für das Bundesministerium für Bildung und Forschung.

- [9] HEERING, WOLFGANG; DAUB, HANS-PETER; WINKELMANN RI-CHARD: Europäische Patentanmeldung; EP1741319; Vorrichtung zur Erzeugung von elektrischen Spannungsimpulsfolgen, insbesondere zum Betrieb von kapazitiven Entladungslampen, November 2005. Universität Karlsruhe.
- [10] TRAMPERT, K.E.: Ladungstransportmodell dielektrisch behinderter Entladungen. Doktorarbeit, Universität Karlsruhe, Lichttechnisches Institut, 2008.
- [11] KOGELSCHATZ, U.; ELIASSON, B.; EGLI W.: From ozone generators to flat television screens: history and future potential of dielectricbarrier discharges. Pure Appl. Chem., 71(10):1819–1828, 1999.
- [12] SCHRÖDER, DIRK: Elektrische Antriebe 3. Springer, 1. Auflage, 1996.
- [13] KUNZE, J. ET AL.: Resonant power supply for barrier discharge UVexcimer sources. Industrie Applications Society Annual Meeting, 1:750-753, 10 1992.
- [14] ROTH, M.: Experimentelle Untersuchungen zu Verlustmechanismen des Kathodenfalls in Barrierenentladungen. Doktorarbeit, Universität Karlsruhe, Lichttechnisches Institut, 2002.
- [15] SCHWARZ-KIENE, P.: Betriebsgeräte und Verfahren zur effizienten Erzeugung ultravioletter Strahlung. Doktorarbeit, Universität Karlsruhe, Lichttechnisches Institut, 2000.
- [16] ERICKSON, R.W.; MAKSIMOVIC, D.: Fundamentals of Power Electronics. Kluwer Academic Publishers, 2. Auflage, 2003.
- [17] VOLLKOMMER, F; HITSCHKE, L: Dielectric Barriere Discharge. In: BABUCKE, GERHARD (Herausgeber): Proc. 8th Int. Symp. on the Science and Technology of Light Sources (LS-8), Seiten 51–60. Inst. Low Temp Plasma Phys., August 1998.

- [18] MILDREN, R P; CARMAN, R J: Enhanced performance of a dielectric barrier discharge lamp using short-pulsed excition. Journal of Physics D: Applied Physics, 34:L1–L6, 2001.
- [19] HUBER, ANDREAS; VESER, ALWIN; HIRSCHMANN GÜNTHER: Europäische Patentanmeldung; EP0781078A2; Schaltungsanordnung zur Erzeugung von Impulsspannungsfolgern, Insbesondere für den Betrieb von dielektrisch behinderten Entladungen, November 1996. Patent-Treuhand- Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH.
- [20] WINKELMANN, RICHARD: Digital geregelter Pulsbetrieb von dielektrisch behinderten Gasentladungslampen. Diplomarbeit, Universität Karlsruhe, 2003.
- [21] SOWA, W.; LECHELER, R.: Lamp Driver Concepts for Dielectric Barrier Discharge Lamps and Evaluation fo a 110W Ballast. IEEE, 2004.
- [22] VOLLKOMMER, FRANK; HITZSCHKE, LOTHAR: Internationale Patentanmeldung; WO0167827A1; Verbessertes Pulsbetriebsverfahren für stille Entladungslampen, 09 2001. Patent-Treuhand-Gesellschaft für Elektrische Glühlampen mbH - Osram.
- [23] SÄNGER, ROBER: mündliche Mitteilung. 2005.
- [24] LIU, SHUHAI: Electrical modelling and unipolar-pulsed energization of dielectric barrier discharges. Doktorarbeit, Universität Karlsruhe, Lichttechnisches Institut, 2002.
- [25] NAUDÉ, N.; CAMBRONNE J.-P.; GHERARDI, N.; MASSINES F.: Electrical model and analysis of the transition from an atmospheric pressure Townsend discharge to a filamentary discharge. Journal of Physics D: Applied Physics, 38:530–538, 2005.
- [26] BHOSLE, S.; ZISSIS, G.; DAMELINCOURT J.J.; CAPDEVILA A.; GUPTA K.; DAWSON F.P.; TARASENKO V.F.: Electrical modeling of an homogeneous dielectric barrier discharge (DBD). Industry Applications Conference, 2005. Fourtieth IAS Annual Meeting. Conference Record of the 2005, 4:2315–2319, 2005.
- [27] RAIZER, YURI P.: Gas discharge physics. Springer, 2. Auflage, 1997.

- [28] KAPZOW, N.A.: *Elektrische Vorgänge in Gasen und Vakuum*. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1. Auflage, 1955.
- [29] PFLUMM, C.: Simulation homogener Barrierenentladungen inklusive der Elektrodenbereiche. Doktorarbeit, Universität Karlsruhe, Lichttechnisches Institut, 2003.
- [30] BOEF, J.-P.; PITCHFORD; L.C.: BOLSIG: user-friendly Boltzmann solver from the SIGLO Series.
- [31] PARAVIA, MARK: optimierter Pulsbetrieb zur Effizienzsteigerung von Xe-Excimer-Flachlampen. Diplomarbeit, Universität Karlsruhe, 2006.
- [32] DE DONCKER, R.W.; LYONS, J.P.: The Auxiliary Resonant Commutated Pole Converter. IEEE, 2:1228 – 1235, Oct 1990.
- [33] ANSOFT CORPORATION: Simplorer Simulation Center 7.0, 2004.
- [34] GRUPP, ANDRÉ: mündliche Mitteilung. 2006.
- [35] EPCOS: Ferrite Magnetic Design Tool 4.0, 2003.
- [36] EPCOS AG DEUTSCHLAND: Datenblatt Ferritmaterial N87, 2007.
- [37] PARAVIA, MARK: interner Bericht. 2007.
- [38] DAUB, RÜDIGER: Spektroskopische Untersuchungen der Reaktionskinetik von Xe2\* im VUV bis NIR. Diplomarbeit, Universität Karlsruhe, 2007.
- [39] RUISS, ANDREAS: Transformatorloses Vorschaltgerät zum gepulsten Betrieb einer Xenonexcimer Flachlampe. Diplomarbeit, Universität Karlsruhe, 2007.
- [40] BALOGH, LASZLO: design and application guide for high speed MOS-FET gate drive circuits. Texas Instruments, 2001. Unitrode Design Seminars - SEM1400.





ISBN 978-3-86644-484-3